

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Прикладная физика

Направление подготовки (специальность) 35.03.06 «Агроинженерия»

Профиль образовательной программы Технический сервис в АПК

Форма обучения заочная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Методические указания по выполнению лабораторных работ	3
1.1 Лабораторная работа № ЛР-1 Аналоговые электроизмерительные приборы и цифровые мультиметры.....	3
1.2 Лабораторная работа № ЛР-2 Изучение электронного осциллографа.....	15
1.3 Лабораторная работа № ЛР-3 Снятие температурной характеристики терморезистора, изучение характеристик фоторезистора.....	27
1.4 Лабораторная работа № ЛР-4 Измерение вольт-амперной характеристики полупроводникового диода, полупроводниковые выпрямители переменного тока.....	43
1.5 Лабораторная работа № ЛР-5 Фотоэлектрический метод преобразования солнечного света, измерение нагрузочной вольт-амперной характеристики солнечной батареи.....	50
1.6 Лабораторная работа № ЛР-6 Современные солнечные батареи, солнечные фотоэлектрические системы (электростанции).....	62
1.7 Лабораторная работа № ЛР-7 Автономные солнечные фотоэлектрические системы (электростанции), расчёт автономной фотоэлектрической системы.....	80

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1.1 Лабораторная работа № ЛР-1 (2 часа).

Тема: «Аналоговые электроизмерительные приборы и цифровые мультиметры»

1.1.1 Цель работы: ознакомиться с принципами работы, устройством и характеристиками электроизмерительных приборов и цифровых мультиметров.

1.1.2 Задачи работы:

1. Изучить элементарные сведения по технике безопасности
2. Ознакомиться с устройством и принципом действия электроизмерительных приборов
3. Описать назначение, устройство и основные характеристики двух электроизмерительных приборов, используя условные обозначения на шкалах.
4. Ознакомиться с принципом действия цифровых мультиметров.
5. Ознакомиться с правилами применения цифрового мультиметра
6. Провести измерения электрических величин.

1.3.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Вольтметр (милливольтметр)
2. Амперметр (миллиамперметр)
3. Реостат
4. Цифровой мультиметр DT 830 (или аналогичный)
5. Блок резисторов
6. Источник постоянного тока
7. Полупроводниковый фотоэлемент
8. Полупроводниковый диод
9. Лампа осветительная
10. Соединительные провода

1.1.4 Описание (ход) работы:

I. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Анализ травматизма при эксплуатации электрических установок показывает, что большинство несчастных случаев происходит вследствие нарушения правил по технике безопасности. Правила по технике безопасности (ПТБ) при эксплуатации электроустановок делятся на ПТБ до 1000 В и выше. В наших лабораториях подводится напряжение до 1000 В.

Установлено, что результат поражения электрическим током зависит от величины тока, его частоты, времени воздействия, индивидуальных свойств организма, а также от пути тока. Сила тока через тело человека при прочих равных условиях в значительной степени определяется величиной электрического сопротивления тела.

Величина сопротивления человеческого тела зависит от состояния наружного кожного покрова, от степени увлажнения кожи, от физиологического состояния организма и т.д. Эта величина может меняться в широких пределах от 1000 Ом до 100 кОм, а иногда, в особенно неблагоприятных условиях, оно снижается до 400-500 Ом. Расчетным принято считать сопротивление 1000 Ом.

Действие электрического тока на человеке может быть: тепловым (ожог), механическим (разрыв тканей, резкие сокращения мышц), химическим (электролиз

тканевых и межтканевых жидкостей, крови). (См. приложение 5). Кроме того, проходя через человеческий организм, он может нарушать физиологические процессы и т.д.

Наиболее опасны постоянные токи и токи переменной частоты от 40 до 60 Гц величиной 0,1 А и выше. Во избежание поражения электрическим током следует соблюдать следующие правила по технике безопасности:

1. Все электрические схемы монтировать с помощью соединительных проводов. Провода должны быть изолированными.
2. Переплетение даже изолированных проводов не допускать.
3. Цепь вести от источника тока, но подключать источник тока в последнюю очередь. При разборке схемы прежде всего отключить источник тока.
4. Все реостаты, включенные в цепь, должны быть установлены на максимум сопротивления.
5. Потенциометры устанавливать на нуль подаваемого в контур напряжения.
6. Замыкать цепь без проверки схемы преподавателем или лаборантом категорически запрещается.
7. Ток замыкать только на время отсчетов.
8. Не производить переключение схем, находящихся под напряжением.
9. Не прикасаться к изолированным частям схемы.
10. Не оставлять без наблюдения схему, находящуюся под напряжением.
11. После выполнения лабораторной работы отключить схему от напряжения, если есть конденсаторы, то их разрядить.

II. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ НАИБОЛЕЕ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Все электроизмерительные приборы классифицируются по следующим основным признакам:

1. Показывающие приборы. Благодаря наличию в этих приборах шкалы (предварительно градуированной с эталоном) и указателя они дают возможность непосредственно отсчитать значение измеряемой величины.
2. Регистрирующие и самопишущие приборы. Такие приборы позволяют непрерывно или через определенные интервалы последовательно записывать значения измеряемой величины. Запись производится на миллиметровую бумагу, фото пленку.
3. Интегрирующие приборы. Они позволяют получать суммарное значение измеряемой величины (например, счетчики электрической энергии).
4. Интегрирующие приборы служат для сравнения измеряемой величины с образцом (мосты и потенциометры).

В свою очередь, показывающие приборы можно разделять :

- а) по роду измеряемой величины: амперметры, вольтметры, омметры, счетчики, частотомеры, фазометры и т.д.
- б) по принципу действия: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, индукционные, тепловые, электростатические, электронные, вибрационные и т.д. (См. приложение 2).
- в) по степени точности: 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 классов. Приборы класса точности 0,1, 0,2, 0,5 применяются для точных измерений и называются прецизионными (класс точности прибора – относительная приведенная погрешность в процентах).

Электроизмерительные приборы состоят из подвижной и неподвижной частей. При измерениях вращающий момент подвижной части уравнивается противодействующим моментом пружины какого-либо другого устройства. При равновесии указатель прибора фиксирует определенный угол поворота. Величина,

численно равная отношению угла поворота подвижной части прибора к приращению измеряемой величины, называется чувствительностью прибора.

Если, например, приращение угла $\Delta\varphi$ вызвано приращением тока ΔI , то чувствительность: $S = \Delta\varphi / \Delta I$. Величина, обратная чувствительности: $C = 1/S$ называется ценой деления прибора. C определяет значение электрической величины, вызывающей отклонение подвижной части прибора на одно деление.

Например, имеем вольтметр, который может измерять напряжение от 0 до 250 В. Шкала этого прибора разделена на 50 мелких делений. Чувствительность прибора:

$$S = \frac{\Delta\varphi}{\Delta U} = \frac{50 \text{ дел.}}{250 \text{ В}} = 0,2 \text{ дел. / В}$$

Цена деления прибора:

$$C = \frac{250 \text{ В}}{50 \text{ дел.}} = 5 \text{ В / дел.}$$

Итак : для нахождения цены деления прибора нужно верхний предел (максимальное значение) измеряемой величины разделить на число делений шкалы прибора (если прибор многопредельный, цена деления для каждого предела будет своя).

Приборы магнитоэлектрической системы.

Неподвижная часть прибора такой системы представляет собой постоянный магнит (1) (рис.1), между полюсами которого создается сильное, равномерное, радиально направленное магнитное поле.

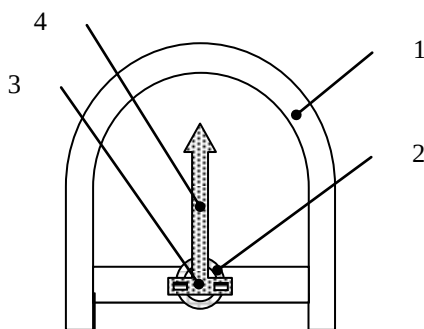


Рис.1

Подвижная часть прибора состоит (2) из прямоугольной рамки, на которой расположена обмотка из медной изолированной проволоки. Рамка прикреплена к корпусу спиральными пружинами (3), создающими противодействующий момент.

В результате взаимодействия магнитного поля магнита и рамки с током возникает вращающий момент, под действием которого подвижная часть прибора, а также с ним стрелка (4), поворачивается около оси. Угол поворота подвижной части прибора пропорционален величине тока, идущего в катушке: $\alpha = kI$, k – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора. Достоинствами приборов магнитоэлектрической системы являются: высокая точность, высокая чувствительность, равномерность (линейность) шкалы, малая зависимость показаний прибора от воздействия внешних магнитных полей, быстрое самоуспокоение подвижной части прибора. Приборы магнитоэлектрической системы применяются в качестве амперметров и вольтметров постоянного тока. Миллиамперметры магнитоэлектрической системы могут измерять токи до 10^{-6} А.

К недостаткам приборов магнитоэлектрической системы можно отнести: измерение только постоянных токов, недостаточная перегрузочная способность их.

Приборы электромагнитной системы.

Принцип действия приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля тока, протекающего по обмотке неподвижной катушки (рис.2), с подвижным железным сердечником 2, помещенным в это магнитное поле. При увеличении тока возрастает индукция магнитного поля в катушке и увеличивается намагничивание железного сердечника. Теоретически установлено, что между углом поворота железного сердечника, при его втягивании внутрь катушки, и величиной тока в катушке существует квадратичная зависимость: $\alpha = kI^2$ (вследствие этого шкала приборов электромагнитной системы неравномерная, квадратичная). Приборы электромагнитной системы применяются для измерения величины тока и напряжения в цепях переменного и постоянного тока. Приборы электромагнитной системы менее точны, однако они измеряют и постоянные, и переменные токи, просты и надежны в эксплуатации.

Приборы электродинамической системы.

Принцип действия прибора электродинамической системы основан на магнитном взаимодействии потоков, проходящих по обмоткам двух катушек - подвижной 1 и неподвижной 2 (рис.3). Обмотки катушек соединены между собой в зависимости от назначения прибора, параллельно или последовательно. В вольтметрах они соединены последовательно, в амперметрах – параллельно.

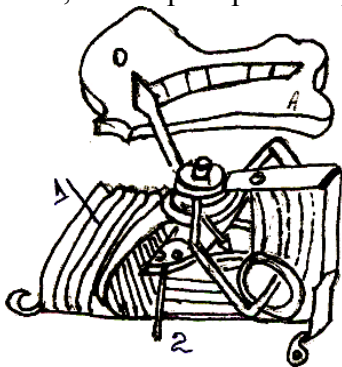


Рис. 2



Рис. 3

Приборы электродинамической системы применяются для измерения в цепях переменного и постоянного токов. Эти приборы точны, однако их показания зависят от наличия внешних магнитных полей, шкала у них неравномерная и достаточно велика потребляемая мощность.

Приборы других систем:

Тепловая система – принцип действия основан на изменении длины проводника при прохождении по нему тока. Эти приборы могут измерять и постоянные, и переменные токи.

Амперметры, вольтметры, гальванометры.

Амперметрами называются приборы, служащие для измерения величины тока. При измерениях амперметры включают в цепь последовательно, поэтому приборы должны иметь малое сопротивление, чтобы включение их не изменяло заметно величину тока в цепи.

Вольтметрами называют приборы, служащие для измерения напряжения в цепи. При измерениях вольтметр включается параллельно тому участку цепи, на концах которого хотят измерить падение напряжения. Сопротивление вольтметра должно быть велико по сравнению с сопротивлением участка цепи, на котором измеряют падение напряжения.

Гальванометрами называют приборы, весьма чувствительные, служащие для измерения малых токов (до 10^{-7} - 10^{-9} А), малых напряжений.

Для расширения пределов измерения амперметров и вольтметров применяются шунты и добавочные сопротивления.

Шунтом называют сопротивление ($R_{\text{ш}}$), включаемое в цепь параллельно амперметру (рис.4). При этом в цепь амперметра ответвляется только часть измеряемого тока I_A . Другая R_A часть тока $I_{\text{ш}}$ будет идти через

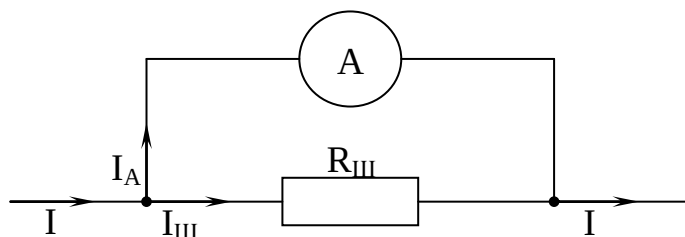


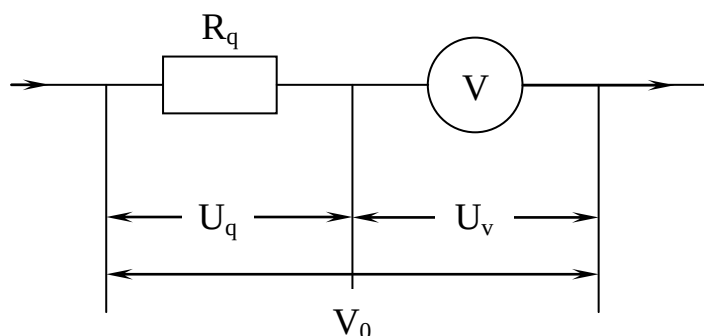
Рис. 4

шунт, при этом $I = I_A + I_{\text{ш}}$.

В зависимости от соотношения сопротивления $R_{\text{ш}}$ и R_A , идущий по амперметру ток можно изменить в желаемое число раз. Например, если необходимо измерить амперметром ток в n раз больший максимально возможного для данного прибора, то нужно включить сопротивление в $(n - 1)$ раз меньшее $R_{\text{ш}} = R_A / (n - 1)$, где $n = I/I_A$, I - величина тока в цепи, I_A - ток, идущий через амперметр (R_A - сопротивление амперметра).

Добавочное сопротивление применяется для расширения пределов измерения вольтметра и включается последовательно с ним (рис.5).

Рис.5



При подключении прибора V в цепь, напряжение распределится на добавочное сопротивление R_q , и на вольтметр U_v , так что $U_0 = U_q + U_v$.

В зависимости от соотношения сопротивления вольтметра R_v и добавочного сопротивления R_q напряжение, подаваемое на вольтметр, будет уменьшено. Если, например, необходимо измерить вольтметром в n раз большее напряжение, то необходимо включить последовательно с вольтметром добавочное сопротивление $R_q = R_v (n - 1)$, то есть в $(n - 1)$ раз большее, чем сопротивление вольтметра (где $n = U_0 / U_v$).

III. РЕОСТАТЫ, ПОТЕНЦИОМЕТРЫ, МАГАЗИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Для изменения силы тока в цепи применяются реостаты, чаще всего реостаты со скользящим контактом. При включении реостата так, как показано на рис. 7, он работает как потенциометр (делитель напряжения). Перемещая ползунок между клеммами К и Д, можно изменить напряжение, подаваемое на лампу, от 0 до U_{max} .

Набор эталонных сопротивлений, представляющих собой катушки сопротивлений, называется магазином сопротивлений. Каждая катушка состоит из хорошо изолированной проволоки, изготовленной обычно из манганина или константана.

Рис.6

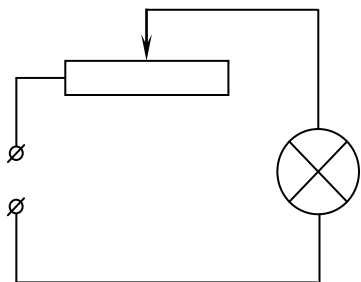
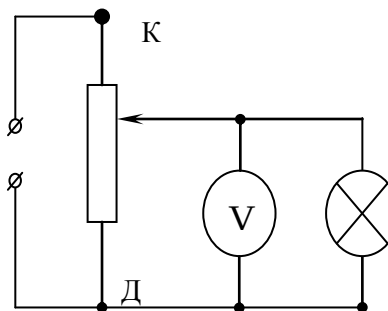


Рис.7



Сопротивление каждой катушки вполне определенное и мало изменяется под действием внешних факторов (в частности температуры). Подбором катушек можно набрать нужное сопротивление.

Измерительные приборы, электрическую схему которых можно переключать для изменения интервалов величины, называются многопредельными. В многопредельные амперметры внутрь прибора вмонтированы шунты, в случае вольтметра – добавочные сопротивления.

IV. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Абсолютная погрешность - под абсолютной погрешностью измерения понимается разность между истинным значением измеряемой величины и значением, полученным при данном измерении. При электрических измерениях абсолютная погрешность равна разности показания прибора и действительного значения измеряемой величины

$$\Delta A = A_{\text{пок. пр.}} - A_{\text{дейст. знач.}}$$

Величина, обратная по знаку абсолютной погрешности, называется поправкой прибора $K = - \Delta A$. Относительная погрешность. Под ней понимается отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины.

$$\beta = \frac{\Delta A}{A_{\text{дейст. знач.}}}$$

Для оценки точности показаний прибора вводится приведенная погрешность. Приведенная погрешность равна отношению максимальной абсолютной погрешности к максимальному значению измеряемой данным прибором величины:

$$\beta = \frac{\Delta A_{\text{max}}}{A_{\text{max}}} \cdot 100\%$$

Максимальная приведенная погрешность в процентах называется классом точности прибора. Эта величина является важнейшей характеристикой прибора и ее значение нанесено на лицевой панели прибора (0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0). Используя значение класса точности прибора, можно оценить абсолютную погрешность (поправку) измерения. Например: Класс точности вольтметра 0,5, максимальное значение измеряемой величины (предел измерения) $U_{\text{max}} = 250 \text{ В}$, тогда:

$$\Delta U_{\text{max}} = \beta \frac{U}{100} = \frac{0,5 \cdot 250 \text{ В}}{100} = 1,25 \text{ В}$$

V. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

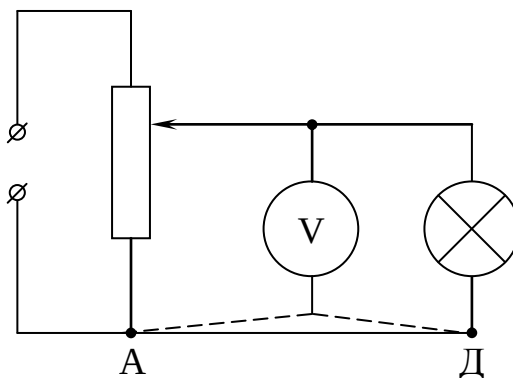
1. Электрические цепи собираются в соответствии с составленной принципиальной схемой (без наличия схемы собирать электрические цепи запрещается).
2. На электрической принципиальной схеме должны быть изображены все электрические элементы, необходимые для изучения и измерения заданных процессов и

их контроля, все электрические связи между ними, а также элементы (разъемы, зажимы), которыми заканчиваются входные и выходные цепи (условные обозначения на схемах приведены в приложении 3).

3. При сборке разветвленной части цепи вначале собирают цепь из последовательно соединенных источников электрической энергии, измерительных приборов, устройств управления и коммутации, а затем к элементам этой (основной) цепи присоединяют другие элементы, подключаемые параллельно. В последнюю очередь включают обмотки вольтметров и параллельно обмотки ваттметров.

4. Когда на схеме имеются узлы, в которых соединено три и более проводников (рис.8), при сборке цепи под одним зажимом необходимо располагать не более 2-х проводников. В противном случае соединения получаются непрочными.

Рис.8



В этих случаях можно найти всегда точки с равными потенциалами, например: точки А и Д ($\varphi_A = \varphi_D$).

5. Если в цепи имеются регулирующие устройства (потенциометры, реостаты), то они должны быть установлены в такое положение, при котором ток или напряжение на соответствующих участках цепи будут наименьшими.

6. При наличии коммутирующих устройств последние должны быть выключены.

7. Собранную цепь проверяют и, в первую очередь, убеждаются, что при включении цепи под напряжение не произойдет короткого замыкания или ее режим работы не превысит расчетный режим.

8. Без разрешения преподавателя или лаборанта включение схем категорически запрещается.

VI. ОПИСАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

Описание электроизмерительных приборов целесообразно проводить по следующей схеме:

1. Назначение прибора (см. приложение 1)

2. Род измеряемого тока

--- постоянный

~ переменный

≡ постоянный и переменный

3. Система измерительного механизма (см. приложение 2)

4. Класс точности прибора: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.

5. Условия эксплуатации I, II, III, IV

а) защищенность от внешних магнитных полей. Меньшая цифра соответствует лучшей защищенности. 1 – защищенность от электрических и магнитных полей.

б) температурный режим работы

- от + 10 до 35 С, влажность до 80%

- от – 20 до 50 . влажность до 80%

- от - 40 до 60 , влажность до 98%

6. Положение прибора во время работы.

или ↑ вертикальное положение

или → горизонтальное положение

7. Напряжение при котором испытана изоляция обмоток

2кV - прибор испытан на пробой изоляции при напряжении 2000 В.

8. Марка завода изготовителя, заводской номер, год выпуска.

1. **Цифровые мультиметры.** Цифровые измерительные приборы наиболее широко применяются в мультиметрах широкого профиля. Типовой цифровой мультиметр выполняет все обычные функции аналогового измерительного прибора, но, как правило, с лучшим качеством. На рисунке приведена упрощённая структурная схема, по которой можно судить о принципе действия базового цифрового мультиметра.

Принцип действия мультиметров основан на преобразовании входного сигнала в цифровой код с последующей обработкой и индикацией измеряемой величины на жидкокристаллическом или светодиодном дисплее. Как видно из рисунка, мультиметр имеет три основных функциональных взаимосвязанных блока.

1. **Блок измерительного преобразователя ИП** преобразует входной сигнал, то есть измеренное значение напряжения, силы тока или др. величины, в сигнал, который затем поступает в *аналого-цифровой преобразователь АЦП*. Этот сигнал имеет форму, необходимую для работы АЦП. Обычно это постоянное напряжение 200 мВ или 2 В.

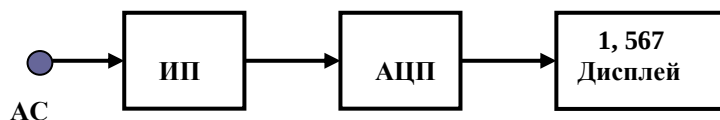


Рис. – Структурная схема базового цифрового мультиметра:

АС- аналоговый сигнал (входной сигнал); ИП – измерительный преобразователь;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

2. **Аналого-цифровой преобразователь** преобразует поступающий на его вход аналоговый сигнал, который эквивалентен входному сигналу, в цифровую форму, необходимую для индикации на дисплее.

3. **Дисплей.** Цифровая информация, полученная от аналого-цифрового измерительного устройства, передаётся на цифровое отсчётное устройство, которые выполняются в виде дисплеев, выполненных на жидких кристаллах или светоизлучающих диодах. Декодированная цифровая информация индицируется на дисплее, который преобразует код в показания, понятные человеку (в виде цифр).

Важной характеристикой дисплея является *разрядность* — число полных десятичных разрядов, которые индицируются цифрами от 0 до 9. Дисплеи, позволяющие индицировать еще один дополнительный разряд, но неполностью, называются отсчетными устройствами с расширенным диапазоном измерений. Их разрядность обозначается в виде $R_{0,9} 1/2$. Это означает, что дисплей имеет $R_{0,9}$ полных разрядов и один неполный. В нем, как правило, может индицироваться только 0 или 1.

Схема мультиметра также содержит делители напряжения, токовые шунты, выпрямители переменного напряжения, преобразователи сопротивления, емкости, переключатель и др.элементы. Конструктивно мультиметры представляют собой портативные многофункциональные измерительные приборы, изготовленные из негорючих материалов в пластмассовом корпусе.

2. Цифровой мультиметр DT 830 (MS 830) - это карманный 3,5 разрядный цифровой мультиметр, предназначенный для измерения постоянного, переменного напряжения, постоянного тока, сопротивлений и для проверки диодов и транзисторов

Передняя панель

Переключатель функций и диапазонов. Это переключатель используется как для выбора функций и желаемого предела измерений, так и для выключения прибора. Для продления срока службы батареи переключатель должен быть в положение “OFF”

когда прибор не используется.

Дисплей.3,5-зарядный 7-сегментный ЖКИ высотой 0,5 дюйма.

Разъём “COMMON”(общий). Разъём для чёрного (отрицательного) провода-щупа.

Разъём “V, Ω ,mA”. Разъём для красного (положительного) провода-щупа для измерения всех напряжений, сопротивлений и токов (кроме 10A).

Разъём “10A”. Разъём для красного (положительного) провода-щупа для измерения тока в диапазоне до 10A.

Общая инструкция

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Подключите правый щуп к входу “V, Ω ,mA”, а чёрный к “COM”.
2. Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел DC V,если измеряемое напряжение заранее неизвестно установите переключатель на наибольший предел, а затем уменьшайте до тех пор, пока не получите необходимую точность измерений.
3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.
4. Включите питание исследуемой схемы или устройства, на дисплее возникнут полярность и величина измеряемого напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Подключите правый щуп к входу “V, Ω ,mA”, а чёрный к “COM”.
2. Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел AC V
3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.
4. Считайте показания на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1. Красный щуп на входу “V, Ω ,mA”, а чёрный на вход “COM”.
(Для измерений в диапазоне между 200 mA и 10A красный щуп подсоединить к входу “10A”).
2. Переключатель пределов установить на требуемый предел DC A
3. Разомкнуть измеряемую схему и подсоедините щупы прибора последовательно с нагрузкой в которой измеряется ток.
4. Считайте показания на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

1. Красный щуп на вход “V, Ω ,mA”, а чёрный на вход “COM”.
2. Переключатель пределов установить на требуемый предел измерения Ω .
3. Если измеряемое сопротивление находится в схеме то, перед измерениями выключите

- питание схемы и разрядите все конденсаторы.
4. Считайте показания на дисплее.

ДИОДНЫЙ ТЕСТ.

1. Красный щуп на вход “V, Ω ,mA”, а чёрный на вход “COM”.
 2. Переключатель пределов установить в положение ►
 3. Подключить красный щуп к аноду а, чёрный щуп к катоду исследуемого диода.
 4. На дисплее появится значение величины прямого падения напряжения на диоде в mV. Если диод включен наоборот, то на дисплее будет “1”.
3. Провести измерения электрических величин:

Задание 1. Изучить инструкцию по применению цифрового мультиметра DT 830.

Задание 2. Измерить с помощью мультиметра DT 830:

- а) э.д.с. гальванического элемента или батареи;
- б) фото-э.д.с. и фототок короткого замыкания фотоэлемента при его освещении;

Задание 3. Измерить сопротивления резисторов и записать результаты измерений.

Задание 4. Последовательно соединить два низкоомных резистора и, измерив общее сопротивление, проверить соотношение $R_o = R_1 + R_2$.

Задание 5. Параллельно соединить два низкоомных резистора и, измерив общее сопротивление, проверить соотношение $\frac{1}{R_o} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.

Задание 6. С помощью мультиметра определите анодный и катодный выводы полупроводникового диода.

Контрольные вопросы

1. Принцип работы цифрового мультиметра.
2. Нарисовать простейшую структурную схему цифрового мультиметра.
3. Что такое разрядность дисплея мультиметра?
4. При измерении на дисплее мультиметра высвечивается слева только цифра 1 (единица), других цифр нет. Что это означает?
5. Что означают сокращения DC, AC, COM, OFF на панели мультиметра?
6. Подготовьте прибор для измерения:
 - а) постоянного напряжения величиной 1,3 В
 - б) силы постоянного тока 120 мкА, 50 мА, 5 А
 - в) переменного напряжения величиной 140 В
 - г) для измерения сопротивления 30 кОм
7. Выразите силу тока 28,6 мА в амперах (А), микроамперах (мкА).

1.2 Лабораторная работа № ЛР-2 (2 часа).

Тема: «Изучение электронного осциллографа»

1.2.1 Цель работы: Ознакомление с устройством и работой электронного осциллографа.

1.2.2 Задачи работы:

1. Изучение устройства (блок-схемы) базовой модели электронного осциллографа.
2. Изучить устройство, принцип действия и назначение электронно-лучевой трубки.

3. Изучить работу и функциональное назначение основных узлов (усилители вертикального и горизонтального отклонения, генератор горизонтальной развёртки, схема синхронизации) электронного осциллографа.

1.2.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Электронно-лучевая трубка.
2. Электронный осциллограф С1-112м.
3. Источник постоянного напряжения.
4. Источник переменного напряжения или звуковой генератор .

1.2.4 Описание (ход) работы:

Теоретическое введение

Электронный осциллограф – это универсальный измерительный прибор, предназначенный для визуального наблюдения и исследования быстропеременных периодических электрических процессов (сигналов).

В нём используется отклонение электронного луча для получения на экране видимого изображения мгновенных значений функциональных зависимостей переменных величин, одной из которых обычно является время. Это изображение электрического сигнала называется осциллограммой.

С помощью осциллографа можно измерить силу тока и напряжение, изучать зависимость силы тока и напряжения от времени, измерять сдвиг фаз между ними, измерять частоту и амплитуду различных переменных напряжений. Кроме того, при применении соответствующих преобразователей осциллограф позволяет исследовать неэлектрические процессы, например измерять малые промежутки времени, кратковременные давления и другие.

Достоинством осциллографа является его высокая чувствительность и практическая безынерционность действия, что позволяет исследовать процессы, наименьшая длительность которых составляет 10^{-10} с.

Устройство осциллографа. Электронный осциллограф – сложный радиотехнический прибор и состоит из следующих функциональных блоков, показанных на структурной схеме (блок-схеме) базового осциллографа (рис.1):

- электронно-лучевой трубки (ЭЛТ);
- входного делителя напряжений (аттенюатора);
- усилителя вертикального отклонения электронного луча;
- схемы синхронизации и запуска генератора развёртки;
- генератора развёртки (ГР);
- усилителя горизонтального отклонения электронного луча;
- блок питания, включающий низковольтный и высоковольтный выпрямители (на схеме не показан).

Как видно из схемы на рис.1 основные электрические схемы (блоки) образуют так называемые каналы «У» и «Х».

Канал вертикального отклонения электронного луча «У» содержит входное устройство (аттенюатор), предварительный усилитель У, линию задержки сигнала, окончательный усилитель.

Канал горизонтального отклонения электронного луча «Х» содержит генератор развёртки по оси Х, устройство синхронизации, предварительный и окончательный усилители по оси Х.

Все эти блоки находятся внутри корпуса осциллографа, на переднюю панель которого выведены экран электронно-лучевой трубки, тумблер включения и выключения питания, различные переключатели, ручки управления и зажимы или гнезда для подачи на

осциллограф исследуемых напряжений. Питание прибора осуществляется обычно от сети переменного тока или/и электрической батареи. Внешний вид осциллографа С1-1 показан на рис.2. Современные осциллографы как правило имеют значительно больше блоков и узлов, чем это представлено на базовой схеме, и соответственно обладают большими возможностями.

Рассмотрим устройство и принцип работы отдельных частей базового осциллографа.

1. Электронно-лучевая трубка представляет собой электронно-вакуумный прибор, относящийся к группе электронно-лучевых приборов (рис.3) и предназначена для визуального наблюдения исследуемых электрических сигналов. Она преобразует электрический сигнал в видимое изображение. Основными элементами ЭЛТ являются: стеклянная конусообразная колба, электронная пушка и отклоняющая система.

Внешне она представляет собой стеклянную колбу специальной вытянутой формы. Внутри колбы создан высокий вакуум. В колбе помещается подогреватель 1 (нить накала) катода, сам катод, управляющий электрод или модулятор 3, первый анод (фокусирующий) 4, второй анод (ускоряющий) 3, вертикально отклоняющие пластины 6, горизонтально отклоняющие пластины 7, экран 8, покрытый с внутренней стороны слоем люминофора, то есть флюоресцирующим веществом, которое светится при ударе о него быстро движущегося электрона.



Рис.1 – Структурная схема осциллографа (базовая модель)



Рис.2 – Внешний вид осциллографа С1-1

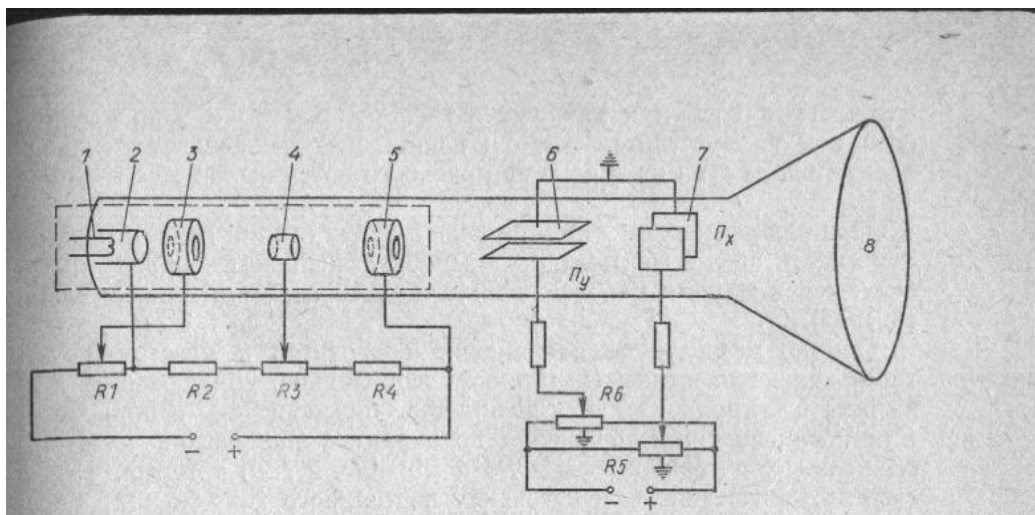


Рис.3 – Схема электронно-лучевой трубки

Нить накала (подогреватель), катод, управляющий электрод и оба анода образуют электронную пушку или электронный прожектор, назначение которого – получить сфокусированный поток электронов, называемый электронным лучом. Источником электронов является накаливаемый катод. Для формирования электронного луча из испущенных катодом электронов служат три электрода, имеющих форму коаксиальных цилиндров: управляющий электрод, первый анод и второй анод. Подача на эти электроды определённых электрических потенциалов (напряжений) приводит к образованию из испущенных электронов остросфокусированного потока быстро движущихся (ускоренных) электронов, которые, ударяясь об экран, создают на нём маленькое ярко светящееся пятно. На пути электронного луча находятся две пары пластинчатых электродов Π_x и Π_y , которые образуют отклоняющую систему, служащую для перемещения электронного луча в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Электронная пушка получает питание от высоковольтного выпрямителя, обеспечивающего разность потенциалов между катодом и вторым анодом от 1 до 5 кВ в зависимости от типа трубки. Это напряжение подаётся на ряд последовательно соединённых резисторов (потенциометров) $R1$, $R2$, $R3$, $R4$ (рис.3). Таким образом обеспечивается возможность регулирования потенциалов отдельных частей пушки, что позволяет регулировать вид (яркость и чёткость) изображения на экране.

Яркость. Подавая на управляющий электрод (модулятор) 3 отрицательный потенциал относительно катода, можно регулировать число электронов, выходящих из электронной пушки и ударяющихся об экран, заставляя его светиться (рис.3). То есть можно с помощью потенциометра $R1$ изменять яркость свечения экрана. Поэтому ручка движка потенциометра $R1$, выведенная на переднюю панель, обозначена «Яркость».

Фокус. Кроме того, совместно с первым анодом 4 управляющий электрод образует электростатическую линзу, собирающую электроны в пучок. Поток электронов, проходя внутри первого анода, сжимается, а затем окончательно фокусируется второй электростатической линзой, образованной полем между первым и вторым анодами. Изменяя потенциал первого анода с помощью потенциометра $R3$, можно осуществлять фокусировку электронного потока. Движок потенциометра $R3$ выведен на переднюю панель и обозначен «Фокус».

В результате такой фокусировки из электронной пушки выходит остросфокусированный поток электронов, называемый электронным лучём. Выйдя из второго анода, электронный луч проходит между двумя парами отклоняющих пластин и, попадая флюоресцирующий экран, вызывает его свечение. Фокусировка определяет чёткость изображения на экране.

Отклоняющая система предназначена для перемещения электронного луча в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В электронных осциллографах обычно применяется электростатическое отклонение луча. Такая отклоняющая система состоит из двух пар металлических пластин, расположенных симметрично относительно оси трубки. Пластины одной пары расположены перпендикулярно пластинам другой пары.

Первая пара пластин расположена горизонтально и отклоняет электронный луч в вертикальном направлении и поэтому называются **вертикально-отклоняющими** P_y (рис.3, 6). На эти пластины подаётся исследуемое напряжение, усиленное усилителем вертикального отклонения (усилителем Y).

Вторая пара пластин расположена вертикально и отклоняет луч в горизонтальном направлении. Эти пластины называются **горизонтально-отклоняющими** P_x (рис.3,7). На эти пластины подаётся пилообразное напряжение с генератора развёртки, которое управляет движением луча по горизонтали.

В отсутствие разности потенциалов между отклоняющими пластинами электронный луч попадает в центр экрана. При приложении к пластинам разности потенциалов между ними возникает электрическое поле, которое, действуя на пролетающие в нём электроны, отклоняет их от первоначального направления в сторону пластины с большим потенциалом. Отклонение луча зависит от величины и знака разности потенциалов, приложенной к пластинам. Смещение луча на экране пропорционально разности потенциалов между пластинами, то есть

$$x = \alpha_x U_x \quad (1)$$

$$y = \alpha_y U_y \quad (2)$$

где x, y - смещения луча в горизонтальном и вертикальном направлениях, U_x, U_y - разности потенциалов между горизонтально и вертикально отклоняющими пластинами.

Коэффициенты пропорциональности α_x и α_y называются чувствительностью трубки к напряжению соответственно в направлениях осей x и y . Чувствительность определяет смещение электронного луча на экране при разности потенциалов на пластинах 1 В и имеет небольшое значение, менее 1 мм.

При одновременном действии полей между обеими парами отклоняющих пластин электронный луч сместится и в горизонтальном и в вертикальном направлениях и окажется в точке с координатами x и y , определяемыми формулами (1) и (2).

Перемещение луча по экрану. Для перемещения изображения по экрану отклоняющие пластины соединены с потенциометрами $R5$ и $R6$, которые подсоединены к источнику постоянного напряжения (рис.3). Середина каждого из потенциометров $R5$ и $R6$ заземлена. Если движок потенциометра $R5$ стоит на середине, то между пластинами 7 разность потенциалов равна нулю, так как противоположная пластина заземлена всегда. При перемещении движка потенциометра $R5$ вправо от середины, то есть к «плюсу» источника тока, потенциал пластины P_x будет увеличиваться, что приведёт к перемещению луча на экране влево от наблюдателя. При перемещении движка влево (ближе к «минусу») луч будет смещаться вправо на экране. Ручка потенциометра $R5$ также выведена на переднюю панель и обозначена «ось x влево – вправо». Аналогично работает потенциометр $R6$, с помощью которого луч перемещается по вертикали. Поэтому его ручка снабжена надписью «ось y вверх - вниз».

2. Блок схема осциллографа. Непосредственно на отклоняющие пластины P_x и P_y исследуемое напряжение подаётся сравнительно редко. Для этой цели в задней стенке корпуса или сбоку имеются специальные гнезда.

Обычно исследуемое напряжение подаётся на входные зажимы или гнезда, расположенные в нижней части передней панели осциллографа. Левый «Вход» - вход Y , а правый «Вход» - это вход X . Так как одна из каждой пары отклоняющих пластин заземлена (соединена с корпусом прибора), исследуемое напряжение U_y должно подводиться к левой клемме «Вход» и корпусу, а напряжение U_x - к правой клемме

«Вход» и также к корпусу. Для удобства рядом установлены клеммы «Земля», которые закорочены между собой корпусом осциллографа и в случае сильных помех заземляются.

Аттенюатор или делитель напряжения. С входных клемм напряжение U_y подаётся на делитель напряжения, состоящий из нескольких резисторов R_1, R_2, R_3 (рис.4). С помощью этого делителя и переключателя Π_1 на потенциометр R_4 подаются напряжения, равные: $U_y, 0,1 U_y, 0,01 U_y, 0,001 U_y$, то есть осуществляется ступенчатое изменение напряжения. Переключатель Π_1 имеет на передней панели ручку, обозначенную «Ослабление». Перемещая движок потенциометра R_4 (рис.4) можно плавно изменять напряжение, подаваемое на усилитель вертикального отклонения Y , а следовательно, и на пластину Π_y . Ручка потенциометра R_4 на передней панели снабжена надписью «Усиление плавно». Аналогичный потенциометр R_5 и усилитель горизонтального отклонения X находятся перед пластиной Π_x .

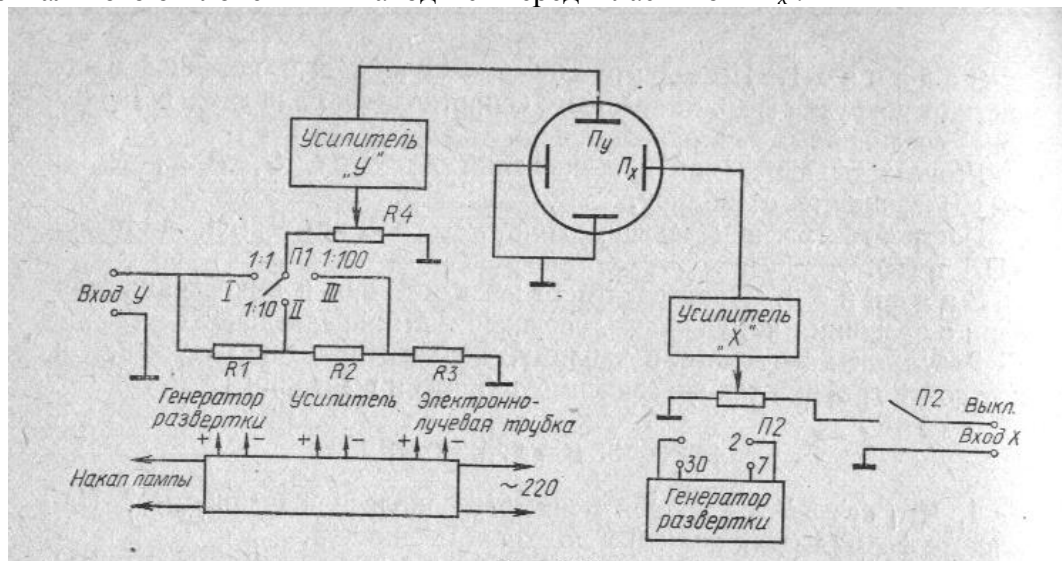


Рис.4 - Упрощённая блок-схема осциллографа С1-1

Усилитель вертикального отклонения луча усиливает слабые исследуемые электрические сигналы до напряжений, которые вызывают заметные смещения луча на экране, что позволяет наблюдать исследуемые сигналы.

Канал горизонтального отклонения луча (канал развёртки «X») состоит из генератора развёртки, усилителя горизонтального отклонения и блока синхронизации.

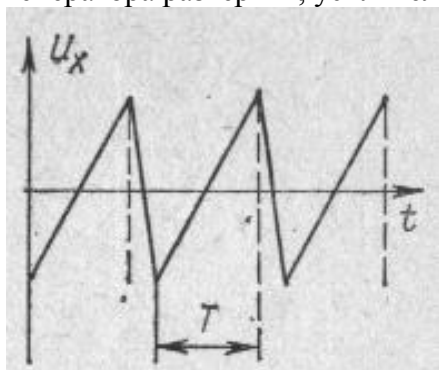


Рис.5 – График зависимости напряжения сигнала генератора развёртки, от времени

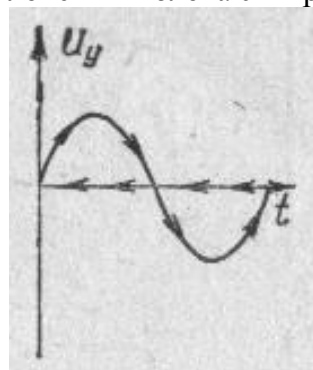


Рис.6 – Осциллограмма синусоидального

Генератор развертки предназначен для формирования пилообразного напряжения, которое подаётся на пластины Π_x для перемещения электронного луча по горизонтали. График импульсов напряжения пилообразной формы показан на рис.5. Напряжение в течение промежутка T линейно увеличивается, а затем почти мгновенно

падает до первоначального значения. Частоту напряжения, вырабатываемого генератором развёртки, можно ступенчато и плавно изменять в достаточно широких пределах (как правило от, 10 Гц до 1 МГц и более). Движение (прямой ход) электронного луча по экрану происходит слева направо, быстрый обратный ход – в противоположном.

Усилитель горизонтального отклонения предназначен для усиления пилообразного напряжения, поступающего на его выход с генератора развёртки. С выхода усилителя усиленное пилообразное напряжение поступает на горизонтально отклоняющие пластины P_x для перемещения луча в горизонтальной плоскости.

Подадим такое пилообразное напряжение на пластину P_x и проследим за движением луча на экране. Поскольку напряжение U_x пропорционально времени t в течение промежутка времени T , смещение x тоже пропорционально времени, то есть луч движется по экрану равномерно слева направо. Это движение луча называется **прямой ход луча**. Когда напряжение быстро падает до начального, луч быстро возвращается в исходную точку (**обратный ход**). Обратный ход луч происходит настолько быстро, что его след на экране почти незаметен. Однако во многих современных осциллографах при обратном ходе луч гасится. Для этого на управляющий электрод электронной пушки подаётся отрицательное запирающее напряжение, не позволяющее электронам вылетать из электронной пушки.

С помощью переключателя на передней панели «Диапазон частот» и ручки «Частота» можно менять частоту (период) пилообразного напряжения, выдаваемого генератором развёртки. При частотах до 10 Гц заметно перемещение луча на экране в виде движущегося маленького светящегося пятнышка или точки. При больших частотах след луча из-за инерционности человеческого зрения сливается в сплошную линию.

Во многих современных осциллографах регулировка частоты развёртки выведена на панель в виде удобной двойной ручки с надписью «Развёртка». При этом под ней указывается не частота, а интервал времени, соответствующий одному делению шкалы осциллографа, «время/дел».

Фиксирование временных процессов на экране осциллографа. Как образуется на экране изображение зависимости электрического сигнала (напряжения) от времени, которое называется осциллограммой ?

Одновременно с напряжением развёртки, поданным на пластину P_x , подадим на вход Y периодически меняющееся напряжение U_y с периодом T , равным периоду развёртки. При этом луч будет участвовать в двух взаимно перпендикулярных движениях и вычерчивать на экране траекторию этого движения. Пусть U_y изменяется со временем синусоидально, то есть $U_y = U_m \sin(2\pi \frac{t}{T})$.

Тогда луч будет колебаться в вертикальном направлении и при этом равномерно перемещаться в горизонтальном направлении слева направо. Очевидно, что траектория луча будет представлять собой синусоиду (рис.6). По окончании периода T луч быстро вернётся в крайнее левое положение (обратный ход) и снова начнёт вычерчивать на экране синусоиду. Если периоды развёртки и исследуемого напряжения (в примере синусоидального) равны, то следующая синусоида точно совпадёт с первой, и на экране – при частоте исследуемого сигнала больше 16 Гц – будет видна неподвижная светящаяся линия (в данном примере синусоида).

Как выглядит осциллограмма исследуемого сигнала при изменении частоты развёртки? На рис.7 (слева) изображён график $U_y(t)$, а на него наложен график пилообразного напряжения, который делит ось времени на промежутки $\Delta t_1 = \Delta t_2 = \Delta t_3 = T_{разв.}$, в течение которых происходит полная развёртка. Луч на экране при каждой развёртке вычерчивает ту часть синусоиды, в течение которой происходит развёртка. При равенстве периодов $T_{иссл.} = T_{разв.}$ Кривые I, II, III одинаковы и при наложении друг на друга совпадают и на экране наблюдается осциллограмма одного колебания (рис.7, справа).

Если уменьшить частоту развёртки вдвое, то есть увеличить период развёртки в два раза, то за увеличенное время развёртки луч успеет совершить два полных колебания в вертикальном направлении, и на экране будет видна картина, изображённая на рис.8. Эта осциллограмма изображает два полных колебания (колебательного движения в вертикальном направлении) луча по поверхности экрана.

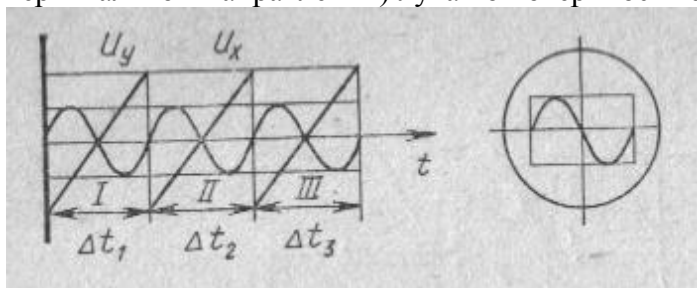


Рис.7

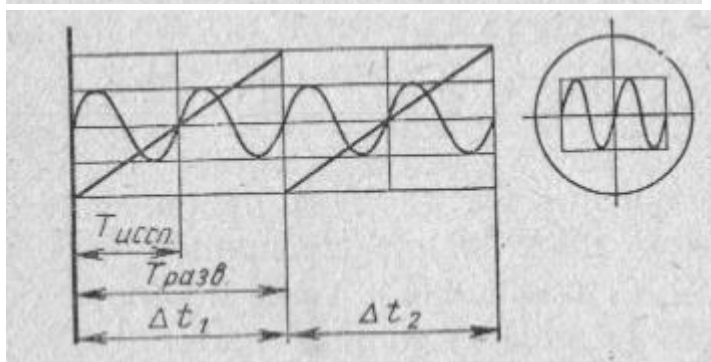


Рис.8

Если $U_y(t)$ изменяется по другому закону, но является периодической функцией, то на экране будет наблюдаться соответственно график этого напряжения, что и используется при исследовании различных процессов.

Однако, если период развёртки T_x не является целым кратным периоду T_y изучаемого напряжения, то электронный луч будет начинать движение слева направо каждый раз в различных фазах (положениях, состояниях) и получаемая на экране картина будет представлять собой наложение нескольких смещённых траекторий. Разобраться в такой картине (осциллограмме) практически невозможно и приходится изменять период развёртки до тех пор, пока он не станет согласованным с периодом изучаемого напряжения ($T_x = n T_y$).

Устойчивая картина на экране осциллографа (осциллограмма) наблюдается при совпадении частоты исследуемого напряжения и частоты развёртки или в более общем случае тогда, когда периоды $T_{разв.}$ и $T_{иссл.}$ кратны друг другу

$$T_{разв.} = n T_{иссл.}, \quad \text{где } n - \text{целое число.}$$

Исследовать можно и одиночные электрические импульсы, но при этом применяется более сложная техника (осциллографы).

Схема (блок) синхронизации предназначен для получения неподвижного изображения на экране электронно-лучевой трубки. Блок синхронизации осуществляет запуск генератора развертки, который вырабатывает пилообразное напряжение.

Принцип синхронизации состоит в следующем. Допустим, что нам удалось с помощью ручки «Частота плавно» подобрать частоту развёртки (частоту генератора), кратную частоте исследуемого сигнала. Однако, вследствие нестабильности частоты генератора развёртки через некоторое время это условие не будет полностью соблюдаться и изображения на экране не будут накладываться друг на друга. При этом картина (осциллограмма) будет перемещаться по экрану, что затрудняет наблюдение.

Для получения устойчивого изображения важно, чтобы начало развёртки всегда совпадало с одной и той же фазой исследуемого сигнала, то есть чтобы развёртка начиналась одновременно с прохождением исследуемого напряжения, например, через нулевое значение. Тогда начальные точки графика будут накладываться друг на друга. В

силу периодичности сигнала совпадут и все остальные точки изображения. В этом случае говорят, что развёртка синхронизирована (согласована во времени) с исследуемым сигналом.

Синхронизация – это процесс, при котором работа генератора развёртки становится зависимой (связанной) от исследуемого сигнала. Синхронизацию осуществляют с помощью схемы синхронизации. **Режим синхронизации может быть внутренним и внешним.**

При работе осциллографа в режиме внутренней синхронизации из канала вертикального отклонения снимается часть усиленного исследуемого сигнала и подаётся на вход схемы синхронизации. Эта схема совместно со схемой запуска генератора развёртки вырабатывает короткие импульсы определённой формы, полярности и амплитуды, которые осуществляют запуск генератора развёртки. Формирование запускающих импульсов происходит в тот момент, когда напряжение на входе блока синхронизации достигает определённой величины, которая выбирается регулятором «уровень синхронизации».

При работе в режиме внешней синхронизации сигнал, управляющий запуском генератора развёртки, подаётся извне, то есть от отдельного внешнего источника.

Требуемый режим работы блока синхронизации задаётся переключателем рода работы (внутренняя, внешняя) и переключателем режима синхронизации. Фиксированные положения переключателя отмечены надписями:

а) «внутр» - при этом напряжение синхронизации подаётся от части исследуемого сигнала;

б) «от сети» - при этом напряжение синхронизации подаётся от переменного напряжения частотой 50 Гц;

в) «внешн» - при этом напряжение синхронизации должно быть подано от внешнего источника через гнездо «вход синхронизации».

Плавное изменение величины синхронизирующего напряжения осуществляется потенциометром, у ручки которого имеется надпись «уровень синхронизации» или «усиление».

Задание 1. Изучение устройства и работы электронно-лучевой трубки.

Нарисуйте схему устройства электронно-лучевой трубки, укажите названия и назначение её основных частей.

Задание 2. Изучение назначения и принципа работы отдельных блоков осциллографа: аттенюатора, усилителя канала вертикального отклонения, канала развёртки; разделов «Фиксирование временных процессов», «Принцип синхронизации».

Задание 3. Определение чувствительности электронно-лучевой трубки.

Смещение луча на экране пропорционально разности потенциалов между отклоняющими пластинами, то есть $x = \alpha_x U_x$ и $y = \alpha_y U_y$

где x, y - смещения луча в горизонтальном и вертикальном направлениях, U_x, U_y - разности потенциалов пластинами. Коэффициенты α_x и α_y называются чувствительностью трубки к напряжению соответственно в вертикальном и горизонтальном направлениях. Чувствительность определяет смещение электронного луча на экране при разности потенциалов на пластинах 1 В и имеет небольшое значение.

Выполнение:

- включите осциллограф и через несколько минут установите посередине экрана луч;

- подайте постоянное напряжение $U_y = 100$ В непосредственно на вертикально отклоняющие пластины «У» осциллографа, то есть к гнездам «У» на задней панели. При этом тумблер – переключатель должен находиться в положении «У»;

- измерьте смещение электронного луча y на экране и определите коэффициент чувствительности α_y ;

- затем, подайте постоянное напряжение $U_x = 100$ В непосредственно на горизонтально отклоняющие пластины X» осциллографа, то есть к гнездам «X» на задней панели. При этом тумблер – переключатель должен находиться в положении «X»;
- Измерьте смещение электронного луча x на экране и определите коэффициент чувствительности α_x ;
- Результаты измерений занесите в лабораторную тетрадь и сделайте выводы.

1.3 Лабораторная работа № ЛР-3 (2 часа).

Тема: «Снятие температурной характеристики терморезистора, изучение характеристик фоторезистора»

Часть 1. «Снятие температурной характеристики терморезистора»

1.3.1 Цель работы: Ознакомиться со свойствами полупроводниковых терморезисторов.

1.3.2 Задачи работы:

1. Ознакомиться со свойствами полупроводниковых терморезисторов;
2. Измерение (снятие) температурной характеристики терморезистора

1.3.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. терморезистор,
2. цифровой мультиметр,
3. термометр технический,
4. электрическая плитка лабораторная,
5. стакан металлический,
6. штатив с муфтой и лапкой,
7. соединительные провода.

1.3.4 Описание (ход) работы:

1. Изучить теоретическое введение и записать основные необходимые сведения о свойствах полупроводников и полупроводниковых терморезисторов.

Теоретическое введение

1. Полупроводники и их свойства. Электропроводность полупроводников.

Полупроводниками называют вещества, способные значительно изменять свои свойства под влиянием различных внешних воздействий (температуры, освещения, электрического и магнитного полей, ввода в небольшом количестве чужеродные примеси и т.д.). Можно отметить некоторые важные свойства полупроводников:

1. Полупроводниковые материалы при комнатной температуре имеют удельное электрическое сопротивление $\rho = 10^{-3} - 10^{12}$ Ом · см.
2. Механизм электропроводности полупроводников качественно отличается от механизма электропроводности проводников (металлов и электролитов). Это проявляется не только в обычно большом удельном сопротивлении полупроводника, но и в иной зависимости этого сопротивления от температуры.

Сопротивление чистого, однородного полупроводника с ростом температуры очень сильно (экспоненциально) уменьшается, тогда как у металлов наоборот – с ростом температуры сопротивление несколько увеличивается.

При температуре, близкой к абсолютному нулю, удельное сопротивление металлов достигает малых значений, а их проводимость значительна или даже переходит в сверхпроводимость. Удельное сопротивление полупроводников при низких температурах очень велико и приближается к удельному сопротивлению диэлектриков.

3. Электрические свойства полупроводников очень чувствительны к присутствию в нём чужеродных (примесных) элементов. Например, вводя в полупроводник ничтожно малые количества примесных атомов определённого вида (это называется легированием) его электропроводность можно изменить до $10^6 - 10^7$ раз.

4. При освещении полупроводника светом определённого спектрального состава происходит сильное изменение (уменьшение) его электрического сопротивления. Это явление называется внутренним фотоэффектом или фотопроводимостью и нашло широкое применение.

5. Также сильно изменяется удельное сопротивление полупроводников при внесении их в постоянное магнитное поле, под влиянием внешнего электрического поля, при облучении ускоренными ионизированными частицами.

Полупроводниковыми свойствами обладает множество веществ как с кристаллической, так и с аморфной (некристаллической) структурой. Кристаллическими полупроводниками являются некоторые химические элементы (кремний, германий, селен, теллур и др.), химические соединения (арсенид галлия, антимонид индия, сульфид кадмия и др.), некоторые оксиды и ряд других веществ сложного состава. При производстве полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, представляющих собой устройства для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов, наиболее широко используют кремний Si, германий Ge и арсенид галлия GaAs.

Механизм электропроводности полупроводников. Величина плотности тока j , возникающего в проводнике под действием внешнего электрического поля, зависит от концентрации свободных зарядов (электронов) n и определяется выражением

$$j = env \quad (1)$$

где n - концентрация свободных носителей заряда (электронов), v - средняя скорость направленного движения (или дрейфовая скорость), приобретаемая носителями заряда в электрическом поле, e - величина заряда электрона.

Дрейфовая скорость v зависит от природы проводника и напряжённости электрического поля в нём. Обычно эту величину записывают в виде произведения напряжённости поля E и подвижности свободных носителей заряда μ .

Подвижность свободных носителей заряда μ (электронов, ионов, дырок) – это величина, численно равная дрейфовой скорости, приобретаемой ими в электрическом поле напряжённостью $E = 1$ В/м. Величина подвижности μ и её температурная зависимость определяются физическими процессами, которые влияют на направленное движение носителей. Эти процессы называются механизмами рассеяния носителей и бывают разными. Применяя эту величину μ , формулу (1) можно записать в виде:

$$j = env = en\mu E \quad (2)$$

Записав закон Ома в дифференциальной форме $j = \gamma E$ и сравнив с формулой (2), видно что удельная электропроводность вещества определяется концентрацией свободных носителей n и их подвижностью μ согласно формуле

$$\gamma = en\mu \quad (3)$$

Электропроводность вещества обусловлена перемещением валентных электронов, осуществляющих перенос электрического заряда. В металле (проводнике) всегда в огромном количестве имеются свободные электроны с концентрацией $n = 10^{22} - 10^{23} \text{ см}^{-3}$, которые в электрическом поле направлены перемещаются, образуя электрический ток.

В чистом и однородном полупроводнике при отсутствии внешних воздействий и невысокой температуре количество свободных электронов мало, поэтому при обычных условиях проводимость полупроводников низкая. Это обусловлено тем, что значительная

часть внешних, валентных электронов атомов полупроводника связаны со своими и соседними атомами, образуя прочные химические связи (силы), которыми атомы полупроводника сцеплены друг с другом. Пока существует такая связь, эти электроны не могут участвовать в переносе заряда. **Лишь осуществляя достаточно энергичное внешнее воздействие на полупроводник (например, нагревая или освещая его светом), можно освободить часть валентных электронов, участвующих в образовании химических связей между атомами, и тем самым образовать дополнительное количество свободных электронов Δn , которые увеличат электропроводность полупроводника (см. формулу 1) и могут существенно изменить его другие свойства.**

Рассмотрим качественно механизм электропроводности полупроводников на примере типичного полупроводника германия Ge, учитывая в качестве внешнего воздействия (фактора) тепловое воздействие (нагревание) и характер химических связей между атомами. Атомы германия имеют на внешней электронной оболочке четыре слабо связанных с ядром электрона. Их называют валентными электронами. В твердом кристаллическом состоянии каждый атом германия с помощью этих четырех валентных электронов образует сильные химические связи с четырьмя другими окружающими его атомами. Связь между атомами в германии осуществляется парами валентных электронов и потому называется парноэлектронной или ковалентной. При этом каждый валентный электрон принадлежит одновременно двум атомам (рис.1), говорят, что электроны обобществляются.

Два валентных электрона взаимодействующих атомов (по одному от каждого атома) образуют между ними при своем движении область с повышенной плотностью отрицательного заряда, к которой притягиваются положительные ядра атомов. Это электрическое притяжение и является силой, удерживающей атомы друг около друга, то есть ковалентной химической связью. Три других валентных электрона каждого атома образуют такие же связи с тремя другими соседними атомами. Ковалентная связь, образованная парой электронов между каждой парой соседних атомов германия, показана на рисунке 1.

Ковалентная связь прочная и разрушить её непросто. **Энергия, необходимая для удаления (вырывания) одного электрона ковалентной связи, является энергетической характеристикой (параметром) полупроводника и называется шириной запрещённой зоны E_g .** Этот параметр разный у разных полупроводников и намного превышает энергию теплового движения атомов при комнатной и более низких температурах. У германия она составляет $E_g = 0,67$ эВ, у кремния - $E_g = 1,12$ эВ, тогда как средняя энергия теплового движения при температуре 300 К намного меньше $kT = 0,026$ эВ. Такой тепловой энергии разумеется недостаточно, чтобы разрушить ковалентную связь и освободить электрон, и потому концентрация свободных электронов в полупроводниках на много порядков меньше, чем в металлах, и при обычных условиях электропроводность полупроводников низкая.

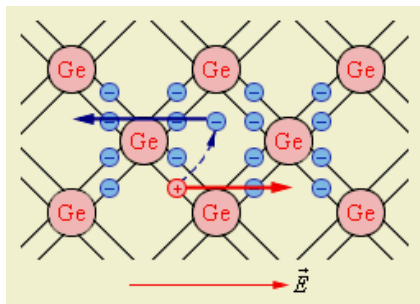


Рис.1 - Ковалентные связи в кристалле Ge и образование электронно-дырочной пары.

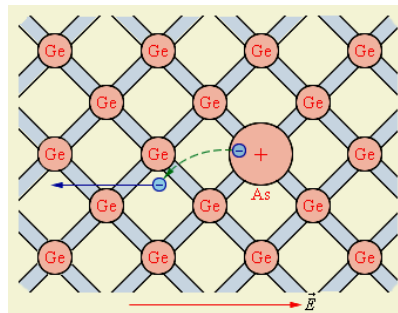


Рис.2 – Атом мышьяка в решетке германия. Полупроводник n-типа.

При повышении температуры часть валентных электронов приобретает тепловую энергию, достаточную для разрыва ковалентной связи, то есть для отрыва от пары атомов германия. Оторвавшийся электрон способен свободно перемещаться по кристаллу и он становится свободным носителем заряда (рис.1). В результате образования свободных электронов полупроводник (германий) приобретает свойство электропроводности.

Разорванную ковалентную связь называют дыркой. Недостаток электрона в одной из связей означает, что атом (или пара атомов) имеет положительный заряд, численно равный заряду электрона e . Разорванная ковалентная связь может быть заполнена валентным электроном одного из соседних атомов германия. На месте этого электрона вновь образуется разорванная связь - дырка. Такой процесс может повторяться, а это означает, что дырка способна перемещаться по кристаллу, то есть тоже является свободным носителем заряда, имеющим в отличие от электрона положительный заряд. Следует отметить, что дырка не является реальной материальной частицей, в отличие от электрона проводимости. **Дырка – это вакантное электронное состояние в нарушенной ковалентной связи полупроводника.**

Таким образом, разрыв одной ковалентной связи приводит к появлению пары свободных носителей заряда — электрона и дырки, так называемой **электронно-дырочной пары**. Образование свободных носителей заряда (электронов и дырок) под действием тепловой энергии называют термической генерацией (**термогенерацией**) носителей. С ростом температуры концентрация электронно-дырочных пар в полупроводнике увеличивается и, следовательно, увеличивается его электропроводность.

При данной температуре полупроводника за счёт тепловой энергии в единицу времени образуется определенное количество электронно-дырочных пар. В то же время идет обратный процесс – при встрече свободного электрона с дыркой, восстанавливается электронная связь между атомами германия, а электронно-дырочная пара исчезает. **Этот процесс называется рекомбинацией.**

Свободные электронно-дырочные пары могут образовываться также под действием других источников энергии, способных разрушить ковалентную связь, например, при освещении полупроводника видимым светом, при облучении ускоренными частицами или жестким электромагнитным излучением.

В отсутствие электрического поля свободные электроны и дырки участвуют в хаотическом тепловом движении. Но если полупроводник помещается в электрическое поле, то возникает упорядоченное движение свободных зарядов (ток). В нём участвуют не только свободные электроны, но и дырки, которые ведут себя как положительно заряженные частицы. Поэтому ток I в полупроводнике складывается из электронного I_n и дырочного I_p токов $I = I_n + I_p$. При этом концентрация электронов проводимости n в полупроводнике равна концентрации дырок (p) $n = p$. Электронно-дырочная проводимость проявляется только у чистых и однородных полупроводников.

Общую электропроводность полупроводников, обусловленную генерацией, перемещением и рекомбинацией пар электрон-дырка, называют собственной электропроводностью или проводимостью, а сам полупроводник называется собственным полупроводником. Собственная проводимость обычно невелика. Значительно лучшей проводимостью обладают примесные полупроводники, причём характер проводимости зависит от вида примесного вещества.

Примесная проводимость полупроводников. При наличии примесей проводимость полупроводников сильно изменяется. Например, добавка фосфора в кристалл кремния в количестве 0,001 атомного процента уменьшает удельное сопротивление более чем на пять порядков. **Необходимым условием уменьшения сопротивления полупроводника при введении примесей является отличие валентности атомов примеси от валентности основных атомов полупроводника.**

Проводимость полупроводников, обусловленную присутствием примесей называется **примесной проводимостью**. Различают два типа примесной проводимости –

электронную и дырочную. **Электронная проводимость** возникает тогда, когда в кристалл германия или кремния с четырехвалентными атомами введены (в очень небольшом количестве) пятивалентные чужеродные атомы (например, атомы мышьяка As или фосфора P).

На рис. 2 показан пятивалентный атом мышьяка As, находящийся в узле кристаллической решетки германия вместо атома германия Ge. Четыре валентных электрона атома мышьяка участвуют в образовании ковалентных связей с четырьмя соседними атомами германия. Пятый валентный электрон атома мышьяка оказался лишним, он легко отрывается от атома и становится свободным. Атом же мышьяка As, потерявший электрон, превращается в положительный ион, расположенный в узле кристаллической решетки. Он не может перемещаться. **Примесные атомы с валентностью, превышающей валентность основных атомов полупроводника и потому легко отдающие электроны, называются донорной примесью.** В результате ее введения в кристалле появляется значительное число свободных электронов, что приводит к резкому уменьшению удельного сопротивления полупроводника.

В германии с примесью мышьяка есть также электроны и дырки, ответственные за собственную проводимость полупроводника, которые образованы за счет тепловой энергии. Но основным типом носителей свободного заряда являются электроны, оторвавшиеся от атомов мышьяка. В таком кристалле концентрация свободных электронов намного больше концентрации дырок $n \gg p$. **Поэтому такая проводимость называется электронной, а полупроводник, обладающий электронной проводимостью, называется электронным или полупроводником n-типа (от латинского слова *negative*, отрицательный).**

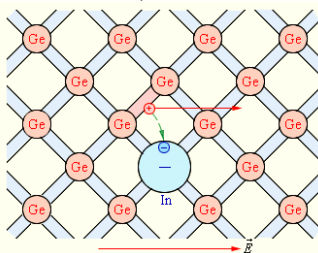


Рис. 3 - Атом индия в решетке германия.
Полупроводник p – типа.

Дырочная примесная проводимость возникает тогда, когда в кристалл германия или кремния введены трехвалентные примесные атомы (например, атомы индия In или бора B). На рис. 3 показан атом индия In, который образовал с помощью своих трех валентных электронов ковалентные связи лишь с тремя соседними атомами германия. На образование связи с четвертым (ближним соседом) атомом германия у атома индия нет электрона. Однако, этот недостающий электрон может быть легко захвачен атомом индия из ковалентной связи соседних атомов германия. В этом случае атом индия превращается в отрицательный ион, расположенный в узле решетки, а в ковалентной связи соседних атомов образуется вакансия, то есть дырка. **Примесные атомы с валентностью, меньшей валентности основных атомов полупроводника, способные захватывать электроны, называются акцепторной примесью.** В результате введения акцепторной примеси в кристалле разрывается множество ковалентных связей и образуются вакантные электронные места (дырки).

Наличие акцепторной примеси резко снижает удельное сопротивление полупроводника за счет появления большого числа свободных дырок. Концентрация дырок в полупроводнике с акцепторной примесью значительно превышает концентрацию собственных электронов и дырок, которые возникли вследствие теплового разрушения ковалентных связей основных атомов полупроводника $p \gg n$. **Проводимость, обусловленную высоким содержанием дырок, называется дырочной, а сам примесный полупроводник с дырочной проводимостью называется**

полупроводником р-типа (*пэ – типа, от лат. слова positive, положительный*) **или дырочным**. Основными носителями заряда в полупроводниках р-типа являются дырки.

Формула удельной электропроводности (3) верна для металлических проводников с одним типом свободных носителей заряда (электронов проводимости). Поскольку в полупроводниках, кроме свободных электронов, перенос заряда осуществляют также и дырки - свободные подвижные носители положительного заряда, формула (3) должна быть дополнена ещё одним слагаемым, учитывающим участие дырок в образовании тока. Для полупроводников она имеет вид:

$$\gamma = e n \mu_n + e p \mu_p , \quad (4)$$

здесь e - заряд электрона, n – концентрация электронов, μ_n - подвижность электронов, p и μ_p - концентрация и подвижность дырок, соответственно.

Как видно из формулы (4), изменяя каким-либо способом (воздействием) концентрацию электронов и дырок в полупроводнике, а также их подвижность, можно заметно изменить электрические свойства полупроводника.

Способность полупроводников изменять свои свойства под внешним воздействием используется в полупроводниковых параметрических приборах. Одним из основных механизмов, который используется в таких приборах, является процесс генерации пар электрон-дырка под воздействием внешних факторов. Полупроводниковые параметрические приборы являются безпереходными. В них отсутствуют р-п –переходы. Наиболее яркими представителями таких приборов являются терморезисторы и фоторезисторы, широко применяемые в электронной автоматике.

2. Полупроводниковые терморезисторы или термисторы (старое название – термосопротивления) - полупроводниковые приборы, принцип действия которых основан на свойстве полупроводников значительно изменять свое электрическое сопротивление (электропроводность) при изменении температуры.

Терморезисторы представляют собой объёмные или плёночные полупроводниковые резисторы, электрическое сопротивление которых изменяется при изменении температуры.

Характер изменения сопротивления полупроводника при изменении его температуры определяется влиянием температуры на физические процессы, обуславливающие электропроводность полупроводника. Удельная электропроводность полупроводников определяется концентрацией электронов и дырок и их подвижностью в электрическом поле согласно формуле (4) $\gamma = e n \mu_e + e p \mu_p$. Поэтому очевидно, что температурная зависимость электропроводности γ полупроводников определяется температурным ходом (зависимостью от температуры) концентраций и подвижностей свободных носителей заряда (электронов и дырок).

О первой причине – роль концентрации свободных носителей заряда. В полупроводниках концентрация свободных зарядов определяется природой полупроводника (шириной запрещённой зоны полупроводника). В нагретом состоянии ($T > 0$) часть атомов кристаллической решетки полупроводника ионизуется, образуя в равных количествах свободные электроны и дырки. Поэтому в чистом и однородном полупроводнике, обладающем собственной проводимостью, с ростом его температуры, его сопротивление уменьшается за счёт значительного увеличения концентрации свободных носителей заряда (электронов и дырок). Кроме того, в любом полупроводнике есть примеси, которые также являются поставщиками электронов или дырок, концентрация которых также зависит от температуры.

О второй причине – роль подвижности. Подвижность свободных носителей заряда в кристаллических твёрдых телах связана с рассеянием носителей заряда на дефектах (отклонениях от идеальности) кристаллической решетки. Под рассеянием понимается изменение скорости и направления движения (отклонение) направленно движущихся в электрическом поле свободных зарядов, которое происходит из-за

взаимодействия с электрическим полем структурного дефекта. Механизмы рассеяния бывают разные.

В случае рассеяния свободных носителей заряда на тепловых колебаниях ионов полупроводника около их положения равновесия при $T > 0$, зависимость подвижности от температуры примерно имеет вид $\mu \approx T^{-3/2}$. Видно, что с повышением температуры подвижность μ уменьшается. Следует отметить, что изменение электропроводности полупроводника за счёт изменения подвижности, может быть заметно меньше, чем её изменение, вызванное термогенерацией электронно-дырочных пар.

Из сказанного ясно, что выбирая или создавая новое полупроводниковое вещество определённого состава и структурного совершенства, можно изготовить терморезисторы с разной реакцией на изменение температуры.

Терморезисторами или термисторами принято называть терморезисторы, у которых сопротивление уменьшается при повышении температуры и наоборот. Они наиболее широко применяются в технике.

Терморезисторы, у которых с повышением температуры сопротивление тоже увеличивается, называют **позисторами**.

Количественно изменение сопротивления терморезистора при изменении температуры характеризуют параметром «**температурный коэффициент сопротивления ТКС или ТКР**». Это величина равна относительной доле, которую составляет изменение сопротивления терморезистора ΔR от первоначального значения R (при некоторой начальной температуре) при изменении его температуры на 1 градус. Единица измерения - $1/^\circ\text{C}$ или $1/\text{K}$.

$$TKC = \frac{1}{R} \cdot \frac{dR}{dt} \quad (5)$$

Обычно этот параметр приводят в процентах, умножая на 100 %. Очевидно, что у терморезисторов ТКС есть отрицательная величина, а у позисторов – положительная.

Основой для изготовления многих типов терморезисторов являются поликристаллические полупроводниковые материалы с электронной проводимостью – окислы так называемых переходных металлов (от титана до цинка). Эти материалы получают в виде порошка, из которого, добавляя связующее вещество, прессуют терморезисторы в виде цилиндрических стержней, трубок, шайб, бусинок, прямоугольных пластинок. Для защиты от воздействия внешней среды их поверхность покрывают специальными эмалями и лаками. Также достаточно широко используются для их изготовления кристаллические кремний, германий и карбид кремния и некоторые другие полупроводники. Внешне они похожи на маломощные резисторы и конденсаторы (рис.4). Их обозначение на электрических схемах показано на рис.5.



Рис.4

Различают терморезисторы, реагирующие на внешний нагрев (температуру окружающей среды) и на нагрев током, проходящим через рабочее тело (термочувствительный элемент) терморезистора. Терморезисторы с реакцией на внешний нагрев используют для измерения температуры окружающей среды; они служат датчиками температуры. Терморезисторы, реагирующие на нагрев током, применяют для регулирования процессов в электрических цепях.



Рис. 5

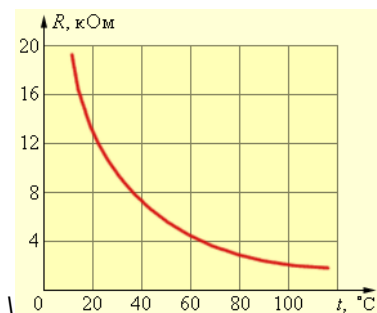


Рис. 6

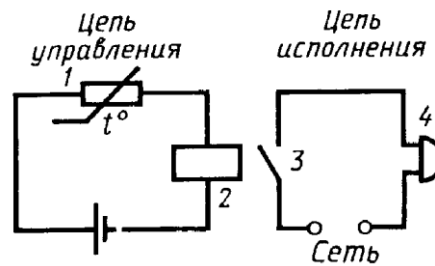


Рис. 7

У наиболее распространенных терморезисторов с отрицательным ТКС с ростом температуры сопротивление уменьшается (рис.6). Это обусловлено увеличением концентрации свободных носителей заряда в рабочем теле. При этом зависимость сопротивления терморезистора от температуры определяется уравнением

$$R_T = A e^{B/T}, \quad (6)$$

где A – коэффициент, зависящий от удельного сопротивления полупроводника и размеров рабочего тела; B – **коэффициент температурной чувствительности**, определяемый свойствами полупроводника; T – термодинамическая температура.

График зависимости, соответствующий уравнению (6), называют **температурной характеристикой терморезистора**. Пример такой характеристики показан на рис.6.

Терморезисторы широко применяют в автоматических устройствах. Упрощенная схема температурной сигнализации, использующая терморезистор (1), электромагнитное реле (2, 3) и сигнализатор (4), показана на рис.7.

2. Измерение (снятие) температурной характеристики терморезистора

- Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

Таблица 1

t, °C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R, Ом											

- Соберите измерительную установку. Панель терморезистора укрепите в лапке штатива, а пробирку с терморезистором погрузите в стакан с холодной водой, установленный на электрической плитке. В пробирку вставьте термометр, а к зажимам терморезистора подключите цифровой мультиметр, подготовленный для измерения сопротивления.

- Измерьте начальную температуру терморезистора (она равна температуре воды в стакане) и начальное сопротивление терморезистора.

- Включите электрическую плитку и нагревайте воду до 90° - 100 °С. При температурах 10, 20 , 30°С и так далее измерьте сопротивление терморезистора. Результаты измерений запишите в таблицу1.

Примечание. Измерения следует вести вдвоём: один записывает показания термометра, а другой одновременно снимает показания мультиметра.

- По данным таблицы постройте график зависимости сопротивления терморезистора от температуры $R = f(t \text{ } ^\circ\text{C})$. По оси абсцисс следует откладывать температуру по шкале Цельсия, а по оси ординат – сопротивление терморезистора в омах.

Контрольные вопросы

1. Полупроводники и их основные свойства.
2. Собственная и примесная электрическая проводимость полупроводников. Свободные носителя заряда в полупроводниках. Формула электропроводности полупроводников.
3. Полупроводниковые терморезисторы. Что это такое ? Принцип действия и устройство.

4. Основные параметры и характеристики терморезисторов. Что называется температурной характеристикой терморезистора ? Какой вид она имеет?
5. Что такое терморезисторы типов ММТ и КМТ ?
6. Что называется позистором ?
7. Применение терморезисторов. Упрощённая схема температурной сигнализации, использующая терморезистор.

Приложение

1. Основные параметры и характеристики терморезисторов прямого подогрева:

- *температурный коэффициент сопротивления ТКС*;
- *коэффициент температурной чувствительности B* - это коэффициент в показателе экспоненты температурной характеристики терморезистора (в формуле 6). Единица измерения – К (кельвин);
- *номинальное сопротивление терморезистора $R_{T_{ном}}$* - это сопротивление терморезистора при определённой температуре окружающей среды. Обычно для большинства терморезисторов это 20°C или 25°C;
- *диапазон рабочих температур ΔT* ;
- *максимально допустимая температура* – это температура, при которой ещё не происходит необратимых изменений параметров и характеристик терморезисторов;
- *максимально допустимая мощность рассеяния $P_{макс}$* - это мощность при которой терморезистор, находящийся в спокойном воздухе при температуре 20°C, разогревается при прохождении тока до максимально допустимой температуры
- *постоянная времени τ* - промежуток времени, в течение которого температура терморезистора уменьшится в $e = 2,718$ раз от выбранного перепада температур (например, при переносе его из воздушной среды с температурой 120 °C в воздушную среду с температурой 20 °C). Этот параметр характеризует способность терморезистора быстро принимать температуру окружающей среды, то есть его тепловую инерционность. Для разных типов терморезисторов постоянная времени лежит в пределах от 0,5 до 140 с.
- *температурная зависимость* - зависимость сопротивления терморезистора от температуры;
- *статическая вольт-амперная характеристика* - зависимость падения напряжения на терморезисторе от проходящего через него тока в условиях теплового равновесия между терморезистором и окружающей средой.

2. Некоторые характеристики основных типов медно-марганцевых (ММТ) и кобальто-марганцевых терморезисторов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тип термо- резистора	Пределы номи- нального сопро- тивления, кОм, при 20°C	$\pm \Delta R_{\text{ном}},$ %	Коэффициент температурной чувствитель- ности, К	Температур- ный коэффи- циент сопро- тивления, %/°C, при 20°C	Диапазон рабочих температур, °C
KMT-1	22—1000	20	3600—7200	4,2—8,4	—60 ÷ +80
MMT-1	1—220	20	2060—4300	2,4—5	—60 ÷ +125
KMT-4a, KMT-4б	22—1000	20	3600—7200	4,2—8,4	—60 ÷ +125
CCT-4a, MMT-4б	1—220	20	2060—4300	2,4—5	—60 ÷ +125
MMT-6	10—100	20	2060	2,4	—60 ÷ +125
KMT-8	0,1—10	10; 20	3600—7200	4,2—8,4	—40 ÷ +70
MMT-8	0,001—1	10; 20	2060—4300	2,4—4	—40 ÷ +70
MMT-9	0,01—4,7	10; 20	2060—4300	2,4—5	—60 ÷ +125
KMT-10*	100—330	20	3600	4,2	0 ÷ +125
KMT-11*	100—3300	20	3600	4,2	0 ÷ +125
KMT-12	0,1—10	30	3600	4,2	—40 ÷ +120
MMT-12	0,0047—1,0	30	2060—4300	2,4—4	—60 ÷ +120
MMT-13a, MMT-13б	0,01—2,2	20	2060—4300	2,4—5	—60 ± +120
KMT-14	0,51—7500**	30	4100	2,3—3,9**	—10 ÷ +300

Часть 2. «Изучение характеристик фоторезистора»

1.3.1 Цель работы: Изучение и измерение характеристик фоторезистора

1.3.2 Задачи работы:

1. Ознакомиться со свойствами фоторезисторов;
2. Измерить зависимость фототока от напряжения при постоянной освещённости (вольт-амперная характеристика).
3. Измерить световую характеристику фоторезистора.

1.3.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. фоторезистор,
2. оптическая скамья, осветитель,
3. миллиамперметр, вольтметр или цифровой мультиметры,
4. соединительные провода.

1.3.4 Описание (ход) работы:

1. Изучить теоретическое введение и записать основные необходимые сведения о свойствах полупроводников и полупроводниковых фоторезисторах.

Теоретическое введение

Фоторезистор представляет собой полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется под действием светового потока, то есть при поглощении падающего на него электромагнитного излучения (света).

Принцип работы фоторезистора основан на физическом явлении, называемым **внутренним фотоэффектом** или **фотопроводимостью**. Это явление заключается в образовании дополнительных свободных носителей заряда в полупроводнике в результате поглощения им электромагнитного излучения (света). Дополнительные свободные носители заряда, возникающие при освещении, образуют дополнительную электропроводность полупроводника, также называемую фотопроводимостью.

При внутреннем фотоэффекте поглощённая световая энергия идёт на внутреннее высвобождение связанных с атомами валентных электронов. В отличие от внешнего

фотоэффекта освобождённые электроны не покидают полупроводник, а некоторое время проводят в свободном состоянии, находясь в межатомных промежутках.

При внутреннем фотоэффекте поглощаемое электромагнитное излучение (свет) передаёт свою энергию связанным электронам. При этом связанному электрону передаётся энергия одного фотона $h\nu$.

Поэтому освобождение связанного электрона и его переход в пространство между атомами возможно только при условии, что энергия фотона равна или больше ширины запрещённой зоны полупроводника $h\nu \geq E_g$. В этом случае в полупроводнике образуются электронно-дырочные пары, которые увеличивают его электропроводность, то есть уменьшают сопротивление полупроводника.

Частота электромагнитного излучения (волн), удовлетворяющая условию $h\nu_{кр} = E_g$, называется красной или длинноволновой границей фотопроводимости. Здесь E_g – ширина запрещённой энергетической зоны полупроводника. Дело в том, что излучение с частотой $\nu < \nu_{кр}$ не может вызвать фотопроводимость, так как энергия фотона такого излучения недостаточна для освобождения связанного электрона $h\nu < E_g$. Критической частоте $\nu_{кр}$ соответствует граничная (красная или длинноволновая граница) длина волны $\lambda_{кр} = c / \nu_{кр}$. Если же энергия фотонов $h\nu \geq E_g$, то избыточная энергия фотонов передаётся электронам в виде кинетической энергии.

В полупроводниковом фоточувствительном слое фоторезистора, находящемся в темноте, при определённой температуре всегда имеется некоторая концентрация свободных носителей заряда. Этими носителями определяется ток проводимости фоторезистора, возникающий при подаче напряжения на него и называемый темновым током I_T . Световой поток, падая на фоточувствительный слой фоторезистора, может генерировать дополнительные носители заряда. Участвуя в электропроводности, они создают дополнительную проводимость, называемую фотопроводимостью. Общий ток освещённого фоторезистора называется световым и обозначают I_c . Разность между световым и темновым токами $I_\Phi = I_T - I_c$ называется фототоком проводимости.

Наряду с процессом генерации дополнительных (избыточных) носителей заряда под действием светового излучения, в полупроводнике имеет место обратный процесс воссоединения свободных электронов и дырок, называемый рекомбинацией. Рекомбинация уменьшает концентрацию свободных носителей заряда. Этот процесс в основном определяется природой полупроводника, а также видом и концентрацией примесных атомов, содержащихся в нём. При непрерывном освещении устанавливается динамическое равновесие, при котором число генерируемых электронов равно числу рекомбинирующих. В этом состоянии в полупроводнике и возникает некоторое постоянное дополнительное количество свободных зарядов, которые определяют дополнительную проводимость, то есть фотопроводимость.

Конструкция и параметры фоторезисторов. Для изготовления фоторезисторов используют наиболее фоточувствительные полупроводники: кремний, германий, селен, а также соединения свинца, кадмия и другие. Наибольшее распространение получили фоторезисторы на основе сульфида кадмия CdS, селенида кадмия CdSe и сернистого свинца PbS.

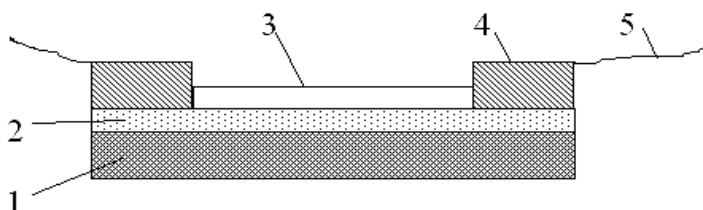


Рис. 1. Схема устройства фоторезистора

Основным рабочим элементом фоторезистора является тонкий светочувствительный слой (элемент) из полупроводника (рис.1) У одних фоторезисторов этот слой представляет собой спрессованную из порошкообразного полупроводника прямоугольную таблетку, у других – тонкий слой полупроводникового материала (2) на стеклянной или керамической подложке (1). На поверхность фоточувствительного слоя наносят два металлических электрода (4). В качестве электродов обычно применяют тонкие плёнки металлов, не подвергающихся коррозии (золото, платина, серебро), наносимых испарением в вакууме. К электродам подсоединены соединительные выводы (5) для включения фоторезистора в электрическую цепь. Для защиты от влияния влаги, воздуха и других внешних

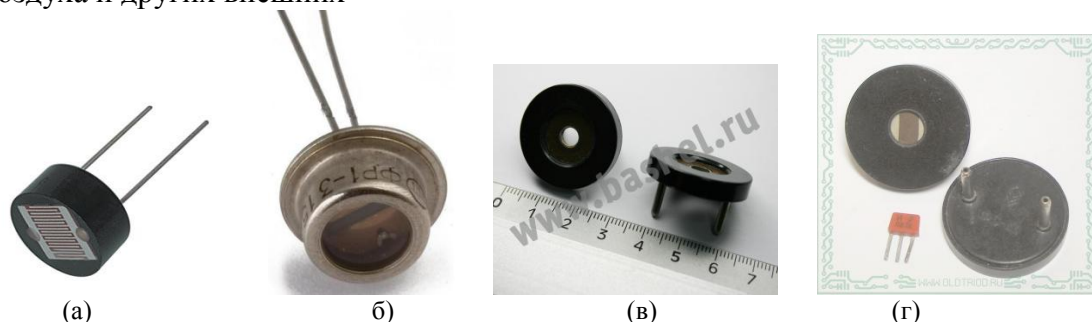


Рис.3 – Фоторезисторы различных типов: а – с рабочей площадкой в виде меандра, б – фоторезистор ФР1-3 (темная прямоугольная полоска - фоточувствительный слой), в – фоторезисторы ФСК-6, г – фоторезисторы ФС-3.

воздействий фоточувствительный слой покрывают прозрачным лаком (3) и помещают в металлический или пластмассовый корпус, имеющий окошко для прохождения светового потока. Поверхность фоточувствительного слоя, заключённую между электродами, называют рабочей площадкой. Фоторезисторы делают с рабочими площадками различной формы и размеров: прямоугольными, в виде меандра или кольца (рис.2). Внешний вид и обозначение фоторезисторов на электрических схемах показаны на рис.3 и 4.

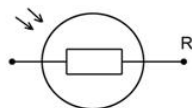


Рис.4 – Обозначение фоторезистора.

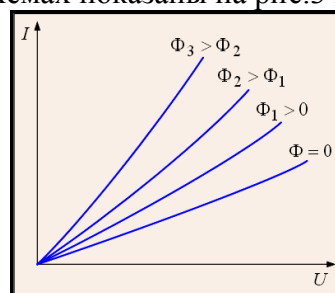


Рис.5 – Вольт-амперные характеристики фоторезистора при разных значениях светового потока Φ .

Основные характеристики фоторезисторов:

Вольт-амперная характеристика – это зависимость светового тока и фототока (при неизменном световом потоке), а также темнового тока от приложенного к фоторезистору напряжения. В рабочем диапазоне напряжений вольт-амперные характеристики линейны (рис.5).

Световая или люкс-амперная характеристика – это зависимость фототока от падающего светового потока или от освещённости. Фоторезисторы обычно имеют нелинейную световую характеристику (рис.6). При больших освещённостях увеличение фототока отстаёт от роста светового потока и намечается тенденция к насыщению. Это объясняется тем, что при увеличении светового потока с ростом концентрации генерируемых носителей заряда растёт вероятность их рекомбинации.

Спектральная характеристика - это зависимость фототока от длины волны падающего света. Спектральные характеристики обычно изображают в виде графиков (рис.7). Как видно, фоторезисторы обладают различными спектральными характеристиками в зависимости от материала, использованного для фоточувствительного слоя.

Сернисто-кадмиевые фоторезисторы имеют высокую чувствительность в видимой области спектра, селенисто-кадмиевые – в красной части спектра, а также чувствительны в ближней инфракрасной области спектра. У сернисто-свинцовых фоторезисторов максимум чувствительности лежит в инфракрасной области спектра, что даёт возможность использовать их для наблюдения и регистрации излучений слабо нагретых тел.

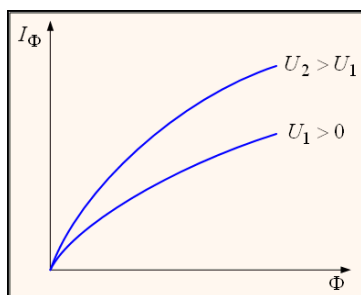


Рис.6

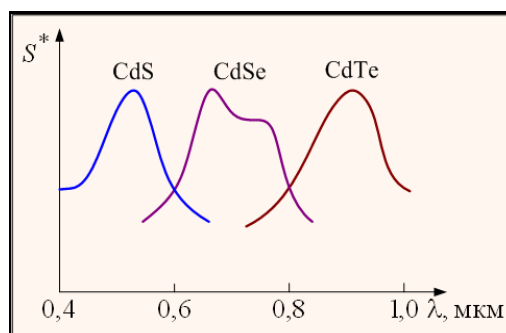


Рис.7

Параметры фоторезисторов:

Темновое сопротивление R_T – это сопротивление фоторезистора при отсутствии освещения.

Темновой ток I_T - ток, протекающий в цепи фоторезистора при приложенном рабочем напряжении при отсутствии освещения.

Световой ток $I_{св}$ – ток через фоторезистор при приложенном напряжении и освещённости 200 лк.

Интегральная чувствительность $k_\Phi = I_\Phi / \Phi \cdot U$ – это отношение величины фототока к величине падающего светового потока Φ , имеющего сложный спектральный состав, и к величине приложенного напряжения U .

Кратность изменения сопротивления $k_R = R_T / R_{св}$ – отношение темнового сопротивления к сопротивлению фоторезистора при освещённости 200лк (люкс). Характеризует фоточувствительность фоторезистора.

Рабочее напряжение U – это напряжение, при котором фоторезистор работоспособен в течение указанного срока службы. Значения рабочих напряжений взяты при освещённости 200 лк.

Допустимая мощность рассеивания P_{max} - максимальная мощность, рассеиваемая на фоторезисторе без его теплового повреждения.

Постоянная времени τ - это время, в течение которого фототок фоторезистора изменяется при освещении или при затемнении фоторезистора на 63 % ($e = 2,71$ раз) по отношению к установившемуся значению.

Эта величина характеризует скорость реакции фоторезистора на изменение светового потока, то есть характеризует его инерционность. Инерционность фоторезистора определяется временем, в течение которого носители заряда, освобожденные светом, находятся в возбуждённом (свободном) состоянии.

Основные параметры некоторых фоторезисторов приведены в таблице.

Таблица

Тип фоторезистора	Допустимая мощность рассеяния, Вт	Рабочее напряжение, В	Темновое сопротивление, МОм	Темновой ток I_T , мкА	Световой ток (фото-ток) $I_{св}$, мА	Отношение $R_T/R_{св}$	Интегральная чувствительность, А/лм	Удельная чувствительность K , 10^{-8} мА/(лм·В)
Селенисто-кадмиевые:								
ФСД-1а	0,05	20	2	1	3	2000	15	30
ФСД-1	0,05	20	2	1	3	2000	15	30
ФСД-Г1	0,05	20	2	1	3	2000	15	30
СФЗ-1	0,01	15	30	0,01	1,5	150 000	20	600
Сернисто-кадмиевые:								
ФСК-1а	0,125	50	3,3	5	2	400	2,8	7
ФСК-1	0,125	50	3,3	5	2	400	2,8	7
ФСК-2	0,125	100	3,3	10	1	100	0,5	1,6
ФСК-4а	0,125	25	1,6	5	2	400	3,0	15
ФСК-5	0,05	50	10	1	1	1000	5,0	220
ФСК-6	0,20	50	3,3	5	2	400	0,28	6
ФСК-7а	0,35	50	0,5	10	0,5	50	0,15	0,25
ФСК-7б	0,35	10	0,1	10	3	300	3,6	7,5
ФСК-Г7	0,35	50	5	5	2	400	0,7	1,8
ФСК-Г1	0,12	50	3,3	5	2	400	2,1	7
ФСК-Г2	0,2	50	1,6	10	6	800	2,1	7
ФСК-П1	0,1	100	100	0,01	2	200 000	4,8	8
СФЗ-1	0,01	15	15	0,5	1	2000	10	400
СФЗ-2	0,05	2	2	0,5—0,2	1,5	3000	0,36	75
СФЗ-2	0,1	5	5	0,5	2	4000	—	80
ФСК-М1	0,03—0,06	70	700	0,1	0,3	$10^3—10^6$	0,5—3	35—50
ФСК-М2	0,03—0,06	70	70	1	1	$10^3—10^6$	3—10	35—50
Сернисто-свинцовые:								
ФСА-1	0,01	2—100	0,022—1	—	—	1,2	—	0,5
ФСА-1а	0,01	2—100	0,022—1	—	—	1,2	—	0,5
ФСА-6	0,01	5—30	0,05—0,3	—	—	1,2	—	0,5
ФСА-Г1	0,01	4—40	0,047—0,47	—	—	1,2	—	0,5
ФСА-Г2	0,01	4—40	0,047—0,47	—	—	1,2	—	0,5

Фоторезистор имеет одинаковую проводимость в обоих направлениях (в нем нет р-п-переходов), поэтому он включается последовательно с управляемым им устройством и источником тока. Схема включения фоторезистора показана на рис.8.

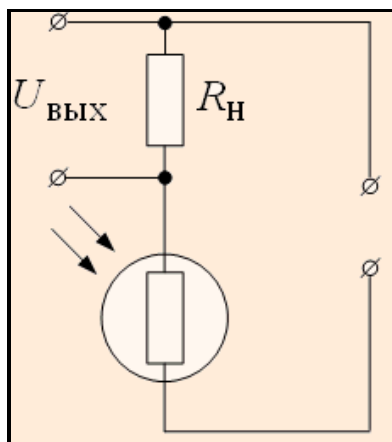


Рис.8

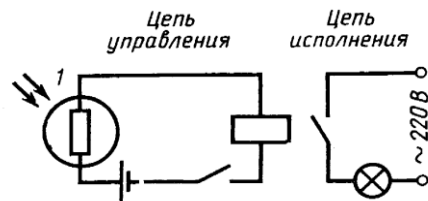


Рис.9

При отсутствии освещения ($\Phi = 0$) фоторезистор обладает большим темновым сопротивлением R_T , поэтому темновой ток мал и определяется выражением:

$$I_T = E / (R_T + R_n) \quad (1)$$

При наличии светового потока ($\Phi > 0$) сопротивление резистора уменьшается до значения $R_{св}$, определяющего вместе с источником тока E световой ток;

$$I_{св} = E / (R_{св} + R_n) \quad (2)$$

Разность этих токов $I_{св} - I_T$ определяет фототок:

$$I_\Phi = E / (R_T + R_n) - E / (R_{св} + R_n) \quad (3)$$

Фоторезистор может реагировать не только на появление светового потока, но и на его исчезновение, то есть является световым реле. При отсутствии освещения или при постоянном освещении фоторезистор представляет собой активное сопротивление, и ток,

протекающий по нему, пропорционален приложенному напряжению, а в случае постоянной величины напряжения величина тока пропорциональна интенсивности действующего светового потока.

Если фоторезистор включен последовательно с источником тока E и с резистором нагрузки R_n (рис. 8), то изменения светового потока Φ сопровождаются изменением тока в цепи, то есть фоторезистор может работать и как вакуумный фотоэлемент для преобразования световой энергии в электрическую.

Применение фоторезисторов.

- Фоторезисторы имеют рабочие токи, измеряемые миллиамперами, что даёт возможность на их основе выполнять простые и надёжные фотореле без усилителей. Основные промышленные типы фоторезисторов могут работать в схемах, питание которых осуществляется непосредственно от сети с напряжением 127 В и 220 В.

На рис.9 приведена схема фотореле с непосредственным включением в цепь последовательно с фоторезистором. Фотореле работает от источника постоянного напряжения, при этом световой ток фоторезистора должен быть достаточным для срабатывания электромагнитного реле. В этом случае при освещении фоторезистора контакты реле в цепи управления замыкаются и лампочка начинает светиться.

- Фоторезисторы осуществляют функции датчиков контроля за обрывом различных изоляционных лент, бумаги и т.п. При сборке электрических машин используются устройства с фоторезисторами типа ФСК для разбраковки подшипников.

- Фоторезисторы применяются в фотоэлектрических пирометрах (оптических устройствах для бесконтактного измерения температуры), где интенсивность светового потока и спектральное распределение являются функциями измеряемой температуры.

- Фоторезисторы успешно применяются также в схемах измерения прозрачности жидкости и газовых сред (дымномеры, фотопылемеры, рефрактометры, колориметры).

- Широкое применение фоторезисторы нашли в области автоматизации производственных процессов, где их используют для измерения качества поверхности (шероховатости) и в приборах для контроля размеров деталей, линейных размеров и перемещений. Так, например, фоторезисторы ФСК-6 и ФСА-6 применяют в фотокопирах, позволяющих обрабатывать детали по чертежу.

Задание 1. Измерить (снять) зависимость фототока от напряжения при постоянной освещённости (вольт-амперная характеристика).

1. Собрать электрическую схему, приведенную на рис.10.

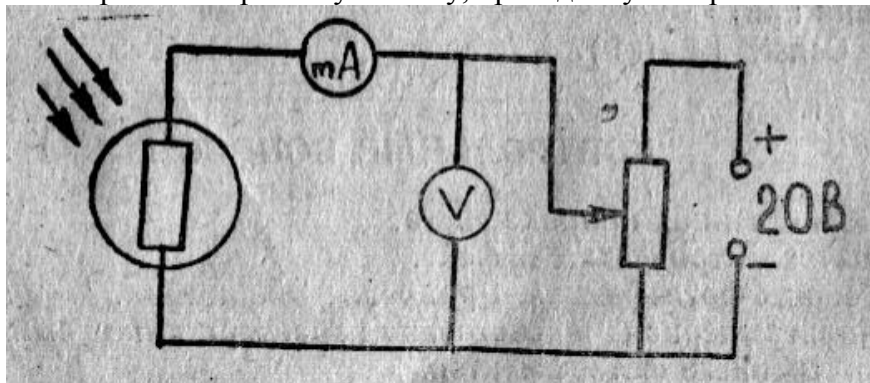


Рис.10

2. На некотором расстоянии от лампы (осветителя) установить фоторезистор (микроамперметр не должен зашкаливать), и, изменяя напряжение от 0 до 20 В через каждые 2 В, записать показания микроамперметра в делениях шкалы.

3. Изменить положение фоторезистора относительно лампы (осветителя), и, снова, изменяя напряжение, записать показания микроамперметра.

4. Построить графики зависимости $I_\phi = f(U)$ при постоянном световом потоке $\Phi = \text{const}$.

Задание 2. Измерить (снять) световую характеристику фоторезистора.

1. На некотором расстоянии от лампы установить фоторезистор. Подать напряжение 12 В, записать показания микроамперметра в делениях шкалы.

2. Изменяя расстояние между фоторезистором и лампой на 5 см каждый раз и оставляя напряжение на фоторезисторе неизменным, записать показания микроамперметра.

3. Для каждого наблюдения (измерения) рассчитать значение светового потока Φ , падающего на фоторезистор, по формуле:

$$\Phi = E \cdot S$$

где Φ - световой поток (в лм, люменах); E - освещённость (в лк), S - площадь рабочей площадки фоторезистора (в м^2).

4. Построить график зависимости фототока от светового потока $I_\phi = f(\Phi)$ при постоянном напряжении $U = \text{const}$.

5. Определите отношение темнового сопротивления фоторезистора к световому сопротивлению $R_m / R_{св}$ (при напряжении 20 В) для светового потока, соответствующему расстоянию $r = 30$ см от источника света.

6. Сделать выводы по работе и ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое фотон? Формула энергии фотона.
2. Что называется внутренним фотоэффектом?
3. Что происходит в полупроводнике при внутреннем фотоэффекте? Механизм этого явления.
4. Возможно ли возникновение внутреннего фотоэффекта в полупроводнике, если энергия фотонов падающего на него света: $h\nu < E_g$, $h\nu > E_g$, $h\nu = E_g$?
5. Что называется фотопроводимостью?
6. Какое устройство называется фоторезистором? Принцип его работы и конструкция.
7. Какие полупроводниковые материалы используют для изготовления фоторезисторов?
8. Основные характеристики и параметры фоторезисторов?
9. Применение фоторезисторов. Схема фотореле на фоторезисторе.

1.4 Лабораторная работа № ЛР- 4 (2 часа)

Тема: «Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода, полупроводниковые выпрямители переменного тока»

Часть 1. «Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода»

1.4.1 Цель работы: Изучение вольт-амперной характеристики полупроводникового диода.

1.4.2 Задачи работы:

1. Измерение зависимости прямого тока диода от величины приложенного к нему напряжения (прямой ветви вольт-амперной характеристики).
2. Измерение зависимости обратного тока диода от величины приложенного к нему напряжения (обратной ветви вольт-амперной характеристики диода).
3. Построить график вольт-амперной характеристики диода.

1.4.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. полупроводниковый диод,
2. источник постоянного напряжения,
3. реостат (потенциометр),
4. вольтметр и миллиамперметр (или цифровые мультиметры),
5. соединительные провода.

1.4.4 Описание (ход) работы:

1. Изучить теоретическое введение и записать основные сведения о формировании, структуре и свойствах электронно-дырочного перехода.

В электронной технике полупроводниковые приборы играют огромную роль. Во многих полупроводниковых приборах имеется один или несколько электронно-дырочных переходов.

Электронно-дырочным переходом или $p - n$ переходом (пэ-эн переходом) называют границу раздела областей полупроводника с различным типом электрической проводимости. Одна область полупроводника (p – область) имеет дырочную проводимость, другая область (n – область) обладает электронной проводимостью. В полупроводнике n -типа основными носителями заряда являются электроны; их концентрация значительно превышает концентрацию дырок ($n \gg p$). В полупроводнике p -типа основными носителями заряда являются дырки ($p \gg n$).

При контакте двух полупроводников p - и n -типов начинается процесс диффузии. Дырки из p -области, где их много, переходят в n -область, где их мало. Электроны, наоборот, из n -области перемещаются в p -область. В результате в n -области вблизи контакта уменьшается концентрация электронов и возникает положительно заряженный слой, состоящий из положительных ионов донорных атомов. В p -области уменьшается концентрация дырок и возникает отрицательно заряженный слой, образованный отрицательными ионами акцепторной примеси. Таким образом, в области контакта полупроводников образуется двойной электрический слой, электрическое поле которого препятствует процессу диффузии электронов и дырок навстречу друг другу. Этот слой часто называют **запирающим или запиорным**, его толщина от нескольких десятых долей микрона до микрона. Объемные заряды этого слоя создают между p - и n -областями напряжение U , приблизительно равное $0,35 В$ для германиевых $p - n$ -переходов и $0,5 - 0,6 В$ для кремниевых $p - n$ -переходов.

Электронно – дырочный переход обладает свойством односторонней проводимости.

Если полупроводник с $p - n$ переходом подключен к источнику тока так, что положительный полюс источника (плюс) соединен с n -областью, а отрицательный полюс (минус) соединен с p -областью, то напряженность электрического поля в запирающем слое возрастает. Переход основных носителей заряда через границу раздела этих областей будет ещё больше затруднён. Ток через $p - n$ -переход практически не идет. Напряжение данной полярности, поданное на $p - n$ -переход, в этом случае называют обратным, как и ток, текущий через него. Незначительный обратный ток обусловлен наличием небольшой концентрации неосновных носителей заряда, свободных электронов в p -области и дырок в n -области. Этот ток (обратный) очень мало и слабо увеличивается при увеличении обратного напряжения. При таком включении внешнего напряжения переход представляет собой большое сопротивление, а ток и приложенное напряжение условно считают отрицательными.

Если $p - n$ – переход соединить с источником так, чтобы «плюс» источника был соединен с p -областью, а « минус» - с n -областью, то напряженность поля в запирающем слое будет уменьшаться, что облегчает переход основных носителей через контактный слой. Дырки из p -области и электроны из n -области, двигаясь навстречу друг другу, будут пересекать $p - n$ – переход, создавая ток в прямом направлении. Сила тока через $p - n$ – переход в этом случае будет возрастать при увеличении напряжения источника.

Зависимость силы тока, текущего через $p - n$ –переход, от величины приложенного к нему напряжения называется вольт – амперной характеристикой и приблизительно описывается выражением

$$I = I_n \cdot [\exp(eU / nkT) - 1]$$

где I - сила тока через, I_n – ток насыщения, U – внешнее напряжение на $p - n$ – переходе, T – температура, k – постоянная Больцмана, n – фактор идеальности $p - n$ – перехода, e – элементарный заряд. График вольт-амперной характеристики кремниевого $p - n$ –перехода показан на рис.1.

Изготовление. $p - n$ – Переходы изготавливают введением небольшого количества примеси в тонкий поверхностный слой полупроводника. По способу изготовления различают сплавные и диффузионные $p - n$ – переходы. Для образования сплавного $p - n$ – перехода на поверхность полупроводникового кристалла помещают электронный материал – металл или сплав; система нагревается до температуры, при которой осуществляется сплавление, и после небольшой выдержки охлаждается. Диффузионный $p - n$ – переход получают диффузией примеси в полупроводник.

В данной работе нужно исследовать зависимость прямого и обратного тока германиевого плоскостного диода Д 7 от величины приложенного к нему напряжения и построить график этой зависимости (вольт-амперной характеристики). Конструкция сплавного маломощного германиевого диода Д 7 показана на рисунке 6. Основной элемент диода – пластинка монокристаллического германия 5. В одну сторону пластинки вплавлен шарик индия 4. В результате в пластинке, имевшей вначале электронную проводимость, образовалась область германия с дырочной проводимостью и на границе раздела исходного германия n – типа и слоя германия p – типа возник $p - n$ – переход. С другой стороны пластинка припаяна припоем с примесью сурьмы 8 к основанию металлического корпуса 6, защищающего кристалл от внешних воздействий и имеющего внешние выводы 1 и 7. Металлическая трубка 2 вплавлена в стеклянный изолятор 3.

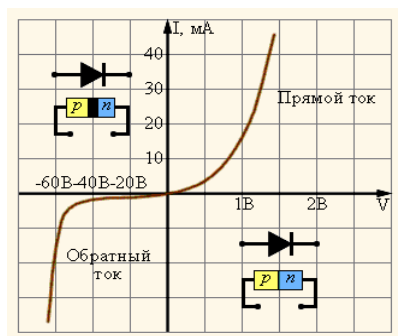


Рис.1. Вольт-амперная характеристика кремниевого $p - n$ перехода

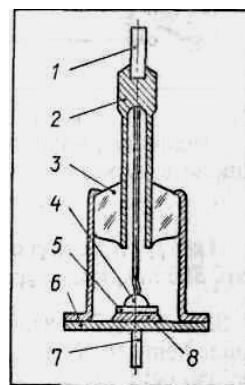


Рис.2. Конструкция сплавного германиевого диода

Задание 1. Измерение зависимости прямого тока диода от величины приложенного к нему напряжения (прямой ветви вольт-амперной характеристики).

1. Подготовьте в тетради таблицы 1 и 2 для записи результатов измерений.

Таблица 1,2

$U, В$									
I, mA									

2. Соберите электрическую цепь, показанную на рис.3. Диод включите в прямом

(пропускном) направлении, обратив внимание на знаки $+$ и $-$, указанные на его панели. Зарисуйте схему электрической цепи в тетради.

Источником тока в работе служит источник постоянного напряжения (ИН), имеющий на выходе регулируемое постоянное напряжение от 0 до 12 В. Напряжение на диод подается с потенциометра R и измеряется вольтметром, включенном на предел 2 или 3 В. Прямой ток измеряется цифровым мультиметром, включенном вначале на предел 20 мА, а затем на предел 200 мА.

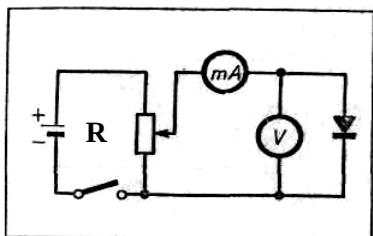


Рис.3

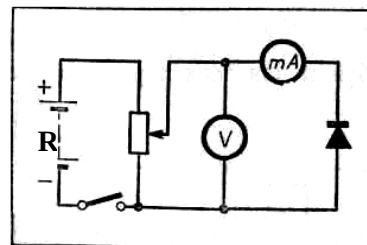


Рис. 4

3. Установите ручкой плавной регулировки источника тока напряжение, подаваемое на потенциометр R , 6 – 12 В. Напряжение на диод поступает с потенциометра R . Его величина зависит от величины выходного напряжения источника тока и положения подвижного контакта потенциометра. Перемещая подвижный контакт потенциометра и при необходимости регулятор напряжения источника тока, увеличивайте прямое напряжение на диоде от нуля до 0,5 – 0,6 В с шагом примерно 0,02 – 0,04 В. Запишите показания обоих приборов, то есть значения силы тока I и напряжения U , в таблицу 1. Сила тока при увеличении напряжения на диоде будет постепенно, а затем резко возрастать.

Внимание. Прямой ток диода не должен превышать 250 – 300 мА.

Задание 2. Измерение зависимости обратного тока диода от величины приложенного к нему напряжения (обратной ветви вольт-амперной характеристики диода).

1. Соберите электрическую цепь по новой схеме (рис.4), обратив внимание на отличие включения диода и вольтметра. Зарисуйте схему цепи в тетради.

2. Установите выходное напряжение источника тока 12 В, то есть максимальное значение. Напряжение на диод поступает с потенциометра R и измеряется вольтметром, включенном на предел 15 или 20 В. Сила обратного тока измеряется цифровым мультиметром в режиме измерения постоянного тока на пределе 2000 мкА. 3. Увеличивая обратное напряжение на диоде (с помощью потенциометра) от 0 до 12 В с шагом 1 В, измерьте величину обратного тока диода. Результаты измерений запишите в таблицу 2.

Задание 3. Построить график вольт-амперной характеристики диода.

1. По данным двух таблиц постройте график зависимости силы тока, текущего через диод от приложенного напряжения, то есть график вольт-амперной характеристики диода. Прямой ток и прямое напряжение считайте положительными величинами, а обратный ток и обратное напряжение – отрицательными. По оси абсцисс откладывайте напряжение в вольтах, а по оси ординат – силу тока в миллиамперах. Масштаб для прямого напряжения можно взять 1 см – 0,1 В, для обратного 1 см – 1 В. Масштаб для прямого тока 1 см – 10 мА, для обратного тока 1 см – 0,1 мА.

2. Используя построенную вольт – амперную характеристику диода, определите его сопротивление в прямом R_n и обратном направлениях R_o при напряжении $U = 0,5$ В и вычислите их отношение R_o / R_n .

3. Сделайте вывод об основных свойствах полупроводникового диода.

Контрольные вопросы

1. Полупроводники и их свойства. Примеры полупроводниковых веществ.
2. Свободные носители заряда в полупроводниках.
3. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
4. Электронно-дырочный переход. Его вольт-амперная характеристика, график и уравнение вольт-амперной характеристики.
5. Полупроводниковый диод, его конструкция, свойства и назначение.

Часть 2. «Полупроводниковые выпрямители переменного тока»

1.4.1 Цель работы: ознакомиться с выпрямительными схемами переменного тока.

1.4.2 Задачи работы:

1. Ознакомиться с устройством и работой однополупериодного выпрямителя;
2. Ознакомиться с устройством и работой двухполупериодного выпрямителя.

1.4.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. полупроводниковый диод,
2. диодный мост
3. источник переменного напряжения (частотой 50 Гц, сетевое напряжение)
4. реостат (потенциометр),
5. резистор сопротивлением 100 Ом,
6. конденсаторы ёмкостью 100, 220, 470, 1000 мкФ,
7. электронный осциллограф С1-112м
8. соединительные провода.

1.4.4 Описание (ход) работы:

1. Изучить теоретическое введение и записать основные сведения о структуре и свойствах электронно-дырочного перехода.

В электронной технике полупроводниковые приборы играют огромную роль. Во многих полупроводниковых приборах имеется один или несколько электронно-дырочных переходов.

Электронно-дырочным переходом или $p - n$ переходом (пэ-эн переходом) называют границу раздела областей полупроводника с различным типом электрической проводимости. Одна область полупроводника (p – область) имеет дырочную проводимость, другая область (n – область) обладает электронной проводимостью. В полупроводнике n -типа основными носителями заряда являются электроны; их концентрация значительно превышает концентрацию дырок ($n \gg p$). В полупроводнике p -типа основными носителями заряда являются дырки ($p \gg n$).

При контакте двух полупроводников p - и n -типов начинается процесс диффузии. Дырки из p -области, где их много, переходят в n -область, где их мало. Электроны, наоборот, из n -области перемещаются в p -область. В результате в n -области вблизи контакта уменьшается концентрация электронов и возникает положительно заряженный слой, состоящий из положительных ионов донорных атомов. В p -области уменьшается концентрация дырок и возникает отрицательно заряженный слой, образованный отрицательными ионами акцепторной примеси. Таким образом, в области контакта полупроводников образуется двойной электрический слой, электрическое поле которого препятствует процессу диффузии электронов и дырок навстречу друг другу. Этот слой часто называют **запирающим или запиорным**, его толщина от нескольких десятых долей микрона до микрона. Объемные заряды этого слоя создают между p - и n -областями напряжение U , приблизительно равное $0,35 В$ для германиевых $p - n$ - переходов и $0,5 - 0,6 В$ для кремниевых $p - n$ - переходов.

Электронно – дырочный переход обладает свойством односторонней проводимости.

Если полупроводник с $p - n$ переходом подключен к источнику тока так, что положительный полюс источника (плюс) соединен с n -областью, а отрицательный полюс (минус) соединен с p -областью, то напряженность электрического поля в запирающем слое возрастает. Переход основных носителей заряда через границу раздела этих областей будет ещё больше затруднён. Ток через $p - n$ -переход практически не идет. Напряжение данной полярности, поданное на $p - n$ -переход, в этом случае называют обратным, как и ток, текущий через него. Незначительный обратный ток обусловлен наличием небольшой концентрации неосновных носителей заряда, свободных электронов в p -области и дырок в n -области. Этот ток (обратный) очень мало и слабо увеличивается при увеличении обратного напряжения. При таком включении внешнего напряжения переход представляет собой большое сопротивление, а ток и приложенное напряжение условно считают отрицательными.

Если $p - n$ - переход соединить с источником так, чтобы «плюс» источника был соединен с p -областью, а «минус» - с n -областью, то напряженность поля в запирающем слое будет уменьшаться, что облегчает переход основных носителей через контактный слой. Дырки из p -области и электроны из n -области, двигаясь навстречу друг другу, будут пересекать $p - n$ - переход, создавая ток в прямом направлении. Сила тока через $p - n$ - переход в этом случае будет возрастать при увеличении напряжения источника.

Зависимость силы тока, текущего через $p - n$ -переход, от величины приложенного к нему напряжения называется вольт – амперной характеристикой и приблизительно описывается выражением

$$I = I_n \cdot [\exp(eU / nkT) - 1]$$

где I - сила тока через, I_n – ток насыщения, U – внешнее напряжение на $p - n$ - переходе, T – температура, k – постоянная Больцмана, n – фактор идеальности $p - n$ - перехода, e – элементарный заряд. График вольт-амперной характеристики кремниевого $p - n$ -перехода показан на рис.1.

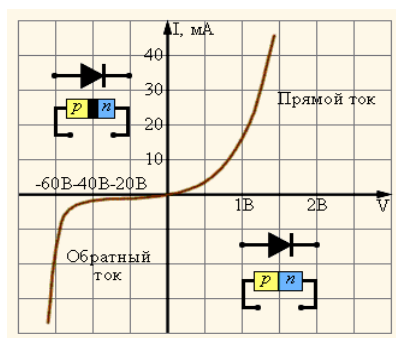


Рис.1. Вольт-амперная характеристика кремниевого $p - n$ перехода

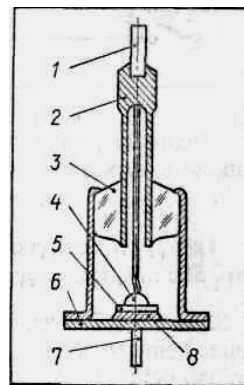


Рис.2. Конструкция сплавного германиевого диода

2. Одним из первых применений полупроводникового диода является выпрямление переменного тока.

Полупроводниковый диод – двухэлектродный полупроводниковый прибор, содержащий один электронно-дырочный переход и два вывода. Заключён в герметичный корпус, защищающий прибор от внешних воздействий (влаги, пыли, света). Основное свойство –односторонняя проводимость электрического тока. Конструкция сплавного германиевого диода показана на рис.2.

Выпрямление переменного тока – преобразование изменяющегося, переменного тока или напряжения в постоянное по направлению (полярности) и величине.

Широко распространены полупроводниковые схемы, состоящие собственно из выпрямителя, преобразующего переменное напряжение в пульсирующее, и дополнительного устройства, уменьшающего изменения величины уже выпрямленного напряжения. Это устройство называется сглаживающий фильтр. Простейший сглаживающий фильтр – это конденсатор достаточно большой ёмкости, подключенный параллельно выходу выпрямителя.

В работе изучаются две выпрямительные схемы: однополупериодная, содержащая один полупроводниковый диод, и диодный мост, состоящий из четырёх полупроводниковых диодов.

Задание 1. Однополупериодное выпрямление переменного тока

1. Соберите схему, показанную на рис.3, и подключите электрический сигнал с резистора R ко входу осциллографа. Наблюдайте осциллограмму в виде синусоиды частотой 50 Гц. Зарисуйте осциллограмму.

2. Включите в цепь диод, как показано на рис.4, и наблюдайте осциллограмму, «обрезанную» снизу. Измените направление включения диода (рис.5) и наблюдайте осциллограмму, «обрезанную» сверху. Зарисуйте осциллограммы.

3. Затем в цепь параллельно резистору R включают конденсатор ёмкостью 100 мкФ и наблюдают сглаженную осциллограмму (рис.6). При включении конденсаторов большей ёмкости (220, 470 и 1000 мкФ) осциллограмма становится всё более сглаженной (рис.7). Конденсатор C является сглаживающим фильтром, уменьшающим колебания (изменения) выпрямленного, пульсирующего напряжения. Зарисуйте

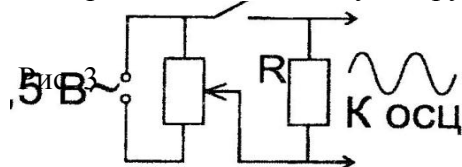


Рис. 4

осциллограммы.

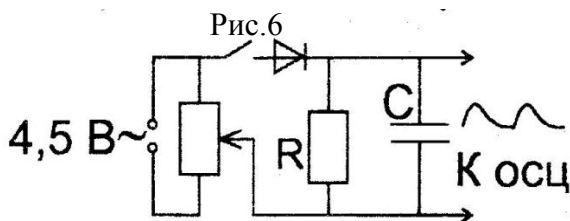
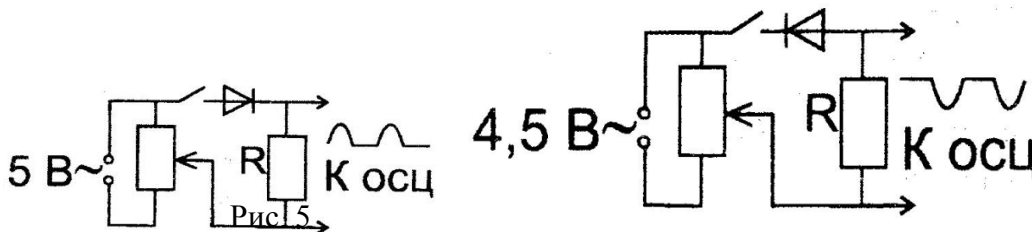


Рис.7



Задание 2. Двухполупериодное выпрямление переменного тока

1. Соберите схему, показанную на рис.8, и подключите электрический сигнал с резистора R ко входу осциллографа. Наблюдайте осциллограмму с частотой пульсаций 100 Гц (рис. 8). Зарисуйте осциллограмму.

2. Параллельно резистору R включите в цепь конденсатор ёмкостью 100 мкФ и наблюдайте сглаженную осциллограмму (рис. 9).

3. При замене конденсатора на конденсаторы большей ёмкости (от 100 до 1000 мкФ) сглаженность осциллограммы становится всё больше, а осциллограмма – всё более прямой (рис.10).

4. Сделайте выводы о проделанной работе, о свойствах диодов

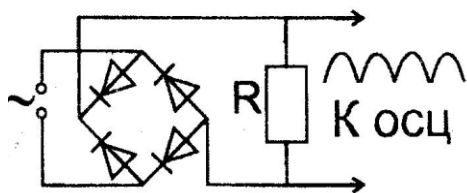


Рис. 8

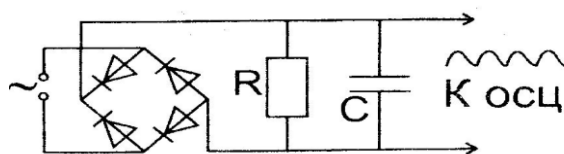


Рис. 10

Контрольные вопросы

1. Электронно-дырочный переход. Его вольт-амперная характеристика, график и уравнение вольт-амперной характеристики.
2. Полупроводниковый диод, его конструкция и свойства
3. Что называют выпрямлением переменного тока? Выпрямителем переменного тока?
4. Однополупериодный выпрямитель переменного напряжения. Схема и работа.
5. Двухполупериодный выпрямитель переменного напряжения (мостовая схема).
6. Сглаживающий фильтр, его назначение.

1.5 Лабораторная работа № ЛР- 5 (2 часа).

Тема: «Фотоэлектрический метод преобразования солнечного света, измерение нагрузочной вольт-амперной характеристики солнечной батареи»

Часть 1. «Фотоэлектрический метод преобразования солнечного света»

1.5.1 Цель работы: Ознакомиться с фотоэлектрическим методом преобразования энергии солнечного света в электрическую энергию.

1.5.2 Задачи работы:

1. Некоторые величины, характеризующие солнечное излучение
2. Ознакомиться с фотоэлектрическим методом преобразования энергии солнечного света в электрическую энергию.

1.5.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Учебная солнечная батарея и солнечные фотопреобразователи;
2. Осветитель;
3. Микровентилятор;
4. Звуковой сигнализатор;
5. Блок светодиодный;
6. Цифровой мультиметр;
7. Соединительные провода;

1.5.4 Описание (ход) работы:

1. Изучить теоретическое введение и записать определения основных величин, характеризующих солнечное излучение.

Светом или оптическим излучением называются электромагнитные волны (электромагнитное излучение), у которых длина волны в вакууме λ занимает диапазон от 10 нм до 1 мм. Этот спектральный диапазон делят на три области.

Для Земли примерное расстояние до Солнца составляет $150 \cdot 10^6$ км и средняя плотность лучистой энергии на земной орбите, у границы земной атмосферы, равняется $\Phi_0 = 1370 \text{ Вт/м}^2$. Эта величина называется **солнечной постоянной**.

Некоторые величины, характеризующие солнечное излучение

1. Энергия излучения (волн) часто обозначается буквами W или Q_e и измеряется в джоулях (Дж).

2. Поток излучения Φ_e – величина, равная энергии электромагнитного излучения, проходящего в единицу времени через некоторую поверхность S .

Φ_e представляет собой мощность излучения, излучаемого телом и распространяющегося в пространстве. Единица измерения – ватт (Вт). Определяется как отношение энергии излучения W ко времени t , за которое излучение произошло.

$$\Phi = W / t \quad (2)$$

3. Энергетическая освещённость (облучённость) E_e – величина, которая характеризует величину потока излучения, падающего на единицу площади освещаемой поверхности. Единица измерения – 1 Вт/м^2 .

Освещённость поверхности зависит от угла падения α . При нормальном падении потока излучения Φ_0 на поверхность S она определяется как отношение этих величин.

$$E_0 = \Phi_0 / S \quad (3)$$

При наклонном падении (рис.1) на ту же самую поверхность S освещённость E этой поверхности меньше и определяется выражением

$$E = E_0 \cdot \cos \alpha \quad (4)$$

где E_0 – освещённость при нормальном падении излучения (света),

α – угол падения, то есть угол между направлением распространения излучения и нормалью к поверхности.

Это означает, что при освещении земной поверхности солнечным светом, количество солнечной энергии падающей (поступающей) на неё зависит от угла наклона солнечных лучей. В соответствии с (4) поток солнечного излучения Φ , падающего на поверхность площадью S , определяется выражением

$$\Phi = \Phi_0 \cdot \cos \alpha = E_0 \cdot S \cdot \cos \alpha \quad (5)$$

Тогда энергия солнечного света, поступающая на эту поверхность за время t , равна

$$W = \Phi_0 \cdot t \cdot \cos \alpha = E_0 \cdot S \cdot t \cdot \cos \alpha \quad (6)$$

4. Солнечная инсоляция. Количество попадающего на освещаемую поверхность потенциально полезного солнечного излучения определяется понятием, именуемым **инсоляцией**. Обозначим её здесь, как W_s .

Солнечная инсоляция W_s – это суммарная энергия солнечного излучения, попадающего на единицу площади горизонтальной поверхности, определённая за достаточно длительный период времени (сутки, неделя, месяц, год). Единица измерения – $1 \text{ кВт} \cdot \text{час/м}^2$.

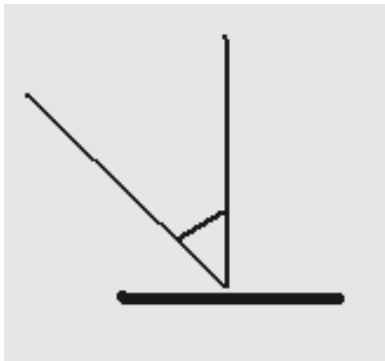


Рис. 1
Наклонное падение света

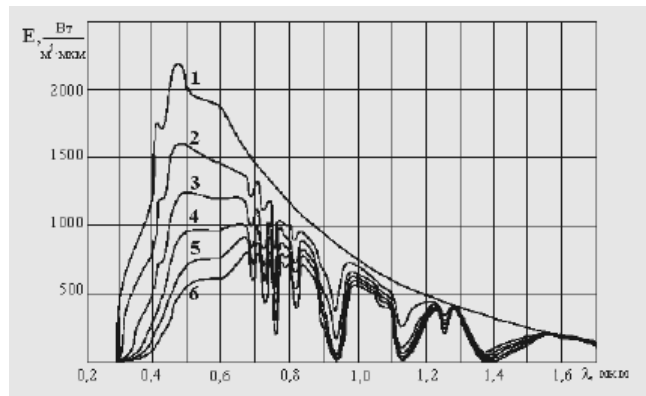


Рис.2 – Спектральное распределение энергии солнечного излучения вне земной атмосферы (1) и на поверхности земли для различных положений Солнца над горизонтом (2,3,4,5,6). 1 мкм = 1000 нм.

Солнечная инсоляция сильно изменяется от одной точки земной поверхности к другой, то есть зависит от географического положения местности. Очевидно, что степи Астрахани, пустыня Сахара получают значительно больше света, чем Петрозаводск или Санкт-Петербург.

При нахождении величины солнечной инсоляции какого-либо района необходимо учитывать также несколько факторов:

- влияние времени года, обуславливающее более низкую освещенность и долготу дня зимой;
- характер местности, освещаемой солнцем (наличие загораживающих солнце деталей рельефа местности, такие как горы, деревья, здания);
- местные погодные условия (облачность, туман, дождь);

Годовая солнечная инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки в разных городах России (в МВт·час/м²)

Архангельск - 0.85
Новосибирск - 1.14
Петербург - 0.93
Екатеринбург - 1.1

Омск - 1.26
Ростов на Дону - 1.29
Москва - 1.01
Астрахань - 1.38

5. Спектр солнечного излучения (или спектральное распределение) – это зависимость мощности (или плотности потока излучения) солнечного излучения от длины волны λ .

Плотность потока излучения – это мощность электромагнитного излучения, проходящего через единицу площади поверхности, расположенной перпендикулярно направлению распространения электромагнитной волны

$$\Phi_e / S = W / S \cdot t$$

Солнечный свет представляет собой непрерывный набор электромагнитных волн с разной длиной волны или разной частоты. Интенсивность этих волн в солнечном спектре разная. Спектр солнечного излучения представлен на рис. 2. Солнечный спектр вне земной атмосферы примерно соответствует спектру излучения абсолютно чёрного тела с температурой 5800 К (кривая 1 на рис.2) и имеет максимум при $\lambda = 555 - 560$ нм.

Спектр солнечного излучения, наблюдаемый на Земле, заметно изменён (кривая 2 на рис.2). При прохождении через атмосферу солнечный свет ослабляется в основном благодаря поглощению инфракрасного излучения парами воды, поглощению ультрафиолетового излучения озоном (O_3) и рассеянию излучения находящимися в воздухе частицами пыли и аэрозолями.

Показатель атмосферного влияния на интенсивность солнечного излучения, доходящего до земной поверхности, определяется “атмосферной массой” (АМ). “Атмосферная масса” для любого уровня земной поверхности в любой момент дня

определяется по формуле
$$AM = \frac{y}{y_0} \cdot \frac{1}{\sin \vartheta} \quad (7)$$
 где y – атмосферное давление, y_0 – нормальное атмосферное давление (101.3 кПа), ϑ – угол высоты Солнца над горизонтом земного шара (рисунок 3).

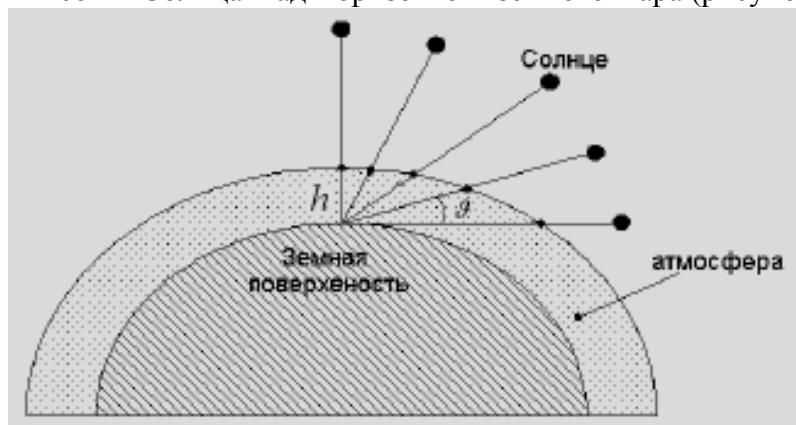


Рис. 3 – Расстояние, проходимое в атмосфере солнечными лучами при различных положениях Солнца над горизонтом, которое характеризуется углом ϑ .

II. Фотоэлектрический метод преобразования солнечной энергии

Фотопреобразователем солнечной энергии (ФЭП) называется полупроводниковое устройство, которое позволяет превращать энергию солнечного излучения непосредственно в электроэнергию, минуя стадии тепловой и механической форм энергии.

Другие, часто применяемые названия этих устройств: фотоэлемент, солнечный фотоэлемент, солнечный элемент (от solar cell).

Работа солнечного фотопреобразователя основана на внутреннем фотоэффекте в полупроводниковой структуре, содержащей внутреннее электрическое поле (например, электронно-дырочный переход). Другое, более раннее название процессов при фотопреобразовании - вентильный фотоэффект.

Солнечный ФЭП наиболее простой конструкции представляет собой полупроводниковый кристалл, состоящий из двух слоев (областей) с различным типом проводимости (электронный – n, дырочный – p). Конструкция солнечного ФЭП на p-n – переходе показана на рис. 4.

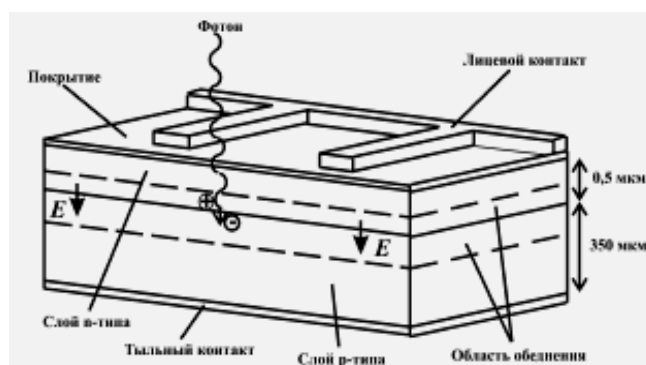


Рис. 4 - Схема кремниевого монокристаллического солнечного элемента (ФЭП).

Слой р-типа имеет толщину 0,35 мм, р-п-переход залегает на глубине 0,5 мкм от верхней освещаемой поверхности, лицевой и тыльный контакты-металлические токоотводы, пунктиром обозначена область обеднения (или запирающий слой).

Принципиальную роль играет встроенное электрическое поле, которое возникает вблизи границы раздела р- и п- областей полупроводника и выделено на рис. 4 пунктиром.

Электроны, перешедшие из п-области в р-область, рекомбинируют с дырками вблизи границы раздела. Аналогично рекомбинируют дырки, перейдя из р-области в п-область. В результате вблизи р-п-перехода практически не остается свободных носителей заряда (электронов и дырок).

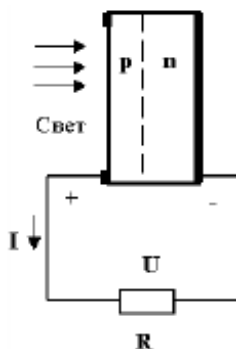


Рис.5 – Схема ФЭП, соединённого с нагрузкой (R). Показаны полярность напряжения и направление тока.

Принцип действия ФЭП. Оптическое (солнечное) излучение, поглощаемое в полупроводниковой структуре с р-п-переходом, создает свободные пары “электрон-дырка” при условии, что энергия фотона $h\nu$ превышает ширину запрещенной зоны полупроводника E_g .

Свободные электроны и дырки возникают как в р- и п- областях перехода, так и в непосредственной близости к запирающему слою.

Существующее в запирающем слое электрическое поле разделяет созданные светом свободные носители заряда в зависимости от их знака: свободные электроны перемещаются в п-область перехода, а дырки перемещаются в р- область, что приводит к зарядке этих областей.

При разомкнутой внешней цепи (ФЭП не подключен к нагрузке) электроны и дырки, концентрирующиеся соответственно в п- и р- областях, приводят к разности потенциалов, смещающей р-п переход в прямом направлении. Если же ФЭП подключен к внешней электрической цепи, то создаваемые при освещении избыточные электроны и дырки приведут к возникновению во внешней цепи электрического тока.

Разделение зарядов встроенным электрическим полем характеризуют электродвижущей силой, называемой фотоэдс, а ток во внешней цепи называют фототоком.

Таким образом, во время освещения ФЭП происходит преобразование энергии квантов света (фотонов) в энергию движущих во внешней цепи электрических зарядов.

Схема освещённого ФЭП, соединённого с внешней цепью (нагрузкой R) показана на рис.5. Показаны полярность напряжения и направление тока, текущего (при освещении) во внешней цепи от р-области к п-области.

Эффективность преобразования (к.п.д.) фотопреобразователя.

Важнейшая характеристика ФЭП – это коэффициент полезного действия η , который определяет эффективность преобразования солнечного излучения в электрическую энергию.

К.п.д. фотопреобразователя η называют отношение максимальной электрической мощности P_m , выделяемой при освещении в нагрузке, к потоку Φ падающего солнечного излучения, то есть к мощности солнечного излучения.

Обычно к.п.д. выражают в процентах. Большинство промышленных солнечных фотопреобразователей изготавливают из монокристаллического и поликристаллического кремния. К.п.д. современных кремниевых ФЭП составляет примерно 14 - 18 %.

Для создания энергетических устройств с нужными характеристиками (напряжение, сила тока, мощность) солнечные ФЭП-ы соединяют в солнечные батареи, применяя последовательное, параллельное или последовательно-параллельное соединения.

Выполнение заданий

1. Подключив поочерёдно к освещённой солнечной батарее микровентилятор, звуковой сигнализатор, светодиодный блок, наблюдайте за их работой. Отметьте, в какие формы энергии переходит энергия света.

2. Определите количество ФЭП, образующих солнечную батарею, и способ их соединения.

3. С помощью цифрового мультиметра определите:

- полярность выходных контактов,
- величину фотоэдс и фототока короткого замыкания при расстоянии до осветителя 30 см.

4. Увеличивая расстояние между солнечной батареей и осветителем, установите (качественную) зависимость фотоэдс и фототока от освещённости. Дайте объяснение этим зависимостям.

5. Освещая батарею солнечным светом и светом осветителя, сравните значения напряжения холостого хода и фототока короткого замыкания.

Контрольные вопросы

1. Что такое свет или оптическое излучение?
2. Что называется инфракрасным, видимым и ультрафиолетовым светом?
3. Что называется солнечной постоянной и чему она равна (для Земли)?
4. Величины, характеризующие солнечное излучение (поток излучения, освещённость, солнечная инсоляция).
5. От чего зависит солнечная инсоляция?
6. Что называют фотопреобразователем солнечной энергии?
7. Устройство солнечного фотопреобразователя с р-п-переходом.
8. Принцип действия ФЭП.
9. К.п.д. фотопреобразователя солнечной энергии.
10. Основной полупроводник, применяемый для промышленного производства фотопреобразователей и солнечных батарей, и к.п.д. промышленных фотопреобразователей.

Часть 2. «Измерение нагрузочной вольт-амперной характеристики солнечной батареи»

1.5.1 Цель работы: изучение устройства и работы солнечных фотопреобразователей.

1.5.2 Задачи работы:

1. Ознакомиться с конструкцией и работой кремниевого солнечного фотопреобразователя.
2. Измерение нагрузочной вольт-амперной характеристики солнечной батареи.
3. Определение параметров солнечной батареи.

1.5.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Кремниевая солнечная батарея;
2. Осветитель;
3. Цифровые мультиметры;
4. Магазин сопротивлений;
5. Соединительные провода.

1.5.4 Описание (ход) работы:

1. Ознакомиться с конструкцией и работой кремниевого солнечного фотопреобразователя.

Солнечные фотопреобразователи (ФЭП) представляют собой полупроводниковые фотоэлектрические устройства, предназначенные для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую.

Другие, часто применяемые названия этих устройств: фотоэлемент, солнечный фотоэлемент, солнечный элемент (от solar cell).

Работа солнечного фотопреобразователя основана на внутреннем фотоэффекте в полупроводниковой структуре, содержащей внутреннее электрическое поле (например, за счёт создания электронно-дырочного перехода). Другое название - вентильный фотоэффект или фотовольтаический эффект.

Конструкция. Солнечный фотопреобразователь типичной, классической конструкции содержит р-п переход и представляет собой тонкую полупроводниковую пластину, состоящую из двух слоев (областей) с различным типом проводимости (электронный – п, дырочный – р). Структура солнечного кремниевого ФЭП с р-п – переходом показана на рис. 1, а условное обозначение - на рис.2

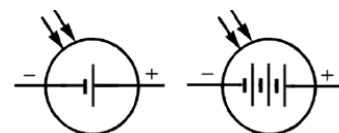
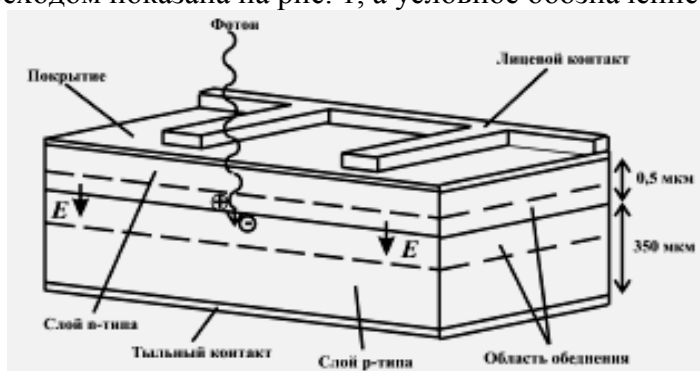


Рис.- 2

Рис. 1 – Структура кремниевого солнечного элемента (ФЭП).

Базовый слой р-типа имеет толщину 0,35 мм, р-п-переход залегает на глубине 0,5 мкм от верхней освещаемой поверхности, лицевой и тыльный контакты - металлические токоотводы, пунктиром обозначена область обеднения, то есть запирающий слой. Покрытие – антиотражающее покрытие из оксида кремния SiO_x , TiO_2 или Ta_2O_5 , которое уменьшает потери, вызванные отражением света от фронтальной поверхности.

Рис.2 – Условное обозначение солнечного фотопреобразователя и солнечной батареи.

Принцип действия ФЭП. Солнечное излучение, поглощаемое в полупроводниковой структуре с р-п-переходом, создает свободные пары “электрон-

дырка” при условии, что энергия фотона $h\nu$ превышает ширину запрещенной зоны полупроводника E_g .

Свободные электроны и дырки возникают как в р- и п- областях перехода, так и в непосредственной близости к запирающему слою. Существующее в запирающем слое сильное электрическое поле разделяет созданные светом свободные носители заряда в зависимости от их знака: свободные электроны перемещаются в п-область, а дырки перемещаются в р- область, что приводит к зарядке этих областей.

При разомкнутой внешней цепи (ФЭП не подключен к нагрузке) электроны и дырки, концентрирующиеся соответственно в п- и р- областях, приводят к разности потенциалов, смещающей р-п переход в прямом направлении. Если же ФЭП подключен к внешней электрической цепи, то создаваемые при освещении избыточные электроны и дырки приведут к возникновению во внешней цепи электрического тока.

Разделение зарядов встроенным электрическим полем характеризуют электродвижущей силой, называемой фотоэдс, а ток во внешней цепи называют фототоком.

Таким образом, во время освещения ФЭП происходит преобразование энергии квантов света (фотонов) в энергию движущих во внешней цепи электрических зарядов.

Схема освещённого ФЭП, соединённого с внешней цепью (нагрузкой R) показана на рис.3. Показаны полярность напряжения и направление тока, текущего при освещении во внешней цепи от р-области к п-области. Направление фототока совпадает с направлением слабого обратного тока, текущего при подаче обратного напряжения.

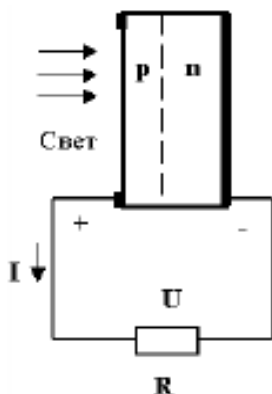


Рис. 3 - Схема ФЭП, соединённого с нагрузкой R . Показаны полярность и направление тока.

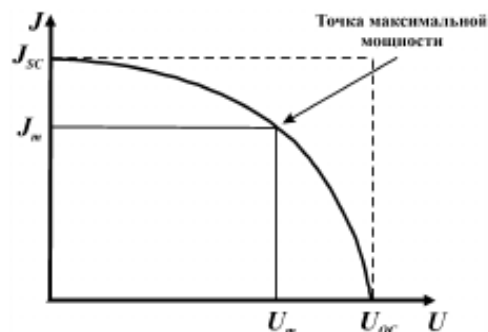


Рис. 4 - Нагрузочная вольт-амперная характеристика солнечного фотопреобразователя при освещении.

IV. Основные параметры. Солнечные фотопреобразователи работают только в фотовольтном режиме, то есть в качестве генераторов тока, электрических батарей или других подобных источников питания. Основными параметрами ФЭП являются:

1. $P_{\max}$ - максимальная электрическая мощность, отдаваемая в нагрузку при освещении;

2. η (к.п.д.) - отношение максимальной электрической мощности $P_{\max}$, выделяемой при освещении в нагрузке, к потоку Φ падающего солнечного излучения, то есть к мощности солнечного излучения, падающего на поверхность ФЭПа.

$$\eta = P_{\max} / \Phi = I_{\max} \cdot U_{\max} / \Phi \quad (1)$$

3. U_{xx} - напряжение холостого хода (фотоэдс или э.д.с. разомкнутой цепи);

4. $I_{кз}$ - ток короткого замыкания (максимальный фототок);

5. f - коэффициент заполнения вольт-амперной характеристики, который определяется выражением

$$f = P_{\text{макс}} / I_{\text{кз}} \cdot U_{\text{хх}} \quad (2)$$

6. $R_{\text{посл}}$ - последовательное сопротивление.

Вольт-амперная характеристика. Важным показателем качества фотопреобразователя является нагрузочная вольт-амперная характеристика, приведенная на рис.4. Обычно её получают путём изменения величины сопротивления нагрузки, включенной последовательно с освещённым фотопреобразователем или солнечной батареей по схеме, показанной на рис. 5. По оси ординат откладывается либо сила тока I , либо плотность тока J . По горизонтальной оси откладываются значения выходного напряжения ФЭП, то есть напряжение на нагрузке U . Указывается уровень освещенности.

Как видно, зависимость силы тока от напряжения является нелинейной. При большом сопротивлении нагрузки R тока в цепи практически нет и выходное напряжение равно напряжению холостого хода $U_{\text{хх}}$. При уменьшении сопротивления нагрузки напряжение немного падает, а сила тока растёт. Затем достигается такое положение, когда с уменьшением сопротивления R выходной ток освещённого ФЭПа практически более не увеличивается. А напряжение будет постоянно уменьшаться. Как только сопротивление нагрузки R станет равным нулю, выходное напряжение упадёт до нуля. Наступит состояние короткого замыкания фотопреобразователя, которое, однако, не приводит к его выходу из строя.

Характер вольт-амперной зависимости не зависит от уровня освещённости. На рис.6 показано семейство нагрузочных характеристик кремниевого фотопреобразователя при различной энергетической освещённости. Все графики имеют одинаковую форму.

Как видно из рис.4, электрическая мощность, выделяющаяся в нагрузке и определяемая произведением $P = I \cdot U$, на рисунке представляется площадью прямоугольника. Для одного и того же фотоэлемента и освещённости в зависимости от величины сопротивления R в нагрузке каждую секунду выделяется разное количество энергии.

При некотором значении R в нём выделяется наибольшее количество энергии. Эта нагрузка является оптимальной и отвечает наибольшему к.п.д. преобразования световой энергии в электрическую. На рис. 4 этот режим отмечен точкой на графике, которой соответствуют определённые значения тока и напряжения. **Мощность, выделяемая в этом режиме является максимальной (пиковой). Численно она равна площади максимального прямоугольника, ограниченного вольт-амперной характеристикой.**

Из рисунка также видно, что максимальная возможная мощность будет тем больше, чем больше $I_{\text{кз}}$ и $U_{\text{хх}}$, а также чем ближе форма нагрузочной кривой к прямоугольнику.

Максимальную (пиковую) мощность можно представить в виде выражения (см. формулу 2):

$$P_{\text{макс}} = f \cdot I_{\text{кз}} \cdot U_{\text{хх}} \quad (3)$$

Величина f называется коэффициентом заполнения. Она показывает, какую часть площади от максимальной возможной при данных $I_{\text{кз}}$ и $U_{\text{хх}}$ (то есть при данном ФЭП и световом потоке) составляет площадь (прямоугольника), характеризующая мощность, снимаемую с фотопреобразователя. Величина f зависит от тока насыщения, фототока и сопротивления нагрузки R .

Используя коэффициент заполнения f к.п.д. преобразования можно выразить в виде:

$$\eta = I_{\text{макс}} \cdot U_{\text{макс}} / \Phi = f \cdot I_{\text{кз}} \cdot U_{\text{хх}} / \Phi \quad (4)$$

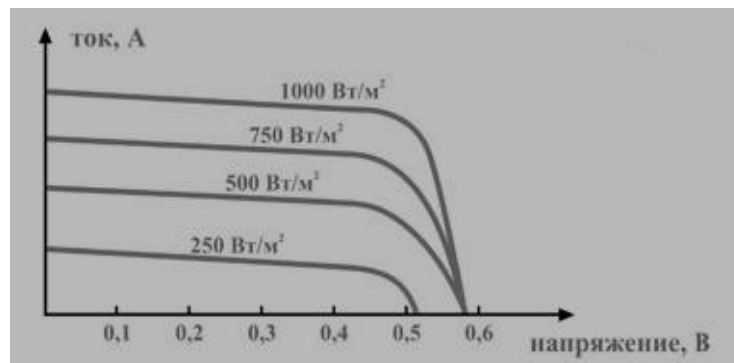


Рис.6 - Семейство нагрузочных характеристик кремниевого фотопреобразователя при различной освещённости.

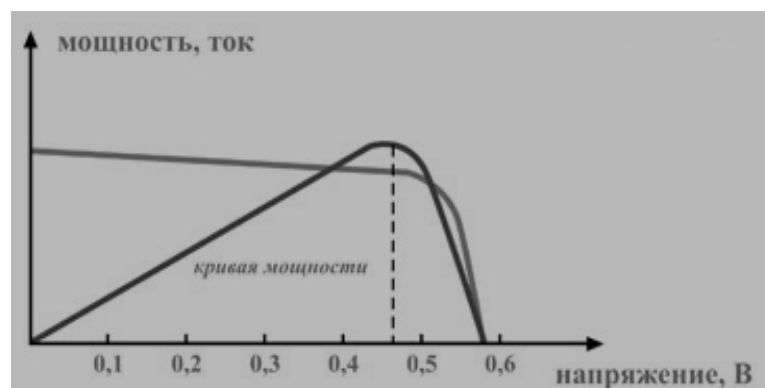


Рис.7 – График зависимости выходной мощности от напряжения для фотопреобразователя из кристаллического кремния.

Кривая мощности. Зависимость выходной мощности, выделяемой в нагрузку, от выходного напряжения на нагрузке показана рис.7. На кривой имеется лишь одна точка, которая соответствует максимальной или пиковой мощности, снимаемой с фотоэлемента.

У кремниевых фотопреобразователей выходное напряжение, которое соответствует пиковой мощности, равно 0,45 – 0,47 В. Фактическая получаемая мощность зависит от интенсивности падающего солнечного излучения и размеров фотопреобразователя.

Солнечные фотопреобразователи и солнечные батареи из кристаллического кремния. Некоторые параметры современных промышленных образцов.

1. Напряжение холостого хода отдельного фотопреобразователя примерно $U_{xx} = 0,6$ в.
2. Плотность тока короткого замыкания (без учёта влияния атмосферы) $J_{кз} = 49,6$ мА/см².

Сила тока зависит от интенсивности падающего света и размера ФЭПа, то есть от площади его поверхности.

3. Пиковая мощность соответствует напряжению около 0,47 В.
4. Коэффициент заполнения - до 0,82.
5. КПД обычного солнечного элемента в настоящее время колеблется в пределах 10-16 %. Это значит, что ФЭП размером $100 \cdot 100$ мм при стандартных условиях может генерировать 1,0 - 1,6 Вт. Солнечные кремниевые фотопреобразователи с р-п переходом, имеющие некоторые конструктивные особенности, имеют к.п.д. от 16 до 19 %.

Для создания энергетических устройств с нужными характеристиками (напряжение, сила тока, мощность) солнечные ФЭП-ы соединяют в солнечные батареи,

применяя последовательное, параллельное или последовательно-параллельное соединения. Вольт-амперная характеристика и кривая мощности солнечной батареи похожи на характеристики отдельных фотопреобразователей.

Стандартными условиями для паспортизации фотопреобразователей и солнечных батарей во всем мире следующие :

- энергетическая освещенность 1000 Вт/м^2
- температура 25°C
- спектр АМ 1,5 (солнечный спектр на широте 45°)

Выполнение заданий

Задание 1. Измерение нагрузочной вольт-амперной характеристики солнечной батареи.

1. Изучить и законспектировать теоретическое введение.
2. Ознакомиться с измерительной схемой (рис. 5) и зарисовать её.
3. Установить осветитель в положение, соответствующее освещённости E_1 .
4. Включить осветитель и измерительные приборы (мультиметры).
5. Установить сопротивление нагрузки R (магазин сопротивлений) в положение, соответствующее минимальному сопротивлению.
6. Изменяя сопротивление нагрузки R от минимального до максимального значений, занести показания вольтметра (напряжение на нагрузке U) и миллиамперметра (сила тока в нагрузке I) в таблицу 1.
7. Для всех снятых показаний по формуле $P = I \cdot U$ вычислить мощность P , выделяемую в нагрузке.
8. По полученным данным построить график нагрузочной вольт-амперной характеристики солнечной батареи.
9. Построить график зависимости мощности, отдаваемой солнечной батареей в нагрузку, от напряжения на нагрузке (кривая мощности).

Таблица 1

$U,$									
$I,$									
$P=I \cdot U,$									

Задание 2. Определение параметров солнечной батареи.

1. Используя полученные данные, определить ток короткого замыкания $I_{кз}$ и напряжение холостого хода $U_{хх}$.
2. Используя табличные данные и зависимость мощности от напряжения, определите максимальную электрическую мощность, выделяемую в нагрузке, и напряжение, соответствующее максимальной мощности, для уровня освещённости E_1 .
3. Используя график нагрузочной вольт-амперной характеристики солнечной батареи для освещённости E_1 , определите коэффициент заполнения f . Коэффициент заполнения определяется путём вычисления максимальной площади прямоугольника, ограниченного вольт-амперной характеристикой.
4. Вычислите к.п.д. солнечной батареи, используя формулу (4), значение энергетической освещённости E_1 и площадь поверхности батареи S .

$$\eta = f \cdot I_{кз} \cdot U_{хх} / \Phi = f \cdot I_{кз} \cdot U_{хх} \cdot 100 \% / E_1 \cdot S \quad (5)$$

Контрольные вопросы

1. Что называют фотопреобразователем солнечной энергии?
2. Принцип действия солнечного фотопреобразователя.
3. Из какого материала изготавливают промышленные солнечные батареи?
4. Конструкция солнечного фотопреобразователя.
5. Роль антиотражающего покрытия и металлических контактов.
6. Основные параметры солнечного фотопреобразователя: $P_{\text{макс}}$, $U_{\text{хх}}$, $I_{\text{кз}}$, f , η (к.п.д.).
7. Нагрузочная вольт-амперная характеристика. Как она выглядит?
8. Что такое пиковая мощность?
9. Параметры современных солнечных фотопреобразователей, изготовленных из кристаллического кремния.
10. Что такое солнечная батарея?

1.6 Лабораторная работа № ЛР-6 (2 часа)

Тема: «Современные солнечные батареи, солнечные фотоэлектрические системы (электростанции)»

Часть 1. «Современные солнечные батареи»

1.6.1 Цель работы: Ознакомиться с устройством солнечных модулей и батарей наземного применения

1.6.2 Задачи работы:

1. Ознакомиться с устройством кремниевых солнечных модулей и батарей наземного применения.
2. Изучить особенности последовательного соединения солнечных фотопреобразователей и солнечных модулей.
3. Изучить особенности параллельного соединения солнечных фотопреобразователей и солнечных модулей.

1.6.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. солнечные модули (учебные),
2. цифровые мультиметры,
3. осветитель,
4. соединительные провода,
5. каркасный солнечный модуль,
6. измерительный стенд.

1.6.4 Описание (ход) работы:

1. Изучить теоретическое введение и записать основные необходимые сведения.

1. Фотоэлектрический преобразователь (ФЭП) солнечной энергии – полупроводниковый прибор (устройство), непосредственно преобразующее солнечный свет в электрическую энергию. Основа преобразования – вентильный или фотовольтаический эффект в полупроводниковой структуре.

В настоящее время более 90 % солнечных фотопреобразователей (солнечных элементов) и солнечных батарей наземного применения изготавливают из кристаллического и поликристаллического кремния.

Типичный кремниевый солнечный фотопреобразователь представляет собой тонкую пластину из кристаллического или поликристаллического кремния, в которой

создан $p - n$ переход. На лицевую освещаемую поверхность нанесены антиотражающее (просветляющее) покрытие и металлическая токосъёмная контактная сетка, на обратную, тыльную поверхность – сплошной нижний (металлический) контакт (рис.1).

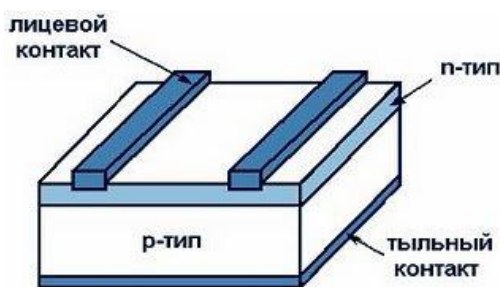


Рис.1 –Упрощённая конструкция солнечного элемента с $p-n$ переходом.

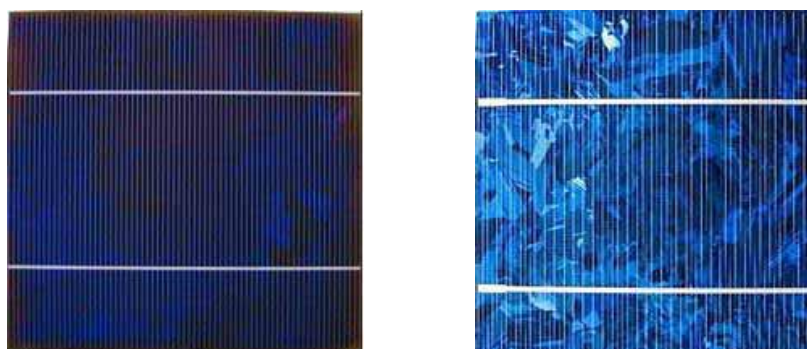


Рис.2 – Фотографии солнечных элементов из монокристаллического кремния (слева) и поликристаллического кремния.

В зависимости от типа проводимости более толстой базовой области различают солнечные элементы двух видов. Солнечные элементы с базой p -типа имеют фронтальную (лицевую) поверхность (сторону) в качестве отрицательного полюса, а тыльная сторона - это положительный контакт. Элементы с базой n -типа имеют тыльную сторону в качестве отрицательного контакта, а рабочую (лицевую сторону) в качестве положительного контакта. Солнечные элементы с базой p – типа гораздо более распространены. На фото (рис.2) показаны солнечные элементы из монокристаллического кремния (слева) и поликристаллического кремния (справа).

Некоторые характеристики промышленных кремниевых солнечных элементов приведены в таблице 1.

Таблица 1

РАЗМЕР, мм	ФОРМА	$U_{xx}, В$	$I_{кз}, А$	$U_p, В$	$I_p, А$	$W_p, Вт$
125·125	псевдоквадрат	0,595	5,31	0,470	4,71-5,11	2,21-2,41
62,5·62,5	1/4 от 125·125	0,595	1,35	0,470	1,05-1,30	0,55-0,60
125·62,5	1/2 от 125·125	0,595	2,65	0,470	2,10-2,65	1,10-1,20
103·103	псевдоквадрат	0,595	3,65	0,470	3,20-3,55	1,50-1,65

Здесь, U_p - напряжение максимальной мощности, иначе рабочее напряжение. При этом напряжении мощность, снимаемая с фотоэлемента или солнечного модуля достигает максимума;

I_p - рабочий ток или ток максимальной мощности. Протекает через фотоэлемент при напряжении максимальной мощности;

W_p - паспортная, максимальная электрическая мощность.

Толщина пластин - 180 – 200 мкм, а размеры стандартных солнечных элементов - 125×125 мм, 156×156 мм. Для производства маломощных солнечных модулей стандартные фотоэлементы режутся с помощью лазера на доли.

Форма фотоэлементов – в виде псевдоквадрата (своеобразного восьмигранника с немного закругленными углами) или чистого квадрата/прямоугольника.

Напряжение холостого хода U_{xx} кремниевых фотопреобразователей не превышает 0,6 – 0,61 В и примерно одинаково у фотоэлементов разных изготовителей. С ростом температуры U_{xx} уменьшается примерно на 0,002 В при увеличении температуры на 1 °С выше 25°С.

Также и рабочее напряжение U_p , которое соответствует максимальной выходной мощности, у разных кремниевых фотоэлементов мало отличается друг от друга и составляет от 0,45 В до 0,49 – 0,5 В.

Сила фототока определяется размерами фотоэлементов и освещённостью, которую создаёт солнечный свет. Сила выходного тока также зависит от длины волны света, поскольку не все фотоны падающего солнечного света при поглощении создают электронно-дырочные пары, а только те, у которых энергия равна или превышает ширину запрещённой зоны кремния $h\nu \geq E_g$. Для кристаллического кремния при комнатной температуре $E_g = 1,12$ эВ.

К.п.д. современных промышленных кремниевых фотопреобразователей наземного применения составляет от 14-15% до 18-19%.

Получены лабораторные образцы с заметно лучшими, почти теоретически предельными параметрами, и с к.п.д. 24 % и более.

Производителями солнечных элементов и батарей приняты определенные условия для тестирования и паспортизации этих устройств. Они называются стандартными (STC-Standard Test Condition) и включают три основных параметра:

- - освещенность 1000 Вт/м²;
- - температура 25°С;
- - спектр АМ 1,5 (солнечный спектр на географической широте 45°).

Солнечная батарея, солнечный модуль, фотоэлектрический модуль представляют собой основные компоненты полупроводниковых энергетических установок, прямо преобразующих солнечный свет в электрическую энергию. Солнечные модули состояются из солнечных фотопреобразователей, а солнечные батареи в свою очередь состояются из солнечных модулей.

2. Способы соединения фотопреобразователей. Батареи можно составлять в любой желаемой комбинации. Простейшей батареей является цепочка из последовательно включённых фотоэлементов. На рис.3 представлены лишь три примера из возможных комбинаций. Различия в характере соединений, хотя все они обладают одинаковыми выходными характеристиками, обусловлены различными требованиями к надёжности.

На рис.3 (а) три последовательные цепочки фотоэлементов соединены параллельно. Такой способ используется, когда высока вероятность короткого замыкания отдельных элементов.

На рис.3 (б) представлена схема параллельно-последовательного соединения фотоэлементов. При таком соединении выход из строя одного элемента, например, из-за появления трещины, не приводит к потере целой цепочки вследствие разрыва цепи. В последнем примере на рис.3 (в) приняты во внимание оба случая с минимумов соединений. Возможны и другие типы соединений.

Количество последовательно спаиваемых фотоэлементов диктуется необходимым номинальным напряжением модуля. Солнечные модули с "номиналом" на 12В состоят из 36 солнечных элементов. Напряжение максимальной мощности 36-ти солнечных элементов даже с учетом потерь при нагреве модуля на солнце обеспечивает заряд 12-ти вольтового аккумулятора. Как известно, при нагреве модуля при реальной работе напряжение максимальной мощности постепенно уменьшается. Скорость снижения примерно составляет 0,002 В/°С на каждый фотоэлемент. Отсчет ведется от 25°С.

Существует важное условие. В одном солнечном модуле фотоэлементы должны иметь максимально близкие параметры, в противном случае один некачественный элемент может испортить всю схему, так как через всю цепочку последовательно спаянных элементов ток будет протекать такой, как у наихудшего фотоэлемента.

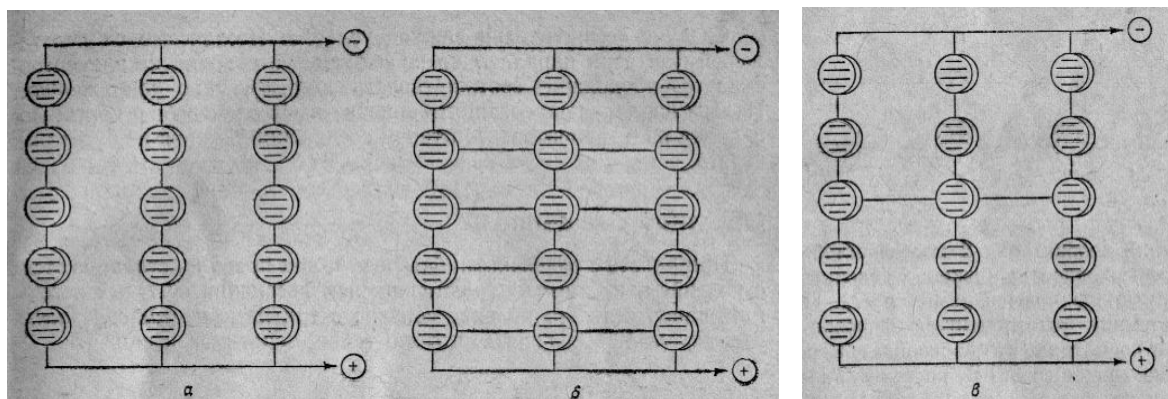


Рис.3

Чтобы увеличить мощность модуля необходимо параллельно соединить цепочки из последовательных солнечных элементов (способ на рис.3, б). К этому приходится прибегать, когда нужны модули определенной мощности, а коммутация маломощных модулей для достижения необходимой мощности нежелательна.

Модули со стандартным напряжением 24 В состоят из 72 последовательно соединенных фотоэлементов. В батареях для космоса подобный параллельно-последовательный тип сборки модуля из мелких солнечных элементов применяется для повышения надежности солнечной батареи в целом, так как в космосе она подвергается облучению («расстрелу») мелкими и более крупными быстрыми частицами и повреждение одной из параллельных цепочек не приведет к значительной потере мощности, как если бы вышла из строя одна цепочка из крупных фотоэлементов.

2. Герметизация солнечных батарей. Обычно осуществляется путём ламинирования. Подобный способ герметизации имеет несколько преимуществ. Во первых, солнечные элементы надежно фиксируются на защитном стекле. Во вторых, из за отсутствия воздушного зазора между покровным стеклом и элементами минимизируются потери на отражение, так как коэффициент преломления пленки ЭВА в кристаллизованном состоянии и коэффициент преломления стекла одинаковы. Соответственно нет ненужных потерь на отражение при переходе солнечного света из одной среды в другую. Для ламинирования применяется этилвинилацетатная (ЭВА) пленка, защитная пленка полиэтилентерефталат (ПЭТ) и закаленное стекло с текстурой, обладающее большей прозрачностью и низкими потерями на отражение под углами падения света менее 90°.

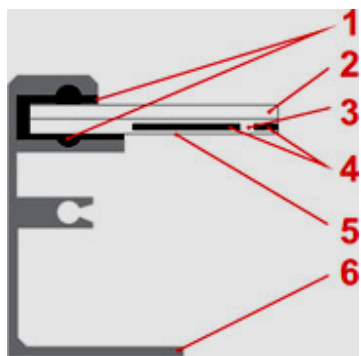


Рис. 4: 1 – герметик, 2 – стекло, 3 - герметизирующая пленка ЭВА, 4 – фотоэлементы, 5 - защитная пленка ПЭТ, 6 - алюминиевый каркас

Процесс ламинирования происходит в вакуумном ламинаторе при температуре 140 -150°C. Перед этим собирается своеобразный сэндвич из стекла, двух слоев ЭВА между которыми находится электрическая схема из фотоэлементов и один слой защитной пленки ПЭТ (рис.4). Под воздействием высокой температуры ЭВА расплавляется, приобретает необходимую прозрачность и надежно спекается со стеклом и тыловой плёнкой ПЭТ.

3. Затенение солнечных батарей. При работе с солнечными батареями сталкиваются с явлением, не имеющим места при использовании обычных источников питания. Это явление связано с так называемым *обратным смещением*.

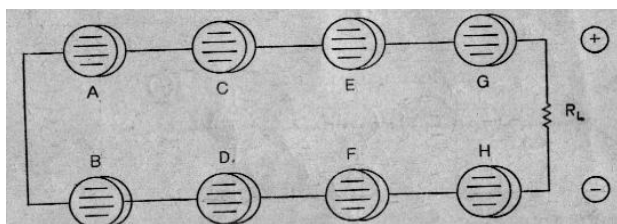


Рис. 5

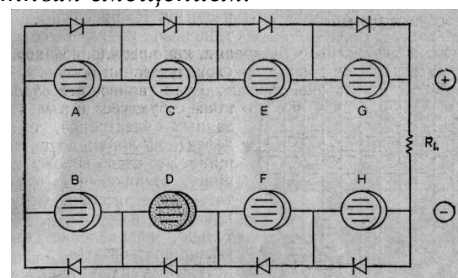


Рис. 6

Например, на рис.5 изображены 8 последовательно соединённых кремниевых фотоэлементов. Полное выходное напряжение цепочки при освещении всех фотоэлементов составляет 4 В (по 0,5 В от каждого элемента). В качестве нагрузки подключен резистор R_L . При затемнении фотоэлемента D непрозрачным предметом он уже не производит электрический ток и представляет собой звено с большим внутренним сопротивлением, а не короткую. Происходит то же, что и при размыкании выключателя, но этот выключатель (затемнённый фотоэлемент) разомкнут не полностью – через него течёт небольшой ток. В большинстве случаев эффективное сопротивление затемнённого фотоэлемента во много раз больше величины нагрузочного сопротивления R_L . Поэтому этот резистор можно рассматривать как кусок провода, соединяющий положительный и отрицательный выводы. Это означает, что функцию нагрузки выполняет элемент D . Остальные элементы снабжают энергией эту нагрузку. При большой мощности батареи, при ярком освещении ток через элемент D может быть значителен, он будет нагреваться и при достаточно сильном разогреве может выйти из строя. В результате вся батарея из последовательной цепочки элементов будет бездействовать.

Эффективное решение этой проблемы – параллельное подключение шунтирующих диодов ко всем солнечным элементам, как это показано на рис.6. Диоды подключены так, что при работе (освещении) солнечного элемента они обратно смещены напряжением самого элемента. Поэтому через диод ток не течёт, и батарея функционирует нормально.

При затемнении, например, одного из элементов диод, подключенный к нему параллельно, оказывается прямо смещённым и через него течёт ток в нагрузку в обход затемнённого фотоэлемента. Выходное напряжение всей цепочки при этом уменьшится на

0,5 В, зато устранится источник саморазрушения и батарея продолжает нормально работать. Без шунтирующих диодов она бы полностью вышла из строя.

На практике нецелесообразно шунтировать каждый элемент батареи. Как правило, исходя из разумного компромисса между надёжностью батареи и стоимостью, используют один диод для защиты 1/4 батареи. Таким образом, на всю батарею требуется 4 диода. В этом случае эффект затенения батареи будет приводить к 25 % , вполне допустимому, снижению выходной мощности батареи.

Поэтому обычно с тыльной стороны солнечного модуля устанавливается контактная коробка для электрических выводов модуля. Если мощность модуля более 60 Вт, то при сборке схемы делается 1 или 2 отвода - средние точки. Эти средние точки нужны для установки в контактной коробке шунтирующих диодов. Эти диоды уменьшают потери мощности от частичного затенения, а также предотвращают выход модуля из строя. Их называют **баррирующими диодами**.

Внешний вид стандартного солнечного модуля из 36 элементов показан на фотографии (рис.7). Для наращивания суммарной мощности солнечные модули соединяются в более крупные массивы, которые называются солнечными батареями. Подобная модульность конструкций позволяет создавать системы неограниченной мощности.

4. Условия использования солнечных батарей.

- температурный диапазон – от - 50°C до +75°C
- диапазон атмосферного давления до 85 - 107 кПа
- относительная влажность 0 - 100%
- максимальная интенсивность дождя до 5 мм/мин
- максимальная нагрузка (снег + ветер) до 2000 Па

Выполнение заданий

Задание 1. Изучить последовательное соединение солнечных элементов и модулей.

1. Измерить напряжение холостого хода U_{xx} и ток короткого замыкания $I_{кз}$ солнечных модулей.
2. Последовательно соединить несколько одинаковых по параметрам солнечных модулей.
3. При соединении модулей поэтапно, начиная с первого модуля, измерить напряжение холостого хода U_{xx} и ток короткого замыкания $I_{кз}$ образующейся солнечной батареи. Результаты измерений занести в таблицу 2.
4. Сделать вывод об особенностях последовательного соединения модулей.



Рис. 7 – Фотография солнечного модуля

Задание 2. Изучить особенности затенения солнечной батареи.

1. Измерить напряжение холостого хода U_{xx} и ток короткого замыкания $I_{кз}$ солнечной батареи, состоящей из нескольких последовательно соединённых модулей.
2. Затемнить (закрыть от падающего света) один модуль солнечной батареи и измерить напряжение холостого хода U_{xx} и ток короткого замыкания $I_{кз}$ батареи.
3. Сравнить значения U_{xx} и $I_{кз}$ частично затенённой батареи с её начальными значениями, когда батарея освещалась полностью.
4. Сделать вывод о сопротивлении затемнённого модуля и его влиянии на работу батареи.

Задание 3. Изучить параллельное соединение солнечных элементов и модулей.

1. Параллельно соединить несколько одинаковых по параметрам солнечных модулей.
2. Измерить напряжение холостого хода U_{xx} и ток короткого замыкания $I_{кз}$ образовавшейся солнечной батареи. Результаты измерений занести в таблицу 3.
3. Сделать вывод об особенностях параллельного соединения модулей.

Таблица 2. Последовательное соединение солнечных модулей

N_2 модуля									
U_{xx}									
$I_{кз}$									

Таблица 3. Параллельное соединение солнечных модулей

N_2 модуля									
U_{xx}									
$I_{кз}$									

Контрольные вопросы

1. Что называют солнечным элементом, солнечным модулем, солнечной батареей?
2. Принцип работы фотопреобразователя солнечной энергии.
3. Конструкция солнечного фотопреобразователя.
4. Основные параметры современных кремниевых фотопреобразователей.
5. Что называют напряжением холостого хода, током короткого замыкания, к.п.д.?
6. Конструкция солнечных модулей и батарей.
7. Способы и особенности соединения солнечных элементов в модули и батареи.
8. Эффект затенения солнечного модуля или батареи. Способ защиты солнечной батареи.
9. Устройство автономной фотоэлектрической станции (ФЭС). Функциональное назначение её элементов.
10. Десять одинаковых солнечных фотопреобразователей (параметры в 1-ой строке таблицы 1) соединены последовательно. Определите U_{xx} , $I_{кз}$ и напряжение полученной батареи при оптимальной нагрузке. Освещение и другие условия стандартные.

Часть 2. «Солнечные фотоэлектрические системы (электростанции)»

1.6.1 Цель работы: Ознакомиться с устройством и работой сетевых солнечных фотоэлектростанций.

1.6.2 Задачи работы: Ознакомиться с устройством и работой сетевых солнечных фотоэлектростанций.

1.6.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Мультимедийный проектор;
2. Компьютер;
3. Солнечные батареи учебные.

1.6.4 Описание (ход) работы:

Изучить теоретическое введение и записать основные необходимые сведения.

1. Сетевые солнечные фотоэлектрические станции (ФЭС) - один из видов электростанций, генерирующий электричество путем преобразования солнечного излучения в электрическую энергию с последующей ее передачей в центральную электрическую сеть.

Сетевая станция представляет собой солнечный генератор без накопителя энергии. Основные элементы электростанций этого типа - солнечные панели и специальный сетевой инвертор. При этом крайне важно подбирать солнечные панели с одинаковыми характеристиками. В противном случае вся последовательная сеть будет работать по характеристикам панели с наихудшими параметрами.

В отличие от станций с накопителем возможности сетевых электростанций ограничены. Сетевая солнечная электростанция не может работать автономно. Поскольку накопителя электроэнергии нет, то в отсутствии солнечного света она не способна генерировать энергию. Поэтому в темное время суток и когда не хватает мощности электростанции, электричество берется из сети. Получается, что использование сетевой станции помогает существенно экономить расходы на электроэнергию. Однако, полностью отказаться от подключения к централизованной сети невозможно.

Структурная схема типовой сетевой солнечной электростанции показана на рис.1

В состав сетевой фотоэлектрической системы входят следующие элементы:

1. Солнечные батареи, вырабатывающие под действием солнечного излучения постоянный ток;
2. Сетевой инвертор, преобразующий постоянный ток, генерируемый солнечными панелями, в переменный;
3. Система мониторинга, позволяющая отслеживать параметры работы солнечной электростанции;
4. Счетчики, предназначенные для мониторинга производительности системы и продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу;
5. Поддерживающие металлоконструкции (опоры) для размещения солнечных батарей на земельном участке, крыше здания или подвижные поворотные трекеры;
6. Централизованная сеть - линия электропередач, к которой подсоединена фотоэлектростанция;
7. Собственные потребители электроэнергии (промышленные или бытовые электроприборы).

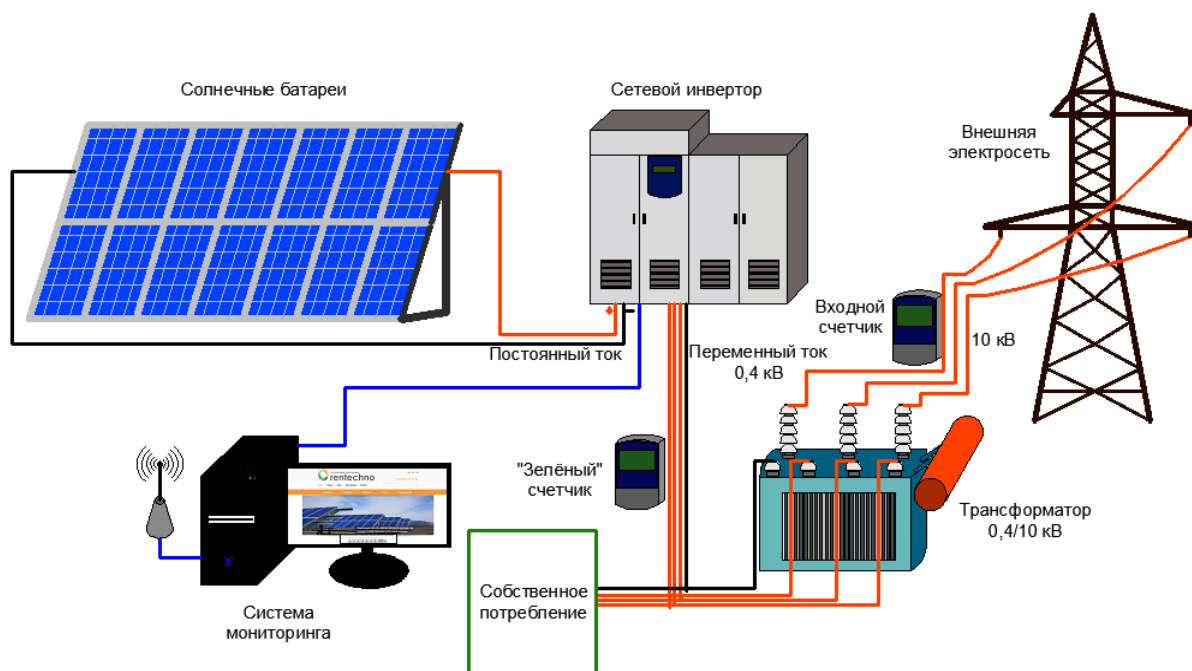
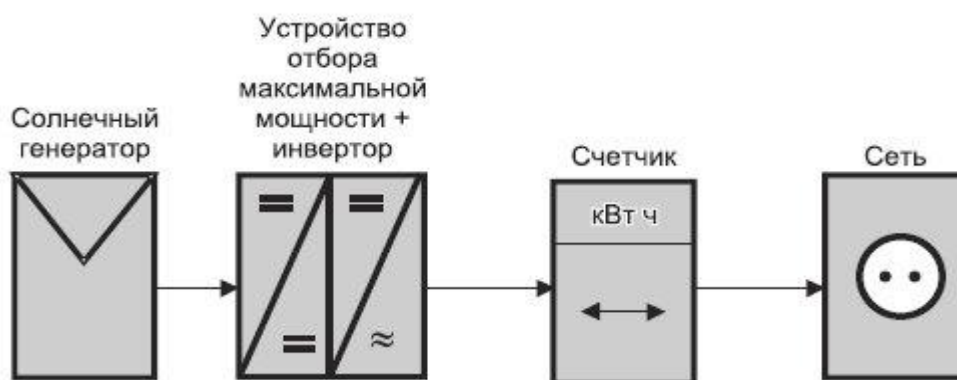


Рис. 1 - Структурная схема типовой сетевой солнечной электростанции (верхний рисунок) или в упрощённом виде (на нижнем рисунке).



Сетевые фотоэлектрические системы могут работать как по «зеленому» тарифу, продавая электроэнергию в централизованную внешнюю сеть, так и использоваться для производства электроэнергии с целью собственного потребления.

Преимущества сетевых солнечных электростанций:

- отсутствует необходимость использования любых видов ископаемого топлива.
- на протяжении всего срока эксплуатации генерируется значительно больше энергии, чем было затрачено для производства электростанции.
- для строительства подходят не только пустые площадки земли, но и крыши и фасады зданий, что позволяет экономить территорию и зачастую существенно снижает затраты на строительство.
- высокая надежность системы — в солнечной электростанции отсутствуют движущиеся части, которые шумят и изнашиваются.
- нет необходимости в проведении трудоемкого технического обслуживания для поддержки солнечной электростанции в работоспособном состоянии.
- возможность подключения по «зеленому» тарифу.
- возможность применения в местах, где отсутствуют централизованные электросети;
- возможность частичного или полного электропитания избранных потребителей;
- возможность дополнительной комплектации системы аккумуляторной батареей;
- экологическая безопасность работы;
- полностью автоматическая работа и изменение ее режимов.

- возможность применения трекерной системы слежения за Солнцем, которая позволяет удерживать солнечные модули в оптимальном положении относительно Солнца, максимально используя всю доступную солнечную энергию;

- срок эксплуатации фотоэлектростанции составляет не менее 25...30 лет. При этом снижение мощности, вызванное естественным старением электронных компонентов фотоэлектрической батареи, не превышает 20% после 25 лет эксплуатации ФЭС.

Строительство солнечных электростанций включает в себя:

- поиск и подбор земельных участков, зданий и других объектов для установки солнечных электростанций;
- прогноз эффективности проекта с учетом специфических территориальных условий;
- расчет стоимости солнечных электростанций;
- расчет окупаемости солнечных электростанций;
- системное проектирование солнечных электростанций и инжиниринг;
- подбор и закупка оборудования;
- монтаж и испытание систем - установка солнечных электростанций;

Сетевые солнечные электростанции, работающие по «зеленому» тарифу

В ряде развитых стран существует благоприятное законодательство (в виде различных льгот), стимулирующее строительство солнечных электростанций, работающих по «зеленому» тарифу, что делает строительство солнечных электростанций экономически привлекательным проектом. Существуют различные нормы для получения «зеленого» тарифа частными лицами (владельцами солнечных батарей) и для получения «зелёного» тарифа для энергообеспечения коммерческих промышленных объектов.



Рис. 2 – Солнечные панели (батареи) на фиксированных опорах

Установка солнечных батарей возможна:

- на фиксированных опорных металлоконструкциях для наземных и крышных солнечных электростанций (рис.2);
- с помощью динамических систем крепления, позволяющих отслеживать суточных и сезонные перемещения Солнца (подвижные трекеры) (рис.3).

Трекер – подвижная платформа, поворачивающаяся вслед за перемещением Солнца по небу.

Солнечные батареи работают лучше всего тогда, когда рабочая поверхность фотоэлементов расположена перпендикулярно солнечным лучам. Применение трекерной системы слежения за Солнцем, которая позволяет удерживать солнечные модули в оптимальном положении относительно Солнца, максимально используя всю доступную солнечную энергию, приводит к увеличению ежегодного производства энергии на 25-30% по сравнению с неподвижно закрепленным солнечным модулем.

Применяются одноосные и двухосные трекеры, позволяющие повысить эффективность всей солнечной электростанции. Динамические системы крепления фотоэлектрических модулей (трекеры) снабжены системами управления, которые состоят из электромеханических приводов, блока управления и программного обеспечения.



Рис. 3 - Подвижные опоры (трекеры) для установки солнечных батарей

Сетевые солнечные электростанции целесообразно использовать на предприятиях, офисных зданиях, в различных торговых центрах, поскольку в этих учреждениях максимальное потребление электроэнергии происходит в светлое время суток.

Стоимость и окупаемость. Комплектующие для сетевых солнечных электростанций производятся в различных странах, в том числе, и в России. Это определяет относительно приемлемые цены и снижает зависимость итоговой стоимости станции от курса валют. Срок окупаемости зависит от изменения тарифов на электроэнергию. По расчетам на сегодняшний день сетевая солнечная электростанция полностью окупит себя через 7-8 лет.

2. Несетевые солнечные электростанции. Фотоэлектрические системы бывают резервными и автономными.

- **Резервные фотоэлектрические системы** электропитания применяются там, где существует возможность подключения к сетям централизованного электроснабжения, но они ненадежны или работают с перебоями. Таким образом, резервные системы могут использоваться для электроснабжения объектов в периоды, когда в сети отсутствует напряжение или его мощность недостаточна.

- Автономные фотоэлектрические системы используются там, где нет централизованных линий электропередач (прокладка сетей затруднена или экономически нецелесообразна) или для электропитания передвижных объектов (сельские дома, дачи, фермы, автомобили, лодки, уличные солнечные фонари и так далее).

- **Автономные электростанции на солнечных батареях.** структурная схема простейшей автономной ФЭС мощностью 0,01...100 кВт, предназначенной для электроснабжения передвижных объектов или объектов, удаленных от ЛЭП, показана на рис.4.

Основными элементами фотоэлектрической системы являются:

- солнечные модули,
- блок аккумуляторных батарей,
- контроллер заряда/разряда аккумулятора,
- инвертор, преобразующего постоянный ток, вырабатываемый солнечными модулями, в переменный ток.

На территории Европы фотоэлектрические системы чаще всего решают проблему резервного энергообеспечения, так как возможность полностью автономной работы ограничивается недостаточным уровнем солнечного излучения в зимнее время.

К преимуществам использования фотоэлектрических систем относится их эффективность в местах, где прокладка линий электропередач затруднена или требует больших затрат, бесшумность работы, отсутствие необходимости проведения сложного технического обслуживания и экологическая чистота.

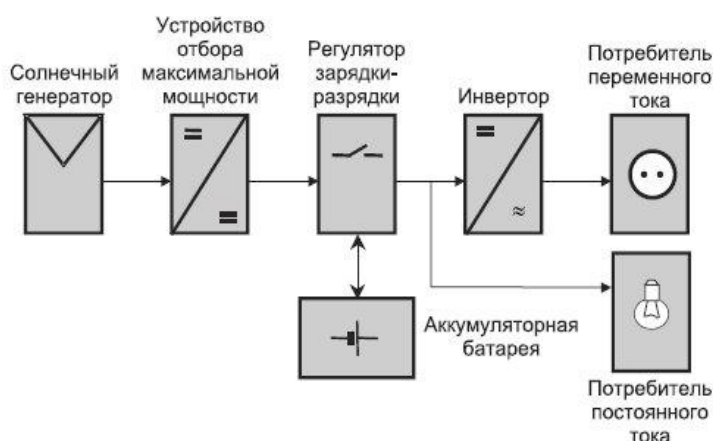


Рис.4 - Структурная схема простейшей автономной ФЭС мощностью 0,01...100 кВт.

Основные компоненты фотоэлектрических солнечных электростанций

Основными компонентами ФЭС являются солнечные модули (солнечные панели), инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный, аккумуляторные батареи, регуляторы отбора максимальной мощности, а также другое электрооборудование.

Солнечные панели (модули)

Солнечные панели, преобразующие часть солнечного излучения в постоянный электрический ток, являются основной частью любой ФЭС (рис.2,3). Каждая такая панель состоит из полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей, осуществляющих прямое, одноступенчатое преобразование солнечного света в электричество, в постоянный электрический ток. Соединяя фотоэлементы в модули (панели), а модули друг с другом, строят крупные ФЭС.

Фотоэлементы для панелей ФЭС изготавливают из полупроводникового кремния, легированного некоторым количеством мышьяка и бора. В настоящее время наибольшее распространение получили три вида солнечных панелей:

- монокристаллические;
- тонкопленочные;
- поликристаллические.

Монокристаллические панели (модули) на основе монокристаллического кремния имеют наивысшую эффективность преобразования энергии: их КПД, составляющий 17...18%, самый большой, а срок их службы – не менее 25 лет. Основным материалом таких

панелей – чистый кремний в виде больших монокристаллов, получаемых выращиванием с помощью кристаллика-затравки, который медленно вытягивается из кремниевого расплава. Большие стержни кристаллического кремния, полученные таким путем, разрезают на пластины (диски) толщиной 0,2...0,3 мм, в которых и создаётся р-п переход и другие фотоактивные слои фотопреобразователя. Затем происходит процесс металлизации, наносится просветляющее покрытие.

На конечной стадии изготовления фотоэлементы электрически соединяются, образуя модули, состоящие из 36 или 72 фотоэлементов. Полученную пластину обрамляют в алюминиевую раму, облегчающую ее крепление к несущей конструкции, закрывают закалённым защитным стеклом, герметизируют с помощью специального герметика. Мощность отдельной солнечной панели может достигать 10...260 Вт (рис.5).

Диапазон рабочих температур для получения оптимальной мощности данного вида солнечных панелей колеблется в пределах 15...25°C. Максимальная мощность достигается только при ясном небе, средней температуре воздуха 25°C и направлении панелей прямо на Солнце. При наличии даже небольшой облачности их мощность снижается на 70%, а в случае сильной облачности – на 90%. Поэтому, чтобы на практике обеспечить максимальную мощность монокристаллических панелей, их необходимо устанавливать в местах с большим числом солнечных дней в году и применять автоматические системы слежения за направлением на Солнце.

Поликристаллические солнечные панели, эффективность которых не так сильно зависит от угла падения солнечных лучей и которые имеют срок службы не менее 20 лет, являются альтернативой монокристаллическим панелям. КПД солнечных панелей на основе поликристаллического кремния составляет 12-15 %.

Тонкопленочные панели – наиболее дешевый вариант из всех видов солнечных панелей, обеспечивающий минимальную себестоимость их производства. Такие панели успешно работают при рассеянном излучении, не требуют прямых солнечных лучей, и их суммарная вырабатываемая за год мощность обычно на 10...15% превышает показатели традиционных кристаллических солнечных панелей. Поэтому такие панели преимущественно (на 95%) используются для ФЭС, генерирующих электроэнергию непосредственно в сеть, даже несмотря на то, что для установки тонкопленочных панелей требуется приблизительно в 2,5 раза больше площади, чем для панелей с монокристаллическими батареями. Тонкопленочные панели из-за меньшего КПД наиболее эффективно использовать в системах мощностью от 10 кВт, а монокристаллические и поликристаллические – для построения небольших автономных или резервных систем электроснабжения.

Электрическая коммутация солнечных модулей. Для получения необходимой мощности и рабочего напряжения солнечные панели соединяют последовательно или параллельно, получая таким образом фотоэлектрический генератор (рис.6). Мощность этого генератора всегда оказывается меньшей, чем сумма мощностей отдельных панелей из-за потерь на рассогласование. Для снижения этих потерь необходим тщательный подбор в генераторе панелей с минимальным разбросом характеристик. Так, например, при последовательном соединении 10 панелей с разбросом характеристик в 10% потери на рассогласование составляют около 6%, а при разбросе в 5% они уменьшаются до 2%.

Эффект затенения или горячего пятна. При затенении одной панели или ее части в фотоэлектрическом генераторе при последовательном соединении отдельных панелей возникает, так называемый, «эффект горячего пятна» – затененная панель или часть ее начинает рассеивать всю мощность, вырабатываемую освещенными панелями (или ее частями), быстро нагревается и выходит из строя. Поэтому для устранения этого эффекта параллельно с каждой панелью (или ее частью) устанавливают шунтирующий диод. К каждой линейке последовательно соединенных панелей подключается также блокирующий диод – для выравнивания напряжений линеек. Схема фотоэлектрического генератора с подключенными параллельно с каждой его панелью диодами показана на

рис.6. Модули устанавливаются на стальных или алюминиевых опорных конструкциях на земле (или на крышах и фасадах зданий — и при этом служат одновременно кровельным или защитным материалом).

Электрические параметры таких модулей представляются в виде вольтамперной характеристики, снятой при стандартных условиях (Standard Test Condition — STC), т.е. когда мощность солнечной радиации составляет 1000 Вт/м², температура элементов — 25°C и солнечный спектр — на широте 45° (рис. 7).

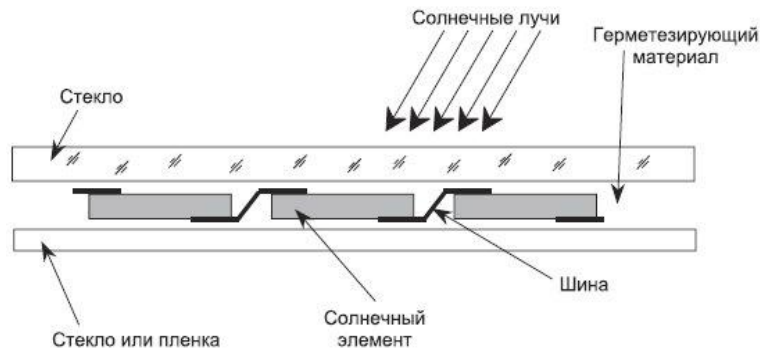


Рис. 5- Разрез солнечного модуля

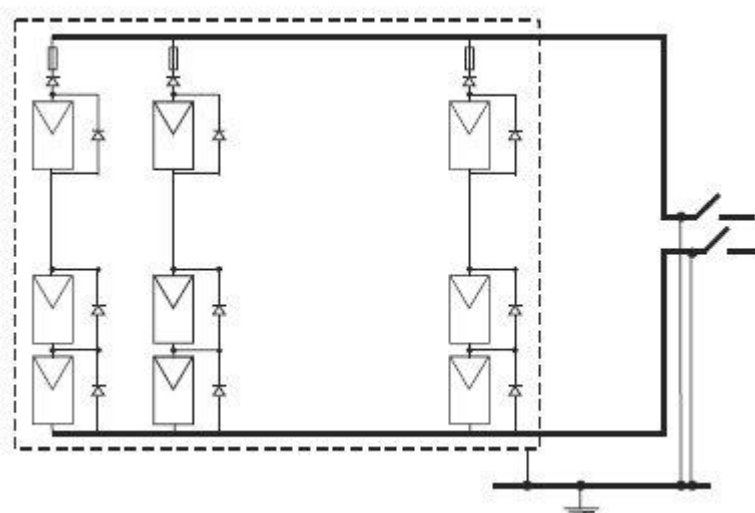


Рис. 6. Схема генератора фотоэлектрической системы

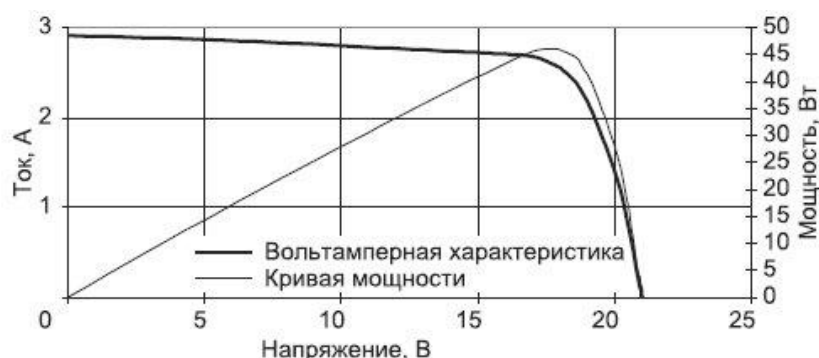


Рис. 7. Вольтамперная характеристика солнечного модуля

Номинальная мощность модуля определяется как наибольшая мощность при STC. Значение напряжения, соответствующее максимальной мощности называется напряжением максимальной мощности V_{mp} (рабочим напряжением), а соответствующий ток — током максимальной мощности I_{mp} (рабочим током). Значение рабочего напряжения для модуля, состоящего из 36 элементов приблизительно равно 16... 17 В

(0,45...0,47 В/элемент) при 25°C. Такой запас по напряжению необходим для того, чтобы компенсировать снижение рабочего напряжения при нагреве модуля (солнечным излучением) — температурный коэффициент напряжения холостого хода для кремния составляет $\sim -0,4\%/^\circ\text{C}$. Температурный коэффициент тока -положительный (0,07%/градус). Напряжение холостого хода модуля мало меняется при изменении освещенности (в то время как ток короткого замыкания прямо ей пропорционален). КПД солнечного модуля определяется как отношение максимальной мощности (модуля) к общей мощности излучения, падающей на его поверхность при стандартных условиях, и составляет 12...15%.

Вольтамперная кривая генератора имеет тот же вид, что и единичного модуля. Рабочая точка генератора, подключенного к нагрузке, не всегда совпадает с точкой максимальной мощности (тем более, что положение последней зависит от условий освещенности и температуры окружающей среды). Подключение таких нагрузок, как, например, электродвигатель, может сдвинуть рабочую точку системы в область минимальной или даже нулевой мощности (и двигатель просто не запустится). Поэтому следующий важный компонент солнечных электрических систем — преобразователи напряжения, способные согласовывать солнечный модуль с нагрузкой.

Регуляторы отбора максимальной мощности. Как правило, в этих регуляторах реализуется принцип поиска максимума мощности путем коротких периодических изменений положения рабочей точки. Если при этом мощность на выходе прибора увеличивается, то положение рабочей точки изменяется в этом направлении при следующем шаге. Таким образом постоянно оптимизируется нагрузочная характеристика для отбора максимальной мощности, а также обеспечивается возможность регулировки в широком динамическом диапазоне и формирования импульсов тока, способных зарядить аккумуляторную батарею даже в условиях малой освещенности. Этот достаточно простой алгоритм может быть улучшен «запоминанием» часто повторяющихся направлений смещения рабочей точки (для устранения шагов смещения в ложных направлениях), что бывает важно в условиях быстро меняющейся освещенности.

На выходе регулятора формируются импульсы постоянного тока, ширина и частота следования которых зависит от мощности, производимой солнечным модулем в данный момент. При этом, если рабочее напряжение нагрузки меньше, чем рабочее напряжение модуля, то можно получать большие значения токов в нагрузке, чем ток короткого замыкания модуля. Следует учитывать, что регуляторы имеют КПД 0,85...0,95.

Инверторы. Солнечный генератор может вырабатывать только постоянный ток. Однако, существует много потребителей, использующих именно постоянный ток (зарядка аккумуляторов, освещение, радиоаппаратура и др.). Для преобразования постоянного тока аккумуляторной батареи в переменный синусоидальной формы необходим инвертор.

Инверторы — полупроводниковые приборы. Они могут быть разделены на два типа в соответствии с типом фотоэлектрических систем: 1) инверторы для автономных систем и 2) инверторы для сетевого применения. Выходной каскад у обоих типов во многом похож, а главное отличие — в схеме управления. Первый тип имеет генератор частоты, а второй должен работать синхронно с промышленной сетью (и в качестве генератора частоты использует саму сеть). Для всех типов основной параметр — КПД (который должен быть более 90%).

Выходное напряжение автономных инверторов в большинстве случаев составляет 220 В (50/60 Гц), а в инверторах мощностью 10...100 кВт можно получать трехфазное напряжение 380 В. Все автономные инверторы преобразуют постоянный ток аккумуляторных батарей, поэтому входное напряжение выбирается из ряда 12, 24, 48 и 120 В. Чем больше входное напряжение, тем проще инвертор и тем больше его КПД. При больших напряжениях значительно меньше потери на передачу энергии от солнечного генератора к аккумуляторной батарее, регулятору зарядки и инвертору, но при этом

усложняется конструкция солнечного генератора и его эксплуатация при опасных напряжениях (выше 40 В).

К форме выходного сигнала автономных инверторов предъявляются менее жесткие требования. В ряде случаев (если позволяет нагрузка) возможно применение инверторов с трапециевидным выходным сигналом. Такие инверторы стоят в 2...3 раза дешевле инверторов с синусоидальным выходным сигналом. Важный параметр автономных инверторов — зависимость КПД от мощности подключенной нагрузки. КПД не должен заметно снижаться при подключении нагрузки в десять раз меньшей (по потребляемой мощности), чем номинальная мощность инвертора. В то же время инвертор должен выдерживать перегрузки в выходных цепях (при подключении электродвигателей или других динамических нагрузок). В идеальном случае к автономному инвертору предъявляются следующие требования:

- способность выдерживать перегрузки (как кратковременные, так и длительные);
- низкие потери при малых нагрузках и на холостом ходу;
- стабилизация выходного напряжения;
- низкий коэффициент гармоник;
- высокий КПД;
- отсутствие помех на радиочастотах.

Примеры выходных сигналов сетевых инверторов и автономных инверторов приведены на рисунках 8 и 9, соответственно.

Промышленность производит широкий ассортимент инверторов, специально разработанных для фотоэлектрических систем. Такие инверторы включают блок регулятора отбора максимальной мощности, блок регулятора заряда, а также дополнительный вход подключения дизель-генератора (для экстренной подзарядки батареи).

К выходному сигналу сетевых инверторов предъявляются самые жесткие требования. Для уменьшения потерь на преобразование такие инверторы работают при высоких входных напряжениях (до 1000 В). Так как их входные цепи запитываются непосредственно от солнечного генератора, инверторы имеют регулятор отбора максимальной мощности (встроенный в инвертор). Сетевые инверторы имеют также блок контроля мощности солнечного генератора (и включаются автоматически, как только мощность генератора становится достаточной для формирования переменного сигнала).

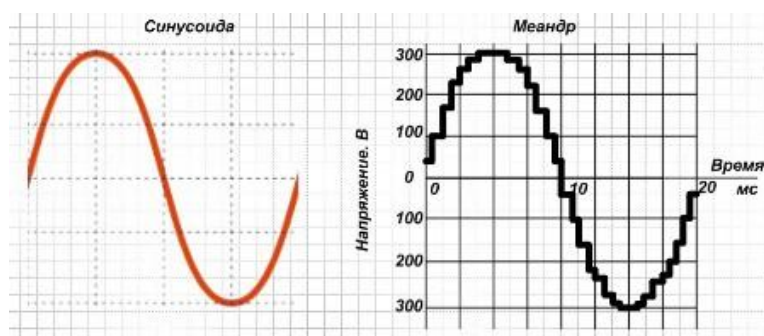


Рис. 8

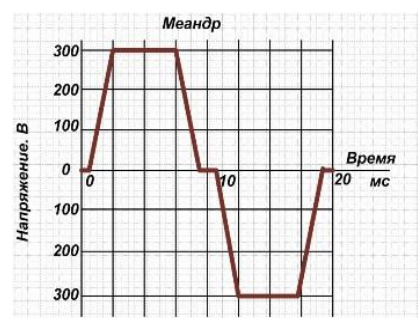


Рис.9

Сравнение солнечных фотоэлектростанций с основными возобновляемыми источниками энергии.

Занимаемые площади. В таблице 2 приведены удельные мощности разных типов электростанций (с учетом площадей, занимаемых сооружениями и зданиями). При расчетах принималось, что все земли имеют одинаковую стоимость. Для тепловых и атомных станций учитывались территории, занятые под добычу угля и руды. Площади производств строительных и конструкционных материалов не учитывались — они

приблизительно одинаковы для всех типов станций. Ожидается уменьшение удельной мощности атомных станций за счет увеличения территорий, занятых под захоронение отходов. Для солнечных станций (особенно фотоэлектрических) данный показатель должен увеличиваться за счет увеличения КПД преобразователей и большего использования возможности размещения их на крышах зданий.

Тип электростанции	Удельная мощность, МВт/км ²
Таблица 2. Удельные мощности разных типов электростанций	
Солнечные станции	50...100
Ветровые станции	до 15
Гидростанции	до 10
Энергия биомассы	до 5
Тепловые станции	до 30
Атомные станции	60...120

Энергоотдача. Данный показатель определяется как отношение количества энергии, выработанной системой за срок службы, к количеству энергии, затраченной на производство материалов и оборудования (для этой системы). Энергоотдача — основной (с точки зрения будущего полного перехода на возобновляемые источники энергии) показатель, т.к. характеризует реальный прирост энергии к общему балансу (табл. 3).

Таблица 3. Энергоотдача разных типов электростанций

Тип станций	Энергоотдача
Солнечные станции:	
фотоэлектрические	20...100
фототермические	10...50
Ветровые станции	более 20
Энергия биомассы	более 20
Тепловые станции	более 15
Атомные станции	6...13

Из таблицы видно, что лучшую энергоотдачу имеют солнечные станции (в перспективе ожидается, что значение еще улучшится). При использовании фотоэлектричества мы получаем возобновляемую энергию и расходует минимальное количество невозобновляемых материалов (все материалы, кроме, например, древесины). Более того, запасы основного материала — кремния (для изготовления стекла и солнечных элементов) достаточно велики.

Контрольные вопросы

1. Виды солнечных фотоэлектрических электростанций.
2. Назначение и структурная схема сетевой фотоэлектростанции.
3. Основные компоненты сетевой ФЭС и их функциональное назначение ?
4. Способы коммутации солнечных модулей.
5. Вольт-амперная характеристика солнечного модуля и солнечной батареи.
6. Что называют номинальной мощностью солнечного модуля?
7. Как определяется к.п.д. солнечного модуля?
8. Форма выходного сигнала сетевого инвертора.

1.7 Лабораторная работа № ЛР-7 (2 часа).

Тема: «Автономные фотоэлектрические системы (электростанции), расчёт автономной фотоэлектрической системы (электростанции)»

Часть 1. «Автономные фотоэлектрические системы (электростанции)»

1.7.1 Цель работы: Ознакомиться с устройством и работой автономных солнечных фотоэлектростанций.

1.7.2 Задачи работы: Ознакомиться с устройством и работой автономной солнечной фотоэлектростанции.

1.7.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Мультимедийный проектор;
2. Компьютер;
3. Автономная ФЭС.

1.7.4 Описание (ход) работы:

1. Изучить теоретическое введение и записать основные сведения о конструкции автономной ФЭС, функциональном назначении её компонентов и работе.

Автономные ФЭС – это солнечные фотоэлектрические системы (электростанции), предназначенные для электропитания передвижных или удаленных объектов, лишенных возможности подвода линии электропередач. Причина может заключаться в нецелесообразности или невозможности подвода электрической линии.

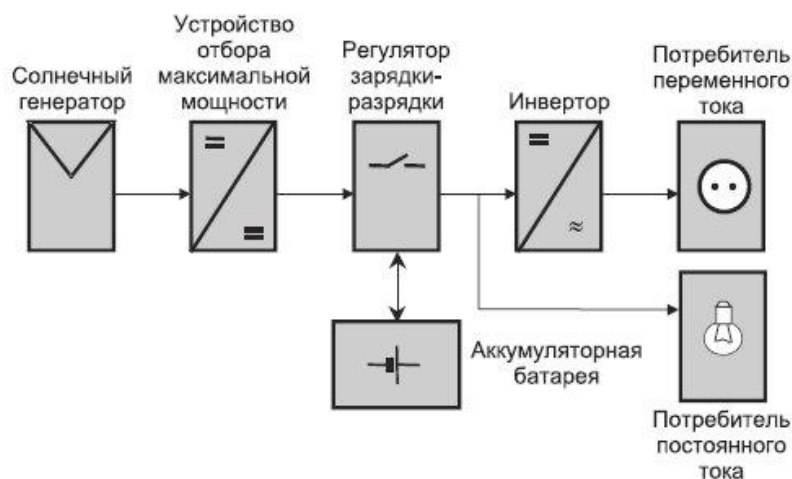
Основные компоненты автономной ФЭС : солнечные батареи, контроллер заряда-разряда аккумуляторной батареи, аккумуляторная батарея и соединительные кабели. Если нагрузка (различные устройства) питается от переменного напряжения, то необходим еще инвертор. Схема ФЭС показана на рис.1, 2.



Рис.1



Рис.2



Принцип работы ФЭС заключается в следующем: солнечная батарея в светлое время суток ведет заряд аккумуляторных батарей АКБ. Контроллер заряда-разряда обеспечивает правильный режим заряда и разряда АКБ. При этом солнечная батарея при необходимости ведет питание дневных нагрузок. Нагрузки, работающие в темное время суток, питаются исключительно от АКБ. Нагрузки переменного тока запитываются через инвертор.

Для надёжной работы, подключаемых к ФЭС устройств (нагрузки), необходим правильный подбор компонентов фотоэлектрической системы, основанный на предварительном расчёте. Под расчётом ФЭС понимается определение номинальной мощности солнечных модулей, их количества, схемы соединения, выбор типа, ёмкости и условий эксплуатации АКБ, мощности инвертора и контроллера заряда – разряда, определение параметров соединительных кабелей.

Компоненты фотоэлектрических систем

Солнечные модули. Солнечные модули — основная часть любой фотоэлектрической системы. Наибольшее распространение получили солнечные модули из монокристаллических или поликристаллических кремниевых элементов. Солнечные элементы могут быть круглыми (диаметром 100,125 и 150 мм) или квадратными (82 x 82,100 x x 100 или 125 x 125 мм). Мощность элементов — 0,9...2,7 Вт.

Солнечные модули наземного использования обычно конструируются для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В. При этом последовательно соединяются 36 солнечных элементов и затем собираются в модуль, разрез которого показан на рис. 3. Полученный пакет обрамляют в алюминиевую раму, облегчающую крепление к несущей (опорной) конструкции. Мощность солнечных модулей может достигать 10...350 Вт. Электрические параметры таких модулей представляются в виде вольтамперной характеристики, снятой при стандартных условиях (Standard Test Condition — STC), то есть когда мощность солнечной радиации составляет 1000 Вт/м^2 , температура элементов — 25°C и солнечный спектр — на широте 45° .

Номинальная мощность модуля определяется как наибольшая мощность при STC. Значение напряжения, соответствующее максимальной мощности называется напряжением максимальной мощности V_{mp} (рабочим напряжением), а соответствующий ток — током максимальной мощности I_{mp} (рабочим током). Значение рабочего напряжения для модуля, состоящего из 36 элементов приблизительно равно 16... 17 В (0,45...0,47 В/элемент) при 25°C . Такой запас по напряжению необходим для того, чтобы компенсировать снижение рабочего напряжения при нагреве модуля (солнечным излучением) — температурный коэффициент напряжения холостого хода для кремния составляет $\sim -0,4\%/^\circ\text{C}$. Температурный коэффициент тока -положительный (0,07%/градус). Напряжение холостого хода модуля мало меняется при изменении освещенности (в то время как ток короткого замыкания прямо ей пропорционален). КПД солнечного модуля определяется как отношение максимальной мощности (модуля) к

общей мощности излучения, падающей на его поверхность при STC, и составляет 12...15%.

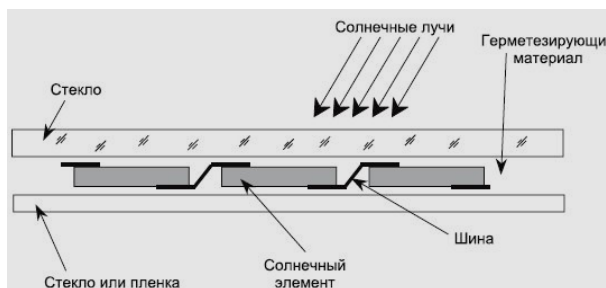


Рис.3- Разрез солнечного модуля

Для получения необходимой мощности и рабочего напряжения модули соединяют последовательно или параллельно. Таким образом получают фотоэлектрический генератор. Мощность такого генератора всегда меньше, чем сумма мощностей модулей — из-за потерь, обусловленных различием в характеристиках однотипных модулей (потери на рассогласование). Чем тщательнее подобраны модули в генераторе (или, чем меньше различие в характеристиках модулей), тем меньше потери на рассогласование. Например, при последовательном соединении десяти модулей с разбросом характеристик 10% потери составляют приблизительно 6%, а при разбросе 5% — уменьшаются до 2%.

При затенении одного модуля (или части элементов в модуле) в генераторе при последовательном соединении возникает «эффект горячего пятна» — затененный модуль (элемент) начинает рассеивать всю производимую освещенными модулями (элементами) мощность, быстро нагревается и выходит из строя. Для устранения этого эффекта параллельно с каждым модулем (или его частью) устанавливают шунтирующий диод. Диод необходим при последовательном соединении более двух модулей. К каждой линейке (последовательно соединенных модулей) тоже подключается блокирующий диод для выравнивания напряжений линеек. Все эти диоды обычно размещаются в соединительной коробке самого модуля. Схема генератора приведена на рис. 4. Модули устанавливаются на стальных или алюминиевых опорных конструкциях на земле (или на крышах и фасадах зданий) — и при этом служат одновременно кровельным или защитным материалом.

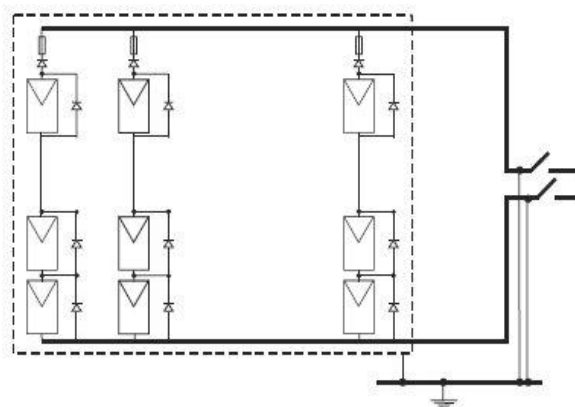


Рис. 4. Схема генератора фотоэлектрической системы

Регуляторы зарядки-разрядки (контроллеры). Стоимость регулятора заряда составляет не более 5% от стоимости всей системы (но от качества зарядных регуляторов зависит ее работа). Чтобы защитить батарею от избыточной разрядки, нагрузка должна быть отключена, когда напряжение батареи падает ниже напряжения отключения. Нагрузка не должна подключаться до момента, когда напряжение не возрастет до определенного порога (напряжения подключения).

В некоторых моделях регуляторов используется звуковой сигнал, который сообщает пользователю о скором отключении нагрузки. Может предусматриваться и ручное отключение контроля нагрузки. Чтобы защитить батарею от перезарядки необходимо ограничить зарядный ток по достижении напряжения окончания зарядки. Напряжение начнет снижаться, пока не достигнет другого порога, называемого напряжением возобновления заряда.

Некоторые производители включают в набор функций регулятора управляемую перезарядку для выравнивания напряжения на аккумуляторах в батарее. Перезарядку следует проводить при постоянном напряжении 2,5 В/элемент после каждой глубокой разрядки и/или каждые 14 дней длительностью 1...5 часов. Нет необходимости проводить управляемую перезарядку в малообслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных батареях.

Все вышеуказанные значения напряжений должны измеряться непосредственно на клеммах батареи, поэтому падение напряжения на соединительных проводах аккумуляторной батареи и регулятора не должно превышать 4% от номинального в самых неблагоприятных рабочих условиях (т.е. когда подключена максимальная нагрузка, а из солнечного генератора не поступает ток). Если это невозможно или дорого, то проводят отдельную сигнальную линию на регулятор.

Электрические нагрузки, требующие высокого значения начального тока (например, электродвигатели) могут приводить к кратковременному падению напряжения на батарее ниже напряжения отключения нагрузки (даже если батарея имеет достаточный заряд). Чтобы предотвратить эту ситуацию, необходимо отключать нагрузку на 3,...30 с после достижения порога напряжения отключения нагрузки. В регуляторах могут быть предусмотрены следующие виды защиты:

- от короткого замыкания в нагрузке;
- от подключения аккумуляторной батареи обратной полярностью;
- температурная компенсация значений пороговых напряжений (это бывает

необходимо, если предполагается эксплуатация батарей при температурах ниже минус 10°C).

Регуляторы имеют светодиодную или жидкокристаллическую индикацию режимов работы и изготавливаются, как правило, в отдельном пылевлагозащищенном корпусе. Класс защиты — от IP32 (защита от песка и дождевых брызг) до IP65 (пылевлагонепроницаемый). Все сказанное относится к регуляторам для автономных солнечных систем небольшой мощности (до 1кВт). В более мощных системах функции контроля зарядки и разрядки берет на себя системный контроллер (управляющий также всей системой). В большинстве случаев это устройство сопряжено с компьютером (осуществляющим к тому же непрерывный мониторинг за работой компонентов с запоминанием значений освещенности, температуры, тока и напряжения для последующего анализа).

Аккумуляторные батареи. Выработанную солнечными модулями энергию можно сохранять в разных формах:

- химическая энергия в электрохимических аккумуляторах;
- потенциальная энергия воды в резервуарах;
- тепловая энергия в тепловых аккумуляторах;
- кинетическая энергия вращающихся масс или сжатого воздуха в резервуарах.

Для фотоэлектрических систем больше подходят электрохимические аккумуляторы, так как солнечный модуль производит, а потребитель потребляет электроэнергию, которая непосредственно и запасается в аккумуляторе. Большинство фотоэлектрических систем используют свинцово-кислотные аккумуляторы. Основными условиями по выбору аккумуляторов являются:

- стойкость к циклическому режиму работы;
- способность выдерживать глубокий разряд;

- низкий саморазряд;
- нечувствительность к нарушению условий зарядки и разрядки;
- долговечность;
- простота в обслуживании.

Важный параметр переносных (или периодически демонтируемых) солнечных систем — компактность и герметичность. Этим требованиям в полной мере удовлетворяют аккумуляторы, выполненные по технологиям «dryfit» и AGM (абсорбированный электролит) или рекомбинационной технологии. Они характеризуются отсутствием эксплуатационных затрат и перекрывают диапазон емкостей 1...12 000 Ач. Выделяющиеся при зарядке газы не выходят из аккумулятора, поэтому электролит не расходуется и обслуживание не требуется. Например, серия аккумуляторов SMG фирмы FIAMM (Италия) объединяет преимущества рекомбинационной технологии и обычных открытых батарей с трубчатыми положительными пластинами. Аккумуляторы имеют:

- длительный срок службы -15 лет;
- стойкость к циклическому режиму — более 1200 циклов;
- отсутствие необходимости обслуживания на протяжении всего срока службы;
- минимальное газовыделение;
- отсутствие пуско-наладочных работ;
- саморазряд — приблизительно 3% в месяц.

Стоимость аккумуляторов и батарей такого типа составляет 150... 250 \$/кВтч. Поэтому, при необходимости можно использовать обычные стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Срок эксплуатации таких батарей в составе солнечной станции — не более 3...5 лет, поэтому за срок эксплуатации станции (15...20 лет и более) нужно будет заменять батареи (к этому добавятся затраты на обслуживание батарей и оборудование помещений). Если обслуживание проводит сам потребитель (а так бывает при использовании фотоэлектричества для электроснабжения отдельно стоящих удаленных жилых объектов — лесничества, дачные, сторожевые домики), то учитывая распространенность данного типа батарей, их применение в солнечных станциях оправдано. Для получения необходимого рабочего напряжения аккумуляторы или аккумуляторные батареи соединяют последовательно. При этом:

- применяют аккумуляторы только одного типа, выпущенные одним производителем;
- используют все аккумуляторы одновременно, не делая отводов от отдельных частей;
- не соединяют аккумуляторы в одну группу с разницей в дате выпуска более чем на месяц;
- обеспечивают разницу температур отдельных аккумуляторов не более 3°C.

Для продления срока службы аккумуляторов при циклическом режиме работы в солнечных системах важно не допускать и глубокого разряда. Степень разряда характеризуется глубиной разряда (DOD), выражаемую в процентах от номинальной емкости аккумулятора.

Эксплуатация аккумуляторов при глубоком разряде приводит к необходимости их более частой замены и обслуживания — и, соответственно, к удорожанию системы. Глубину разряда аккумуляторов в солнечных системах стремятся ограничить на уровне 30...40%, что достигается отключением нагрузки (снижением мощности) или использованием аккумуляторов большей емкости. Поэтому, для управления процессом зарядки и выбора оптимального режима в состав солнечной электрической станции обязательно включают контроллеры зарядки разрядки аккумуляторной батареи.

Регуляторы зарядки-разрядки (контроллеры). Стоимость регулятора заряда составляет не более 5% от стоимости всей системы (но от качества зарядных регуляторов зависит ее работа). Чтобы защитить батарею от избыточной разрядки, нагрузка должна быть отключена, когда напряжение батареи падает ниже напряжения отключения.

Нагрузка не должна подключаться до момента, когда напряжение не возрастет до определенного порога (напряжения подключения).

В некоторых моделях регуляторов используется звуковой сигнал, который сообщает пользователю о скором отключении нагрузки. Может предусматриваться и ручное отключение контроля нагрузки. Чтобы защитить батарею от перезарядки необходимо ограничить зарядный ток по достижении напряжения окончания зарядки. Напряжение начнет снижаться, пока не достигнет другого порога, называемого напряжением возобновления заряда.

На практике выбор напряжения окончания и возобновления заряда -компромисс между обеспечением полного заряда (и усиленного испарения электролита при высоких напряжениях) и недозаряда (предотвращением коррозии электродов и потребления воды — низкие напряжения). Небольшие системы имеют тенденцию к перепотреблению энергии (а не к перезарядке) поэтому допускается перезарядка (высокое потребление воды) и следует использовать более высокое напряжение окончания заряда.

Некоторые производители включают в набор функций регулятора управляемую перезарядку для выравнивания напряжения на аккумуляторах в батарее. Перезарядку следует проводить при постоянном напряжении 2,5 В/элемент после каждой глубокой разрядки и/или каждые 14 дней длительностью 1...5 часов. Нет необходимости проводить управляемую перезарядку в малообслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных батареях.

Все вышеуказанные значения напряжений должны измеряться непосредственно на клеммах батареи, поэтому падение напряжения на соединительных проводах аккумуляторной батареи и регулятора не должно превышать 4% от номинального в самых неблагоприятных рабочих условиях (т.е. когда подключена максимальная нагрузка, а из солнечного генератора не поступает ток). Если это невозможно или дорого, то проводят отдельную сигнальную линию на регулятор.

Электрические нагрузки, требующие высокого значения начального тока (например, электродвигатели) могут приводить к кратковременному падению напряжения на батарее ниже напряжения отключения нагрузки (даже если батарея имеет достаточный заряд). Чтобы предотвратить эту ситуацию, необходимо отключать нагрузку на 3,...30 с после достижения порога напряжения отключения нагрузки. В регуляторах могут быть предусмотрены следующие виды защиты:

- от короткого замыкания в нагрузке;
- от подключения аккумуляторной батареи обратной полярностью;
- температурная компенсация значений пороговых напряжений (это бывает необходимо, если предполагается эксплуатация батарей при температурах ниже минус 10°C).

Регуляторы имеют светодиодную или жидкокристаллическую индикацию режимов работы и изготавливаются, как правило, в отдельном пылевлагозащищенном корпусе. Класс защиты — от IP32 (защита от песка и дождевых брызг) до IP65 (пылевлагонепроницаемый). Все сказанное относится к регуляторам для автономных солнечных систем небольшой мощности (до 1кВт). В более мощных системах функции контроля зарядки и разрядки берет на себя системный контроллер (управляющий также всей системой). В большинстве случаев это устройство сопряжено с компьютером (осуществляющим к тому же непрерывный мониторинг за работой компонентов с запоминанием значений освещенности, температуры, тока и напряжения для последующего анализа).

Инверторы. Солнечная батарея может вырабатывать только постоянный ток. Однако, существует много потребителей, использующих именно постоянный ток (зарядка аккумуляторов, освещение, радиоаппаратура и др.). Для преобразования постоянного тока аккумуляторной батареи в переменный синусоидальной формы необходим инвертор.

Инверторы — полупроводниковые приборы. Они могут быть разделены на два типа в соответствии с типом фотоэлектрических систем: 1) инверторы для автономных систем и 2) инверторы для сетевого применения. Выходной каскад у обоих типов во многом похож, а главное отличие — в схеме управления. Первый тип имеет генератор частоты, а второй должен работать синхронно с промышленной сетью (и в качестве генератора частоты использует саму сеть). Для всех типов основной параметр — КПД (который должен быть более 90%).

Выходное напряжение автономных инверторов в большинстве случаев составляет 220 В (50/60 Гц), а в инверторах мощностью 10...100 кВт можно получать трехфазное напряжение 380 В. Все автономные инверторы преобразуют постоянный ток аккумуляторных батарей, поэтому входное напряжение выбирается из ряда 12, 24, 48 и 120 В. Чем больше входное напряжение, тем проще инвертор и тем больше его КПД. При больших напряжениях значительно меньше потери на передачу энергии от солнечного генератора к аккумуляторной батарее, регулятору зарядки и инвертору, но при этом усложняется конструкция солнечного генератора и его эксплуатация при опасных напряжениях (выше 40 В).

К форме выходного сигнала автономных инверторов предъявляются менее жесткие требования. В ряде случаев, если позволяет нагрузка, возможно применение инверторов с трапецевидным выходным сигналом. Такие инверторы стоят в 2...3 раза дешевле инверторов с синусоидальным выходным сигналом. Важный параметр автономных инверторов — зависимость КПД от мощности подключенной нагрузки. КПД не должен заметно снижаться при подключении нагрузки в десять раз меньшей (по потребляемой мощности), чем номинальная мощность инвертора. В то же время инвертор должен выдерживать перегрузки в выходных цепях (при подключении электродвигателей или других динамичных нагрузок). В идеальном случае к автономному инвертору предъявляются следующие требования:

- способность выдерживать перегрузки (как кратковременные, так и длительные);
- низкие потери при малых нагрузках и на холостом ходу;
- стабилизация выходного напряжения;
- низкий коэффициент гармоник;
- высокий КПД;
- отсутствие помех на радиочастотах.

Промышленность производит широкий ассортимент инверторов, специально разработанных для фотоэлектрических систем. Такие инверторы включают блок регулятора отбора максимальной мощности, блок регулятора заряда, а также дополнительный вход подключения дизель-генератора (для экстренной подзарядки батареи).

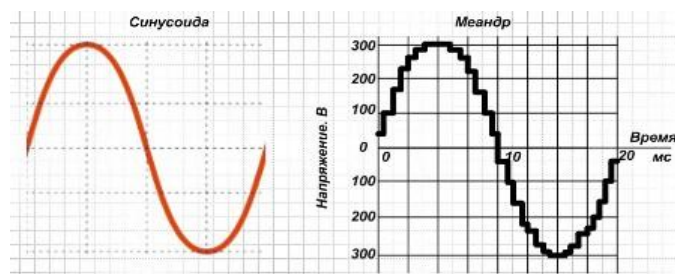


Рис.5 – Форма выходного напряжения сетевого инвертора (синусоида)

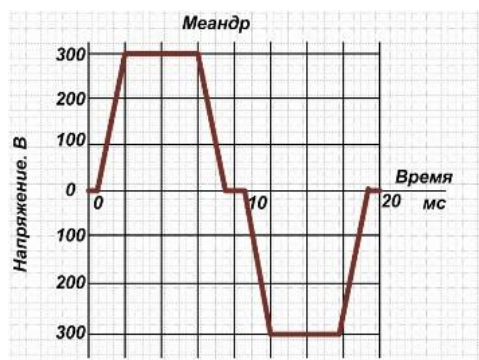


Рис.6 – Форма выходного напряжения автономного инвертора (трапеция)

2. Ознакомиться с устройством и работой автономной ФЭС , имеющей в своём составе двухсторонний солнечный модуль MSW- 80/40.

Контрольные вопросы

1. Что такое солнечный фотопреобразователь, солнечный модуль, солнечная батарея и фотоэлектрическая система (ФЭС) ?
2. Что такое автономная фотоэлектрическая система (фотоэлектростанция) ?
3. Основные компоненты автономной ФЭС и их функциональное назначение ?
4. Принцип работы автономной ФЭС.
5. Форма выходного сигнала сетевого инвертора.
6. Чему равна стандартная энергетическая освещённость ?
7. Что называют номинальной мощностью и к.п.д. солнечного модуля?

Часть 2. «Расчёт автономной фотоэлектрической системы (электростанции)»

1.7.1 Цель работы: освоить методику расчёта автономной фотоэлектрической системы (электростанции)

1.7.2 Задачи работы:

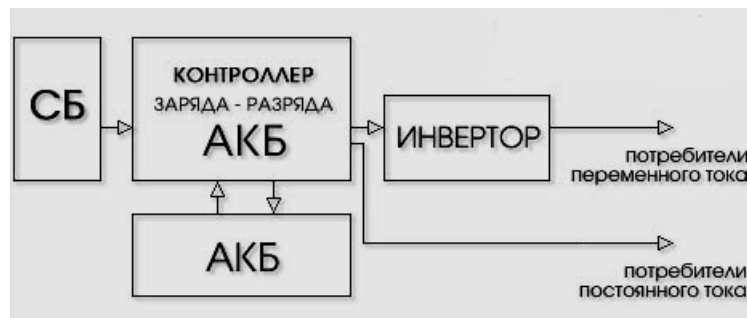
1. Изучить методику расчёта автономной фотоэлектрической системы (электростанции).
2. Выполнить расчёт автономной ФЭС для предложенного набора нагрузок переменного тока.

1.7.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Мультимедийный проектор;
2. Компьютер;

1.7.4 Описание (ход) работы:

Автономные ФЭС – это солнечные фотоэлектрические системы (электростанции), предназначенные для электропитания передвижных или удаленных объектов, лишенных возможности подвода линии электропередач. Причина может заключаться в нецелесообразности или невозможности подвода электрической линии.



Принцип работы ФЭС заключается в следующем: солнечная батарея в светлое время суток ведет заряд аккумуляторных батарей АКБ. Контроллер заряда-разряда обеспечивает правильный режим заряда и разряда АКБ. При этом солнечная батарея при необходимости ведет питание дневных нагрузок. Нагрузки, работающие в темное время суток, питаются исключительно от АКБ. Нагрузки переменного тока запитываются через инвертор.

Для надёжной работы, подключаемых к ФЭС устройств (нагрузки), необходим правильный подбор компонентов фотоэлектрической системы, основанный на предварительном расчёте. Под расчётом ФЭС понимается определение номинальной мощности солнечных модулей, их количества, схемы соединения, выбор типа, ёмкости и условий эксплуатации АКБ, мощности инвертора и контроллера заряда – разряда, определение параметров соединительных кабелей.

Расчет фотоэлектрической системы состоит из нескольких этапов:

1. Вначале необходимо составить перечень всех нагрузок. Это удобно делать при помощи таблицы. Кроме названий подключаемых устройств в столбцах таблицы следует указать мощность каждого устройства, его среднесуточное время работы и количество однотипных приборов.

Электроэнергия, получаемая с помощью ФЭС, дорогая и нужно отказаться от лишних или мощных приборов, которые целесообразней питать от генератора. Имеет смысл использовать нагрузки постоянного тока. Это позволит не приобретать инвертор и экономить энергию, поскольку к.п.д. инвертора обычно 85-95%.

2. Расчет суточного энергопотребления W_c (в кВт · час). Для этого надо для каждого типа нагрузки перемножить её мощность, количество приборов и среднесуточное время работы. Полученные результаты сложить, что и даст энергию, потребляемую в течение суток. Для круглосуточно работающих приборов нужно найти в паспорте изделия его суточное потребление.

Например, нагрузочные устройства ФЭС следующие:

1. Телевизор мощностью 30 Вт, работает 4 часа в сутки;
2. Осветительные лампы – 3 шт., по 15 Вт, работают 6 часов в сутки;
3. Холодильник с энергопотреблением 600 Вт·ч/сутки.

Итого получаем: $W_c = 30 \text{ Вт} \cdot 4 \text{ ч} + 15 \text{ Вт} \cdot 3 \cdot 6 \text{ ч} + 600 \text{ Вт} \cdot \text{ч} = 990 \text{ Вт} \cdot \text{ч}$. За месяц энергопотребление примерно равно $W = 990 \cdot 30 \text{ Вт} \cdot \text{ч} = 30 \text{ кВт} \cdot \text{час}$.

Для нагрузок, использующих переменный ток, расчет нужно вести отдельно и закладывать в их потребление запас 5 % - 15% (в сторону увеличения) для учета к.п.д. инвертора, то есть его энергопотребления. При питании от инвертора (переменный ток) можно грубо учесть потери в нём, умножив энергопотребление W на коэффициент $K_{\text{и}} = 1,2$.

В примере для приведенных устройств переменного тока:

суточное энергопотребление $W_c = 1,2 \cdot 990 \text{ Вт} \cdot \text{ч} = 1200 \text{ Вт} \cdot \text{ч}$; (округлено)

месячное энергопотребление $W = 1,2 \cdot 990 \cdot 30 \text{ Вт} \cdot \text{ч} = 36 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$. (округлено)

3. Определение емкости аккумуляторной батареи АКБ

1. Нужно выбрать номинальное напряжение аккумуляторной батареи;
2. Оценить количество пасмурных (несолнечных) дней подряд, в течение которых АКБ должна работать без заряда от солнечной батареи, а также достигаемую при этом глубину разряда.

Обычно для автономных систем глубина разряда выбирается не более 30-50% . Это позволяет продлить срок службы АКБ.

3. Цифра суточного энергопотребления W_c л умножается на количество пасмурных дней и полученная величина должна составлять глубину разряда АКБ от её полной энергии.

Как известно, емкость АКБ в значительной степени зависит от температуры помещения. Процесс этот обратимый, то есть при повышении температуры до нормальной емкость восстанавливается. Однако, работа аккумуляторов при высоких температурах вредна для них. При низких температурах емкость АКБ снижается и поправку на это снижение необходимо закладывать при расчете системы.

Окончательная емкость АКБ получается умножением расчетной энергии, заключенной в ней, на коэффициент k (поправку на температуру АКБ) из приведенной таблицы и последующим делением на напряжение АКБ.

Полученную величину округляют в большую сторону к стандартным емкостям аккумуляторных батарей. Параллельно-последовательное соединение позволяет набрать нужную электроёмкость АКБ.

Таблица 1

T, °C	25	20	15	10	5	0	- 5
K	1,00	1,03	1,10	1,2	1,28	1,36	1,50

В примере берутся следующие данные:

напряжение аккумуляторной батареи $U_{АКБ} = 12 \text{ В}$;

глубина разряда батареи $k_{гр} = 0,5 \text{ (50 \%)} ;$

количество пасмурных дней $n = 2 \text{ дня}$

температура аккумуляторной батареи $t_{АКБ} = 25^\circ\text{C}$

поправка на температуру АКБ $k = 1$

суточное энергопотребление $W_c = 1200 \text{ Вт}\cdot\text{ч}$

Ёмкость АКБ определяем, как было указано выше:

$$C = W_c \cdot n \cdot k / k_{гр} \cdot U_{АКБ} = 1200 \cdot 2 \cdot 1 / 0,5 \cdot 12 = 2400 / 6 = 400 \text{ А}\cdot\text{ч}$$

4. Мощность инвертора должна быть на 25-30% выше суммарной номинальной мощности одномоментно подключаемых нагрузок.

Кроме того, его пиковая мощность должна быть больше суммарной пиковой мощности нагрузок, которые могут запуститься одновременно. Это связано с тем, что некоторые приборы имеют значительную пусковую мощность при включении. Например, холодильник, насос или иная нагрузка с двигателем. Пусковая мощность таких устройств может в 3 – 7 раз (в течение нескольких секунд) превышать номинальную, рабочую.

В примере. Рассчитаем суммарную пиковую мощность нагрузок. Холодильник при включении потребляет мощность, превышающую рабочую не менее, чем в три раза. Полагаем, что мощность холодильника (компрессорного) в примере равна 200 Вт. Пусковую мощность получаем, умножая рабочую мощность на 3. Получаем 600 Вт. Кроме того, полагаем, что в моменты включения холодильника все остальные нагрузки тоже работают. Это составляет почти 400 Вт. Таким образом, суммарная пиковая мощность составляет 1000 Вт.

Поэтому мощность инвертора должна быть не менее $P_{и} = 1,3 \cdot 1000 = 1300 \text{ Вт}$.

5. Определение суммарной мощности модулей солнечной батареи.

Для расчета потребуется значение солнечной инсоляции, которое берется за период работы станции (ФЭС), когда солнечная радиация минимальна.

При определении этой величины нужно учесть несколько факторов:

- географическое месторасположение объекта;
- период эксплуатации: лето, зима, круглый год;
- режим эксплуатации: выходные, ежедневно, иная схема;
- наличие деталей рельефа или пейзажа, которые могли бы загораживать поток солнечного света к поверхности солнечных батарей в течение дня;
- возможность применения подвижной платформы, следящей за положением солнца.

Чтобы система ФЭС вырабатывала нужное количество энергии за весь период эксплуатации, необходимо вести расчет для условий наихудшей инсоляции. При круглогодичном использовании ФЭС таким месяцем является декабрь. В это время года максимально низкая инсоляция, очень короткий световой день и низкая облачность в большинстве регионов России.

Оптимальный угол наклона ϑ солнечных панелей к горизонту разный в разных регионах страны. Этот угол увеличивается в высоких (более северных) широтах из-за низкого положения Солнца над горизонтом.

Существует простая методика выбора угла наклона ϑ солнечных модулей при ориентации их на юг:

- чтобы получить максимум энергии летом нужно солнечные панели (модули) разместить под углом на 15° меньше географической широты местности;
- чтобы получить максимум энергии в зимнее время года нужно панели наклонить к горизонту под углом на 15° больше географической широты местности;
- чтобы получить максимум энергии за весь год угол наклона солнечных батарей должен быть равен широте местности;
- выбрав угол наклона солнечных модулей, необходимо найти в таблицах солнечной инсоляции её значение для данного региона, времени года и угла наклона принимающей поверхности.

Данные о инсоляции (месячные и суммарные годовые значения) для основных районов России можно найти в справочной литературе по метеорологии и в Интернете.

К примеру для Краснодара (географическая широта – 45°) в июле и для угла наклона солнечных модулей $\vartheta = 30^\circ$ инсоляция составляет примерно $180 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2$.

Это означает, что в июле в Краснодаре поступление солнечной радиации составляет 180 пикочасов.

Пикочасом называется условный промежуток времени в течении, которой интенсивность солнечной радиации (энергетическая освещённость горизонтальной поверхности) равна $1000 \text{ Вт}/\text{м}^2$. Именно такая освещенность используется для паспортизации солнечных модулей.

Таким образом, в Краснодаре в июле в день имеем 6 пикочасов, то есть в течение 6 часов Солнце как бы создаёт энергетическую освещённость $1000 \text{ Вт}/\text{м}^2$, при которой солнечный модуль или батарея выдают максимальную электрическую мощность.

На самом деле световой день, конечно, больше чем 6 часов. Однако в течение дня энергетическая освещённость батарей разная, достигая максимума при положении Солнца в зените. Помимо инсоляции в расчете следует учитывать сильный нагрев модуля в летнее время, что снижает его эффективность. **Это учитывается введением сезонного коэффициента k_c**

Упрощенная формула для расчета необходимой мощности массива солнечных модулей и количества модулей. Определяется по количеству пикочасов, исходя из того, что суммарная мощность всех солнечных модулей, образующих батарею, равна энергии,

необходимой для потребления за определённый выбранный период времени с учётом различных потерь и условий эксплуатации.

Один модуль мощностью P вырабатывает в течение выбранного периода времени (месяц, сезон, год) следующее количество энергии W_m :

$$W_m = k_c \cdot P \cdot E / 1000$$

Здесь, k_c - сезонный коэффициент, равный летом 0,55, а зимой 0,7 ;

E - значение солнечной инсоляции за выбранный период времени, Вт·ч/м² ;

1000 Вт/м² – стандартная энергетическая освещённость ;

$t = E / 1000$ - количество пикочасов в течение выбранного периода.

Количество энергии W , необходимой для потребления за этот период равно:

$$W = W_c \cdot \text{количество дней} = N \cdot W_m = N \cdot k_c \cdot P \cdot E / 1000 \quad (1)$$

Суммарная мощность модулей или мощность солнечной батареи равна

$$P_{CB} = N \cdot P = W \cdot 1000 / k_c \cdot E \quad (2)$$

Отсюда определяем количество солнечных модулей N , необходимых для получения этой энергии:

$$N = W \cdot 1000 / k_c \cdot P \cdot E \quad (3)$$

Здесь,

W_c - суточное энергопотребление, Вт·ч/сутки ;

$W = W_c \cdot \text{количество дней}$ - электроэнергия, необходимая для потребления;

W_m - энергия, вырабатываемая одним модулем в течение выбранного периода, Вт·ч;

P - мощность одного модуля, соответствующая освещённости 1000 Вт/м² ;

N - количество модулей, образующих батарею.

Коэффициент k_c учитывает все потери (нагрев батареи под солнцем, учитывает наклонное падение света в течение дня, потери на заряд АКБ), за исключением потерь в соединительных кабелях. Сечение кабелей обычно подбирается из расчета потерь не превышающих 2-3%.

6. Определение суммарной мощности и количества солнечных модулей для приведенного примера для летнего периода Оренбурга

Предполагается, что солнечные модули ориентированы в пространстве оптимально и ничто их не загораживает в течении светового дня. Однако, системы слежения за положением Солнца нет.

- Географическая широта Оренбурга - примерно 52° с.ш. ;
- Оптимальный угол наклона модулей для летнего периода $\theta = 52^\circ - 15^\circ = 37^\circ$
- Солнечная инсоляция в летние месяцы в Оренбурге условно равна $E = 180$ кВт·ч/м² за один летний месяц (июнь, июль, август) ;
- Месячное энергопотребление, рассчитанное в пункте 2, $W = 36$ кВт·час ;
- Сезонный коэффициент $k_c = 0,55$;
- По формуле (2) вычисляем суммарную мощность солнечных модулей

$$P_{CB} = W \cdot 1000 / k_c \cdot E = 36 \cdot 10^3 \cdot 10^3 / 0,55 \cdot 180 \cdot 10^3 = 364,6 \text{ Вт}$$

- Выберем из таблицы 2 подходящий по параметрам тип модуля ; Например, для приведенных условий подходит модуль МСК – 95.

- Путём деления суммарной мощности P_{CB} на мощность одного модуля 95 Вт, определяем количество модулей $N = 4$. Суммарная мощность 4-х модулей МСК – 95 равна 380 Вт, что немного больше расчётной.

Выполнение заданий

Задание 1. Ознакомиться с методикой расчёта автономной ФЭС.

Задание 2. Осуществить расчёт автономной ФЭС для предложенного набора нагрузок переменного тока согласно описанной методике:

1. Составить перечень нагрузок ;
2. Расчёт суточного и месячного энергопотребления ;
3. Определение ёмкости аккумуляторной батареи ;
4. Оценить мощность инвертора ;
5. Определить мощность солнечной батареи и количество модулей.

Считать условия эксплуатации, угол наклона модулей оптимальными. Сезон эксплуатации – летний. Значение месячной инсоляции, напряжение аккумуляторной батареи $U_{АКБ}$, количество пасмурных дне (подряд) $n = 2$ определяются номером задания. При подборе модулей использовать таблицу 2.

Стандартные солнечные кремниевые модули

Таблица 2 Каркасные солнечные модули серии МСК

Модель	Размер, мм	Uн, В	Uхх, В	Iкз, А	Uр, В	Iр, А	Wр, Вт	Вес, кг
МСК-15	285*425*28	12	21,8	0,92	17	0,86-0,88	15	1,9
МСК-20	425*425*28	12	21,8	1,30	17	1,05-1,20	20	2,7
МСК-24	425*555*28	12	21,8	1,75	17	1,40-1,65	24	3,4
МСК-30	425*555*28	12	21,8	1,80	17	1,65-1,75	30	3,4
МСК-40	535*615*28	12	21,8	2,75	18	2,35-2,50	40	4,0
МСК-60	550*810*28	12	21,8	3,55	18	3,25-3,35	60	5,5
МСК-95	500*1185*28	12	21,8	5,58	18	5,00-5,27	95	7,2
МСК-120	705*1315*38	12	21,8	7,25	18	7,00-7,20	120	10
МСК-140	667*1467*38	12	21,8	8,25	18	7,78-8,05	140	12
МСК-185	805*1575*38	12	21,8	10,99	18	10,00-10,26	185	17
МСК-185	805*1575*38	24	43,6	5,59	36	5,00-5,13	185	17

В таблице 2 - U_p , I_p , W_p - рабочие напряжение, ток и мощность модуля.

Контрольные вопросы

1. Что такое солнечный фотопреобразователь, солнечный модуль, солнечная батарея и фотоэлектрическая система (ФЭС) ?
2. Что такое автономная фотоэлектрическая система ?
3. Основные компоненты ФЭС и их функциональное назначение ?
4. Что называется солнечной инсоляцией ?
5. Что называют 1 кВт · ч (киловаттчас) ? Чему равна эта величина в единицах системы СИ ?
6. Чему равна стандартная энергетическая освещённость ?
7. Что называется пикочасом ?
8. Как определить мощность солнечной батареи и количество её модулей ?
9. Методика расчёта автономной ФЭС.
10. Как определить энергию, вырабатываемую солнечным модулем за летний период ?